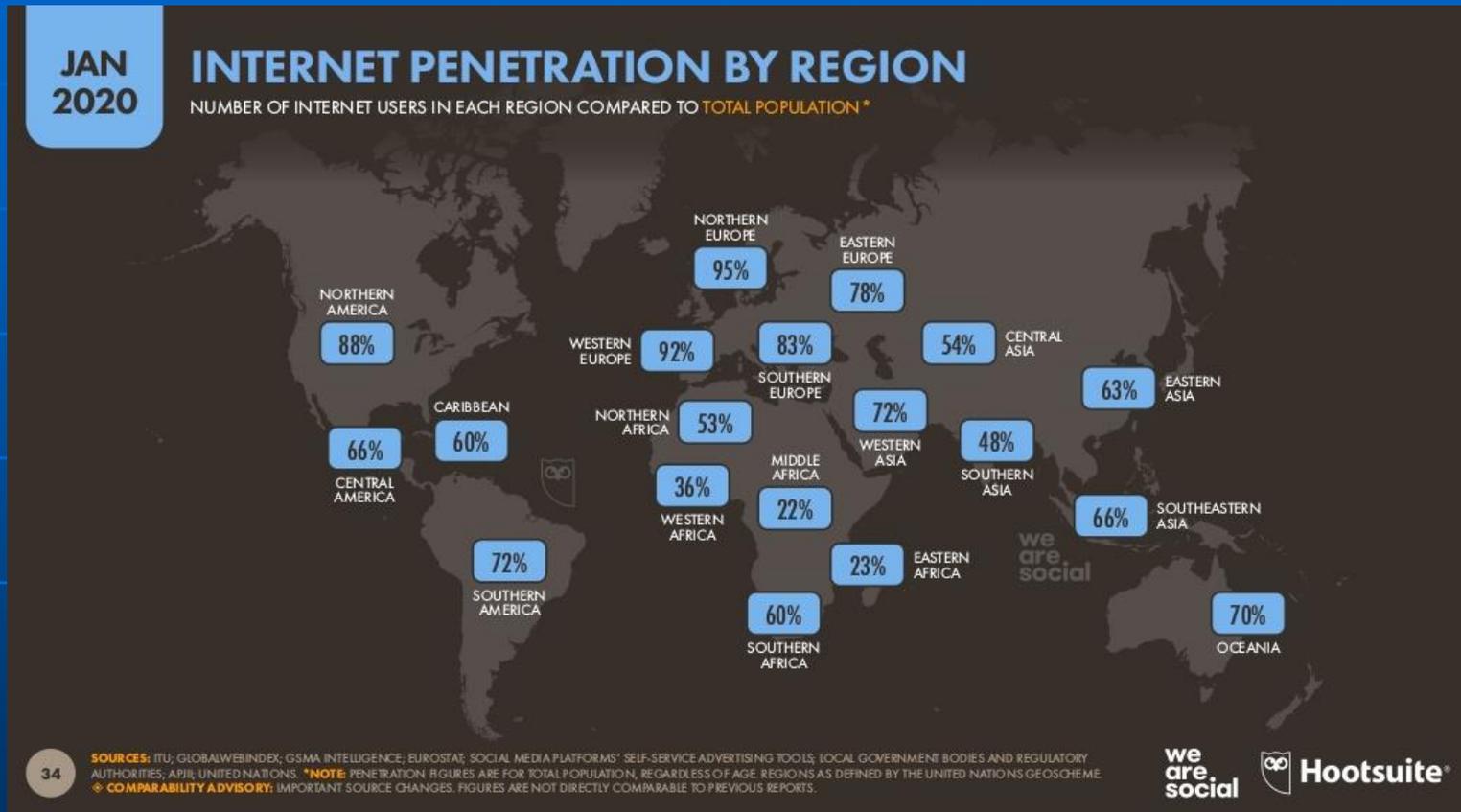


# Familias Lógicas

Introducción a los Sistemas  
Lógicos y Digitales  
2020

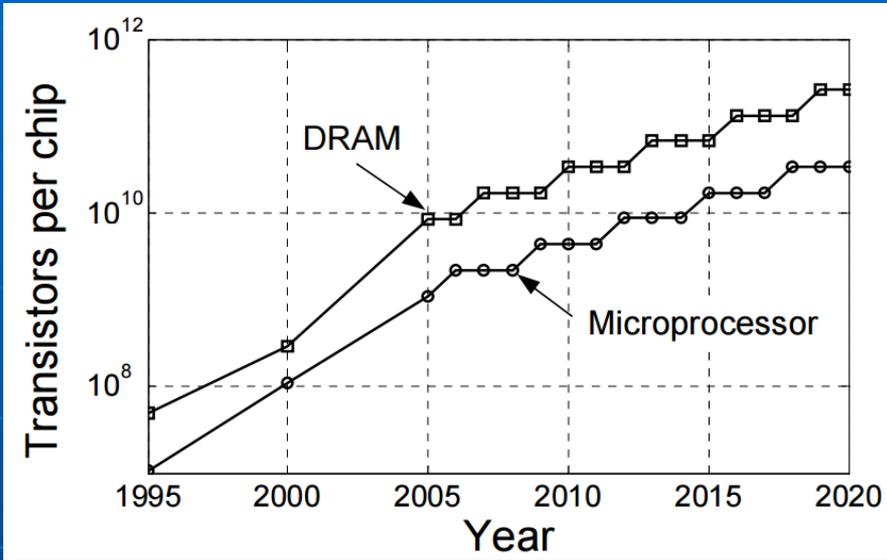
Sergio Noriega

# Crecimiento del tráfico global del protocolo de internet



Necesidad de tecnologías que brinden mayor velocidad, portabilidad, menor consumo y mayor densidad de integración.

# Evolución de la densidad de integración

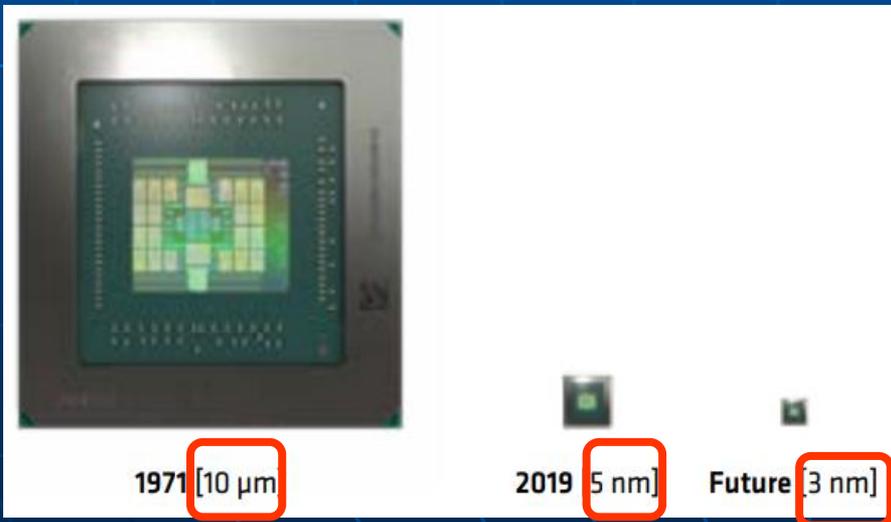


La ley de Moore establece que se duplica por año la cantidad de transistores (Trs) por chip. Hasta el 2017 el estado del arte generaba transistores de 10 nm de longitud de canal, lo que permitía albergar en un chip a 4.000 millones de ellos.

Hoy se ha superado la barrera de los 7 nm. La FPGA Stratix 10 (2019) de Intel tiene tecnología de 14 nm y emplea 43.000 millones de Trs.

AMD (2019) lanzó un micro de tecnología de 7nm y 12 nm con casi 40.000 millones de Trs.

INTEL (Q4-2019) lo hizo con tecnología de 10 nm.



Tamaño comparativo de un mismo diseño pero con diferente tamaño de transistor.

# Familias Lógicas

Las Familias Lógicas son tecnologías que permiten implementar las funciones tanto lógicas como matemáticas en el sistema binario.

## CLASIFICACIÓN:

Dependiendo de la tecnología empleada:

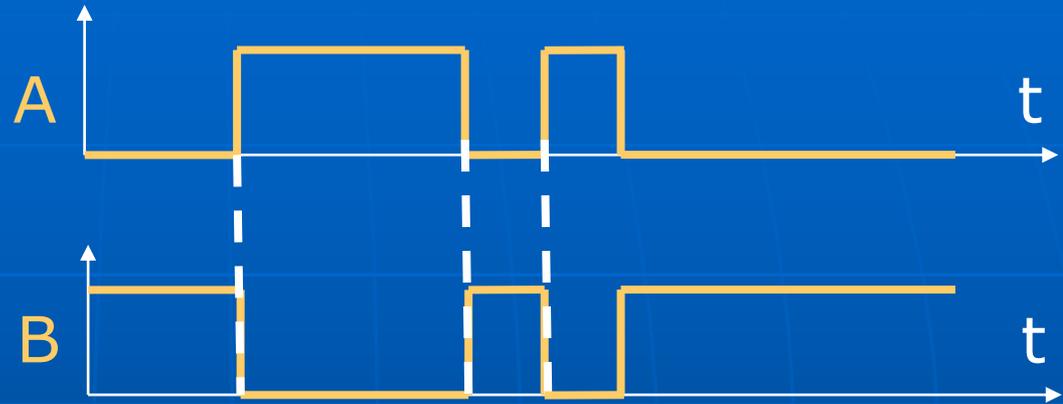
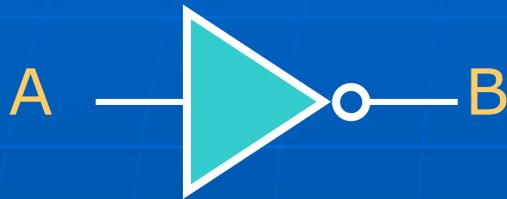


BIPOLAR	Lógica TTL (Transistor-Transistor Logic). Lógica ECL (Emitter-Coupled Logic).
MOS	Lógica CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). LVDS (Low Voltage Differential Signaling).
BIPOLAR-MOS	Lógica BiCMOS. CML (Current Mode Logic).
OTRAS	Lógica GaAs (Galio-Arsénico), etc.. Lógica eléctrica (relays, llaves, etc.). Lógica neumática. Lógica óptica...ETC...

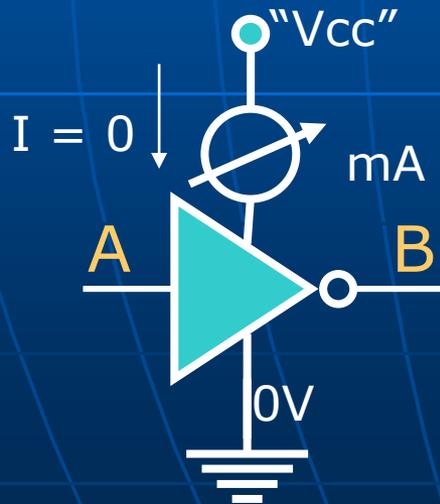


NOTA: Aquí, se tratarán los primeros 3 grupos.

Velocidad de respuesta infinita (retardos nulos)

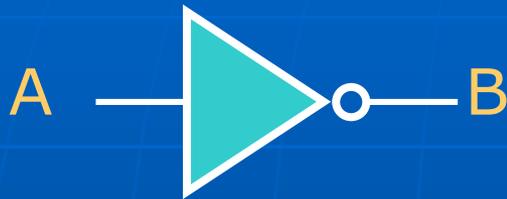


Consumo de energía nulo



Esto requiere que el dispositivo no consuma corriente de la fuente de alimentación. Además impone otra condición y es que si hay una carga conectada a la salida del mismo la misma debe ser infinita para no "pedirle" corriente al circuito.

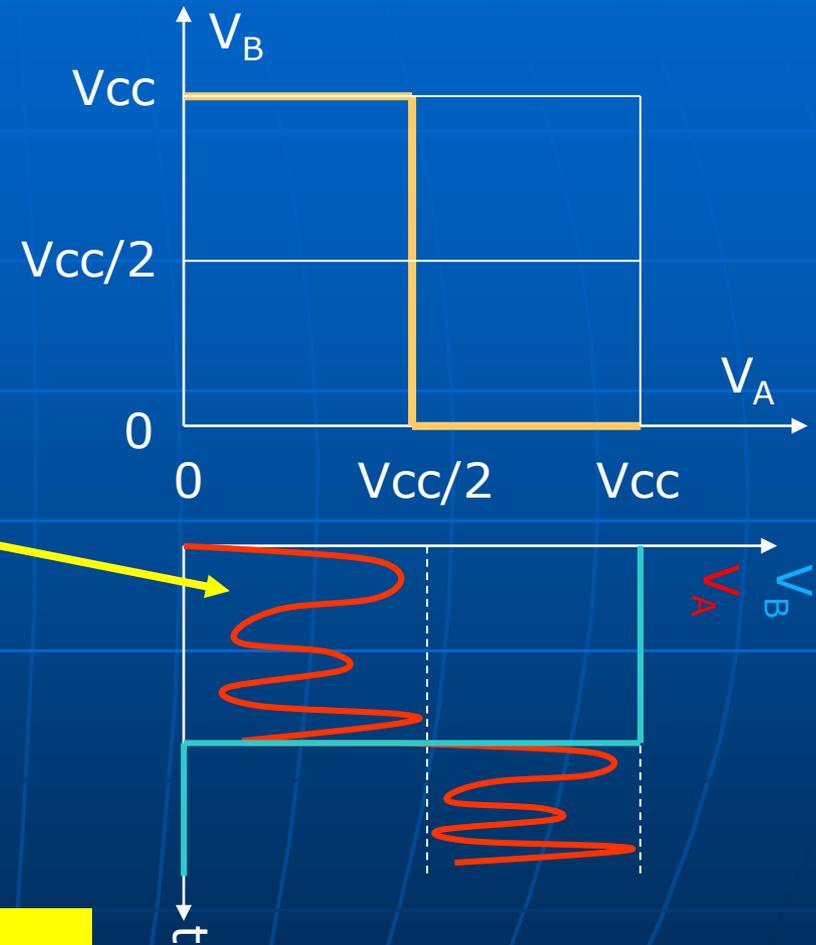
Inmunidad al ruido del 50% de la tensión de alimentación



Mientras la señal de entrada no supere los  $V_{cc}/2$  Volts el inversor sigue reconociendo el "0" a su entrada.

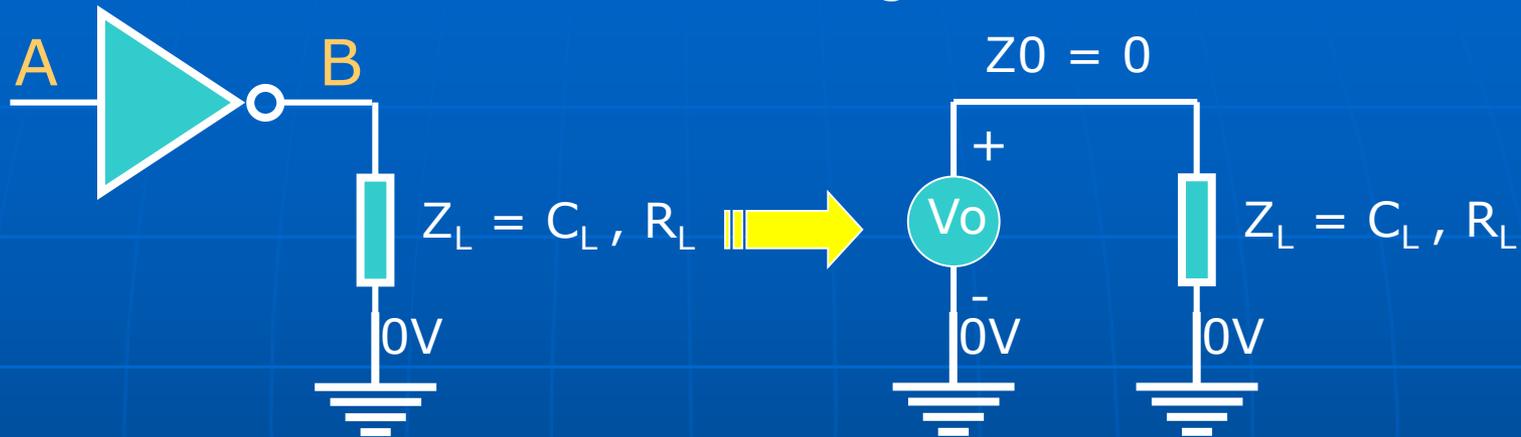
Lo mismo sucede para el "1". De esta manera se tiene un "Márgen de ruido" de  $V_{cc}/2$  ó 50% para cada nivel lógico. Es el márgen máximo que se puede obtener.

NOTA: Aquí no se considera el concepto de Schmitt Trigger que se planteará luego.



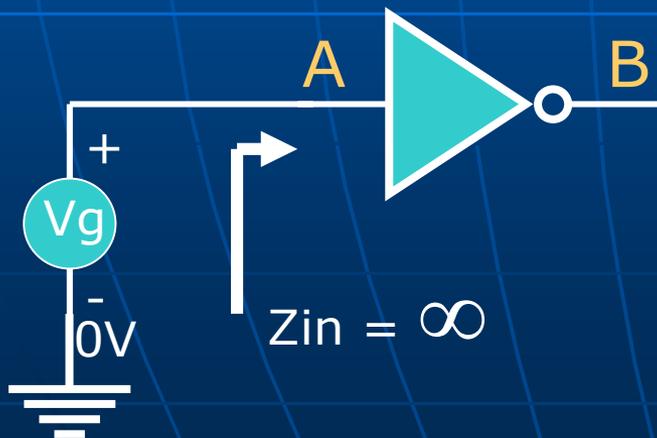
Capacidad de carga infinita:

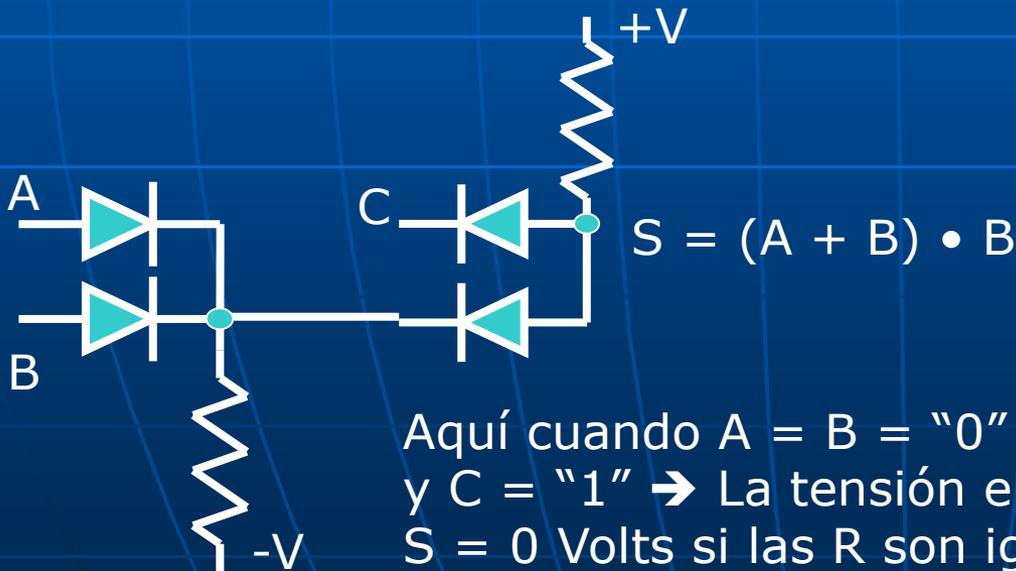
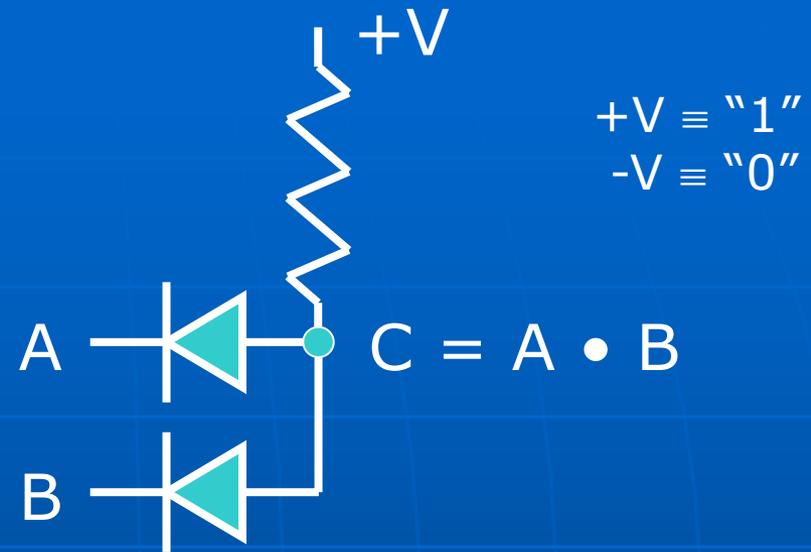
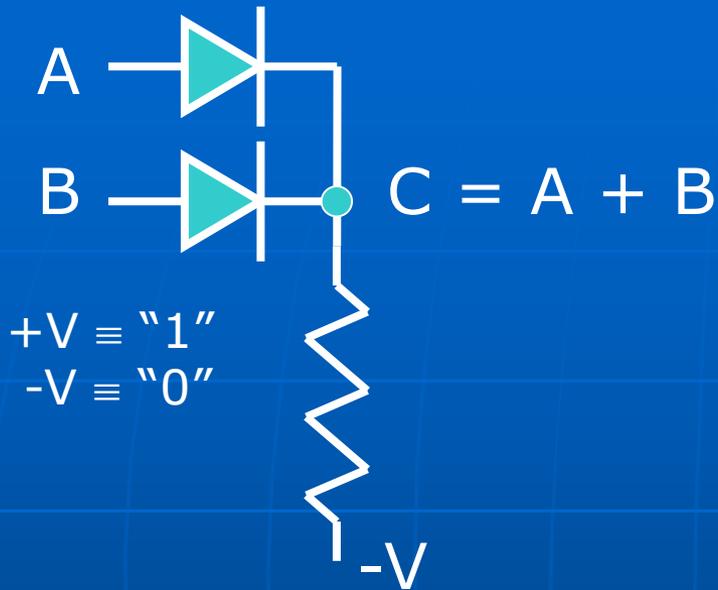
La tensión de salida no varía con la carga.



Impedancia de entrada infinita:

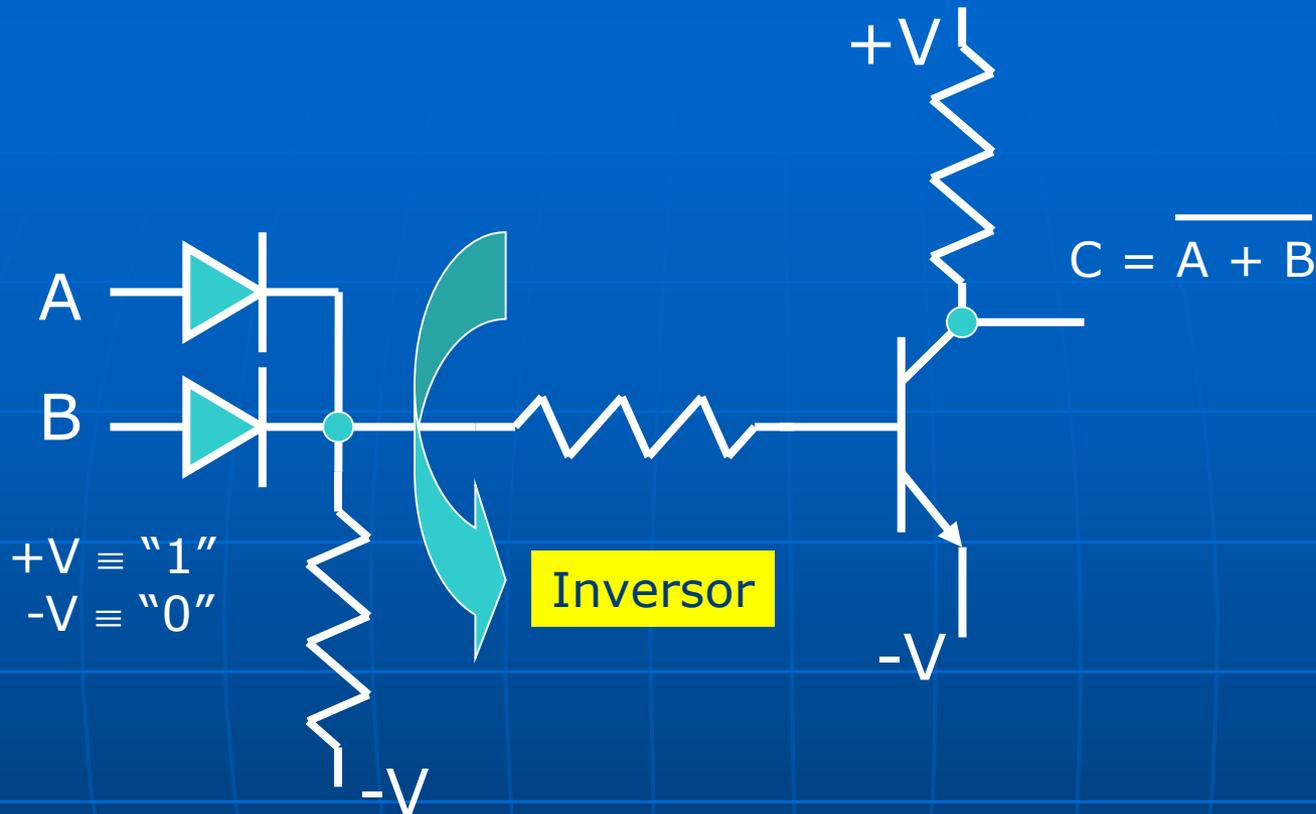
La impedancia de entrada al ser infinita no consume corriente de la fuente a la cual esté conectada.





Aquí cuando  $A = B = "0"$   
y  $C = "1"$   $\rightarrow$  La tensión en  
 $S = 0$  Volts si las R son iguales.

Esta lógica no permite cascadas de compuertas ni puede resolver negaciones. Necesita fuente partida (+V y -V)



Esta lógica permite realizar negaciones → implementa cualquier función. Como hay ganancia de tensión permite cascada de compuertas. Problemas serios por tener un margen de ruido pequeño y retardos elevados. Además requiere fuente partida.

**PRÓXIMO PASO → LÓGICA TRANSISTOR-TRANSISTOR (TTL)**

## Lógica TTL

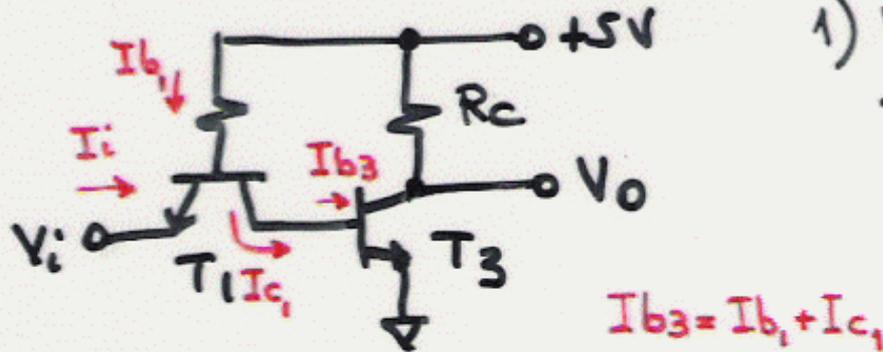
### Evolución

**serie 74, serie 74L, serie 74S (Schottky),  
serie 74LS (Schottky de bajo consumo),  
serie 74ALS, 74F,  
versiones de baja tensión de alimentación.**

La lógica TTL (Transistor Transistor Logic) se instauró en la década del 70 como la más competitiva respecto a CMOS y ECL dado que presentaba la mejor relación velocidad-consumo. La primera versión fué la denominada 74, 74L y 74S (por utilizar transistores Schottky). La última versión fué la serie 74LS que generó 3 subfamilias: 74LS, 74ALS y 74F.

Si bien aparecieron versiones de baja tensión de alimentación, TTL fué superada tecnológicamente por CMOS, debido a que la segunda logró evolucionar obteniendo mayor velocidad, densidad de integración, margen de ruido y menor consumo que TTL.

### INVERSOR



$$1) V_i = H$$

$T_1$  modo inverso  
 $E \rightarrow C, C \rightarrow E$

$$I_i = \alpha_i I_{c3} \rightarrow I_{b1} \approx I_{b3}$$

$\bar{L}$  muy bajo (0.02)  
 para sat. a  $T_3$   
 con  $I_i$  chica.

$$2) V_i = L \rightarrow V_{BE1} \text{ directa } \approx 0.75V$$

$$\rightarrow V_{CE1} \text{ SATURADO} \rightarrow T_3 \text{ OFF}$$

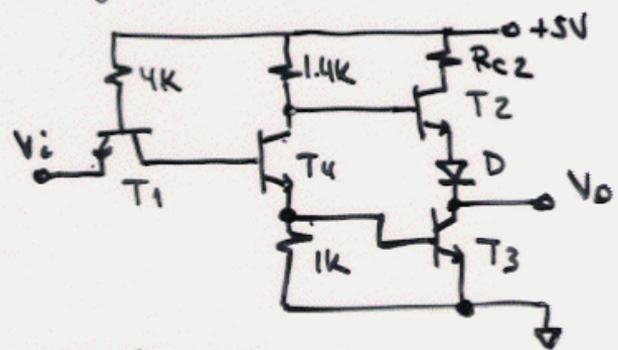
$$V_{CE \text{ SAT}} \approx 0.2V.$$

Desventaja:  $R_c$  alta  $\rightarrow$  gran retardo.  
 $R_c$  baja  $\rightarrow$  gran consumo.

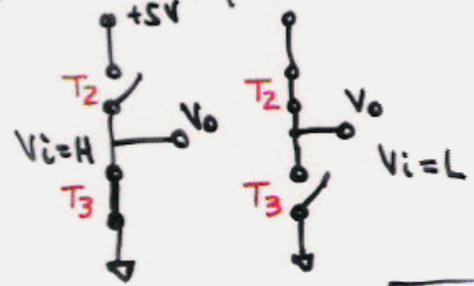
Este tipo de configuración permite:

- > Trabajar con fuente simple (+5V).
- > Consumir poca corriente a la entrada (alta impedancia de entrada).
- > Problemas con retardos ya que  $R_c$  debe ser pequeña y eso implica gran consumo.

Arreglo TOTEM - POLE :



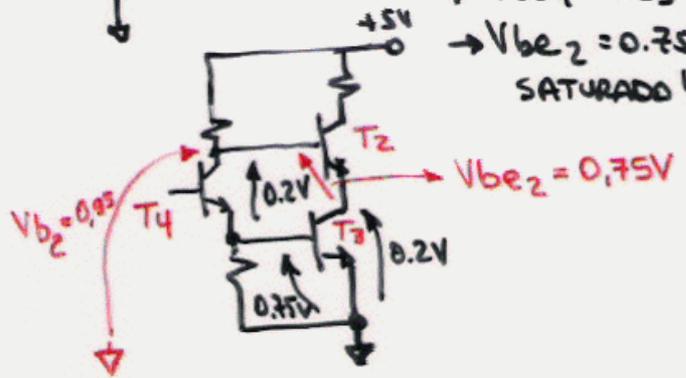
Etapa de salida eq :



- 1)  $V_i = H$   
 $T_1$  modo inverso  $\rightarrow$   
 $T_4$  SAT  $\rightarrow$   $T_3$  SAT  
 $\rightarrow$   $T_2$  OFF
- 2)  $V_i = L$   
 $T_1$  SAT  $\rightarrow$   
 $T_4$  OFF  $\rightarrow$   $T_2$  SAT  
 $\rightarrow$   $T_3$  OFF

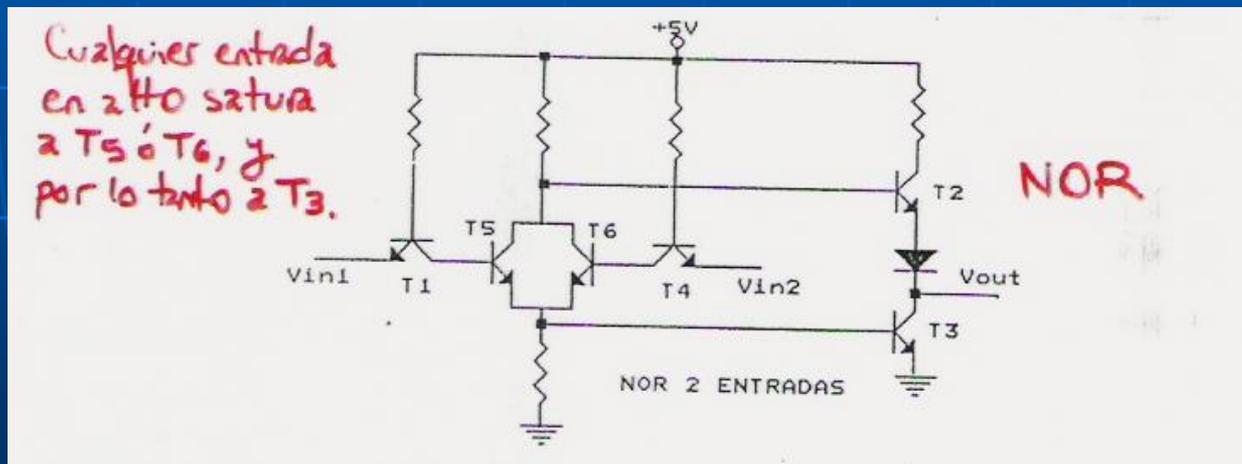
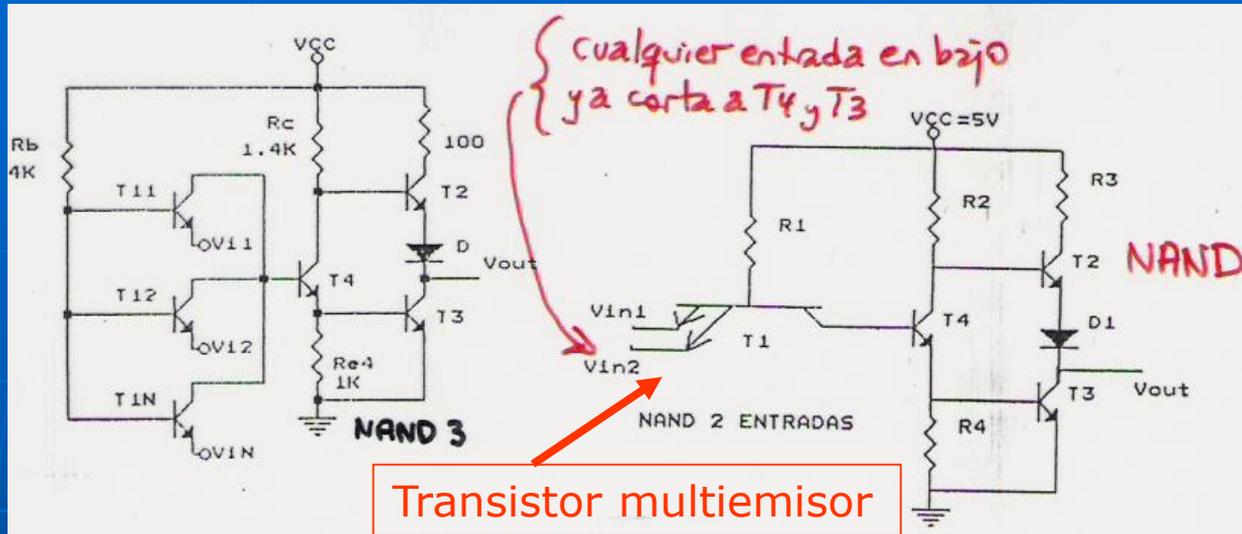
Función del diodo D :

$V_o = L \rightarrow T_4 = T_3 = \text{SAT.}$   
 $\Rightarrow V_{ce4} = V_{ce3} = 0,20V$   
 $\rightarrow V_{be2} = 0,75V$   
**SATURADO !!**



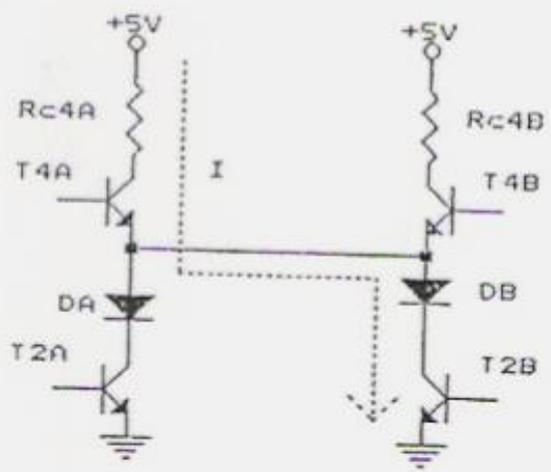
El circuito anterior se mejora en la etapa de salida.  
 T2 y T3 actúan como llaves que se abren y cierran en contrafase.

El diodo evita que se sature T2 junto con T3 (T2 debe estar cortado con  $V_{iH}$  (en alto)).  
 Con la inclusión de D, se necesitarían 0,6V adicionales para hacer conducir a T2 en esas condiciones.



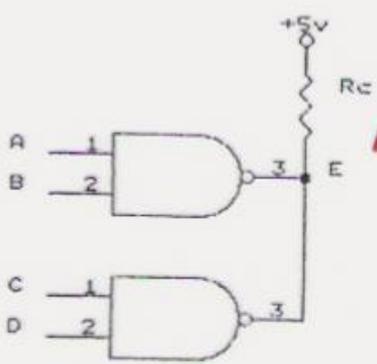
Por la tecnología empleada, las AND y OR se implementan negando a las NAND y NOR, respectivamente. Por lo tanto las primeras tienen mayor tiempo de retardo.

Porqué se necesitan salidas OPEN COLLECTOR ???

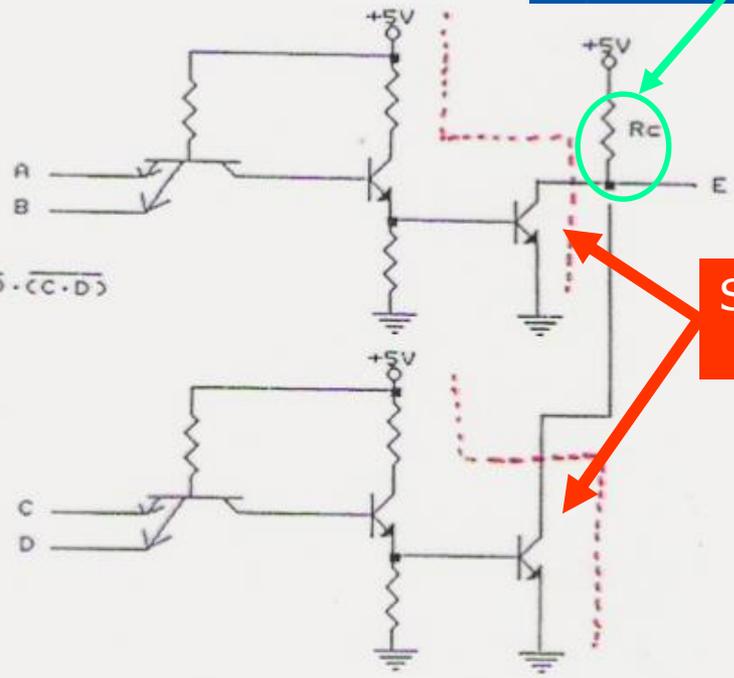


Si se unen salidas TTL y por ejemplo la salida de la compuerta A está en H y la de B en L, circularía una I muy grande que puede dañar al transistor T4 de A. Por ende si se requiere unir salidas se deben emplear CIs con salida OPEN COLLECTOR.

Función AND



$$E = (A \cdot B) \cdot (C \cdot D)$$

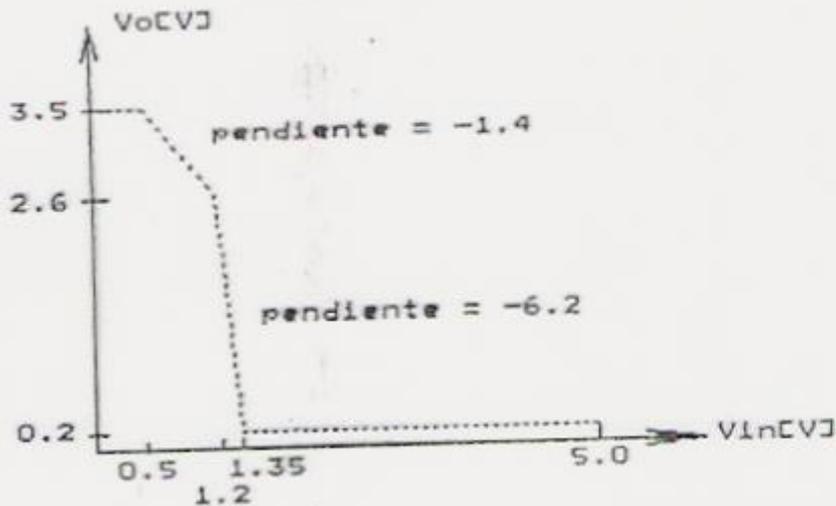


R externa

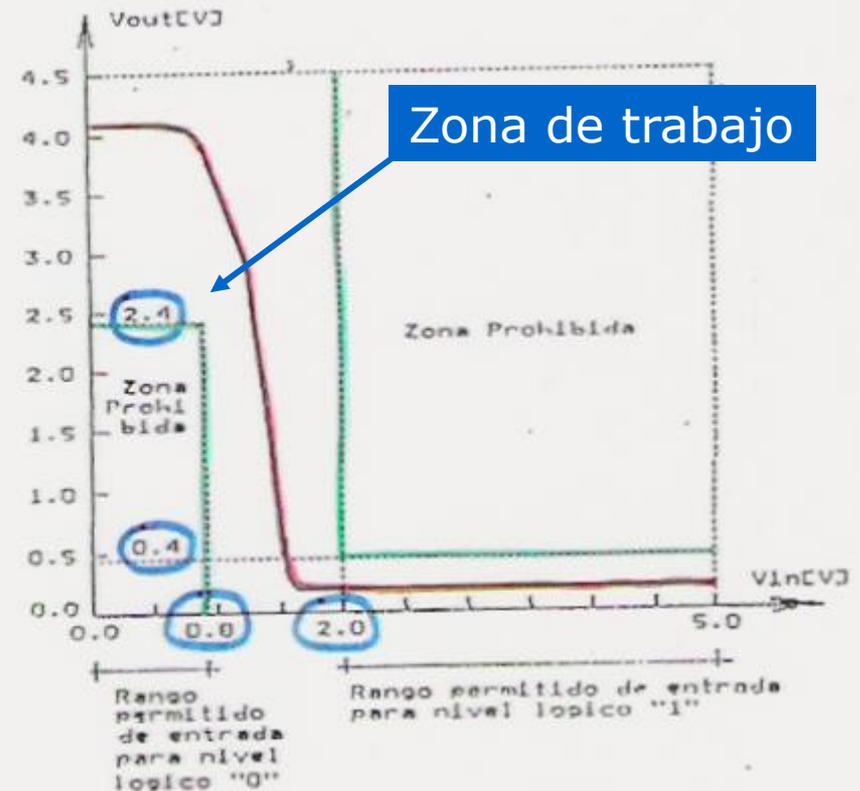
Salidas con transistores con colector abierto

## Función de transferencia idealizada de un inversor TTL

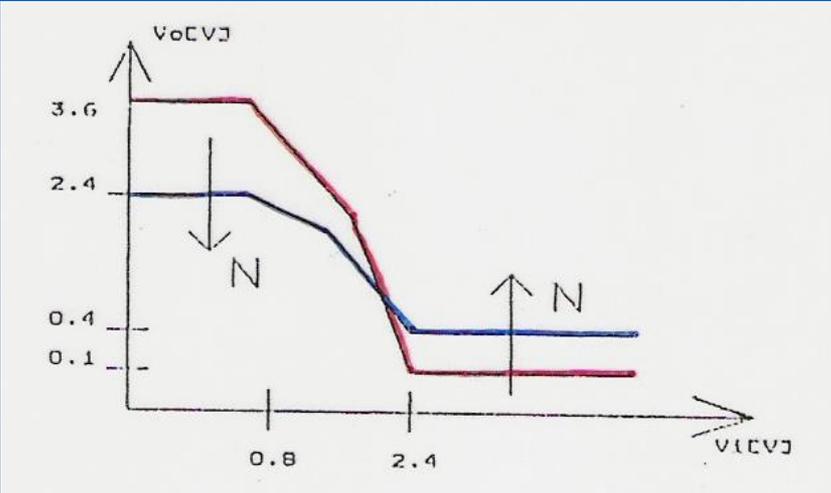
La transición de estado no ocurre en 2,5 V (mitad de  $V_{cc}$ ) sino en aproximadamente 1,2 V, lejos de lo ideal.



## Función de transferencia típica de un inversor con rangos de funcionamiento garantizados por el fabricante



La gráfica de la derecha indica que se permite que una salida TTL puede en estado alto bajar hasta 2,4 V sin salir de especificación, lo mismo que en estado bajo puede subir hasta 0,4 V. Respto a su entrada reconocerá un estado alto hasta una tensión de 2 V y un nivel bajo hasta 0,8 V. Si se cumple todo esto la compuerta reconocerá correctamente los dos niveles lógicos.



Efecto de incrementar la carga a la salida de una compuerta "1": La tensión en nivel L de la salida irá creciendo a medida que aumenta la corriente de carga. Lo contrario pasa en el nivel H (va bajando). El resultado es una degradación del margen de ruido.

En estado alto (H) a medida que se suman entradas la tensión VoH va a ir bajando.

$$\frac{I_{oHm\acute{a}x}}{I_{oHnorm}} = \frac{400\mu A}{40\mu A} = 10U.L$$

$$\frac{I_{oLm\acute{a}x}}{I_{oLnorm}} = \frac{8.0mA}{1.6mA} = 5U.L$$

$$\frac{I_{iHm\acute{a}x}}{I_{iHnorm}} = \frac{20\mu A}{40\mu A} = 0.5U.L$$

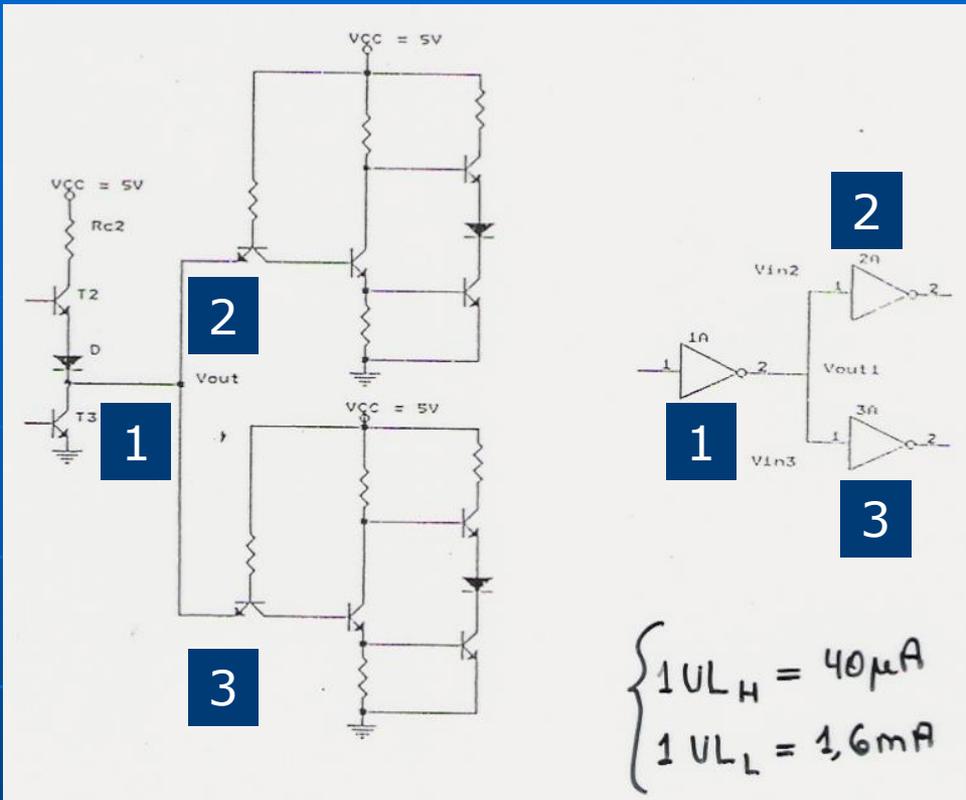
$$\frac{I_{iLm\acute{a}x}}{I_{iLnorm}} = \frac{0.4mA}{1.6mA} = 0.25U.L$$

Lo contrario en bajo, la tensión de salida VoL irá subiendo.

Bajo ningún concepto deberá llegar a los valores límites ( 2,4 V en H ó 0,8 V en L), caso contrario es posible que las compuertas "2" y "3" interpreten mal el nivel lógico.

Se definen valores normalizados de corriente de entrada para cada nivel lógico:  $I_{iHmax}=40 \mu A$  e  $I_{iLmax}=1,6mA$ .

Se establece que idealmente cada compuerta puede soportar 10 del mismo tipo a su entrada sin salir de especificación, es decir que podrá entregar  $I_{oHmax}=400\mu A$  e  $I_{oLmax}=16mA$ .



$$\begin{cases} 1 U_{LH} = 40\mu A \\ 1 U_{LL} = 1,6mA \end{cases}$$

# Familias Lógicas

En el ejemplo hay 3 inversores:  
El "1" es cargado por las  
entradas de "2" y "3".

Para saber si "1" cumple con los  
niveles de tensión en H y L, se  
debe leer la hoja de datos y en  
base a los valores máximos de  $I_i$   
e  $I_o$  para cada nivel, hacer la  
suma y verificar que tanto  
en H como en L no se exceda de  
la máxima corriente de salida  
requerida por la compuerta "1".

De la hoja de datos se desprende que:  
 $I_{i\max H} = 20\mu A$  e  $I_{iL\max} = -0,36mA$   
(negativo porque la corriente sale de  
del pin de entrada).  
 $I_{oH\max} = -0,4mA$  e  $I_{oL\max} = 8mA$ .

Como son 2 compuertas e iguales  
en este caso:  
 $I_{iL\text{total}} = -0,72mA < I_{oL\max} = 8mA$   
 $I_{iH\text{total}} = 40\mu A < I_{oH\max} = -0,4mA$

En este caso el inversor "1" puede  
alimentar a ambos inversores.  
Peor caso en H:  $0,4mA / 20\mu A = 20$  inversores.  
Peor caso en L:  $8mA / 0,36mA = 22$  inversores.

DM74LS04

## Absolute Maximum Ratings (Note 1)

Supply Voltage	7V
Input Voltage	7V
Operating Free Air Temperature Range	0°C to +70°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C

**Note 1:** The "Absolute Maximum Ratings" are those values beyond which the safety of the device cannot be guaranteed. The device should not be operated at these limits. The parametric values defined in the Electrical Characteristics tables are not guaranteed at the absolute maximum ratings. The "Recommended Operating Conditions" table will define the conditions for actual device operation.

## Recommended Operating Conditions

Symbol	Parameter	Min	Nom	Max	Units
$V_{CC}$	Supply Voltage	4.75	5	5.25	V
$V_{IH}$	HIGH Level Input Voltage	2			V
$V_{IL}$	LOW Level Input Voltage			0.8	V
$I_{OH}$	HIGH Level Output Current			-0.4	mA
$I_{OL}$	LOW Level Output Current			8	mA
$T_A$	Free Air Operating Temperature	0		70	°C

## Electrical Characteristics

over recommended operating free air temperature range (unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ (Note 2)	Max	Units
$V_I$	Input Clamp Voltage	$V_{CC} = \text{Min}, I_I = -18 \text{ mA}$			-1.5	V
$V_{OH}$	HIGH Level Output Voltage	$V_{CC} = \text{Min}, I_{OH} = \text{Max}, V_{IL} = \text{Max}$	2.7	3.4		V
$V_{OL}$	LOW Level Output Voltage	$V_{CC} = \text{Min}, I_{OL} = \text{Max}, V_{IH} = \text{Min}$		0.35	0.5	V
		$I_{OL} = 4 \text{ mA}, V_{CC} = \text{Min}$		0.25	0.4	
$I_I$	Input Current @ Max Input Voltage	$V_{CC} = \text{Max}, V_I = 7V$			0.1	mA
$I_{IH}$	HIGH Level Input Current	$V_{CC} = \text{Max}, V_I = 2.7V$			20	$\mu A$
$I_{IL}$	LOW Level Input Current	$V_{CC} = \text{Max}, V_I = 0.4V$			-0.36	mA
$I_{OS}$	Short Circuit Output Current	$V_{CC} = \text{Max}$ (Note 3)	-20		-100	mA
$I_{CCH}$	Supply Current with Outputs HIGH	$V_{CC} = \text{Max}$		1.2	2.4	mA
$I_{CCL}$	Supply Current with Outputs LOW	$V_{CC} = \text{Max}$		3.6	6.6	mA

**Note 2:** All typicals are at  $V_{CC} = 5V, T_A = 25^\circ C$ .

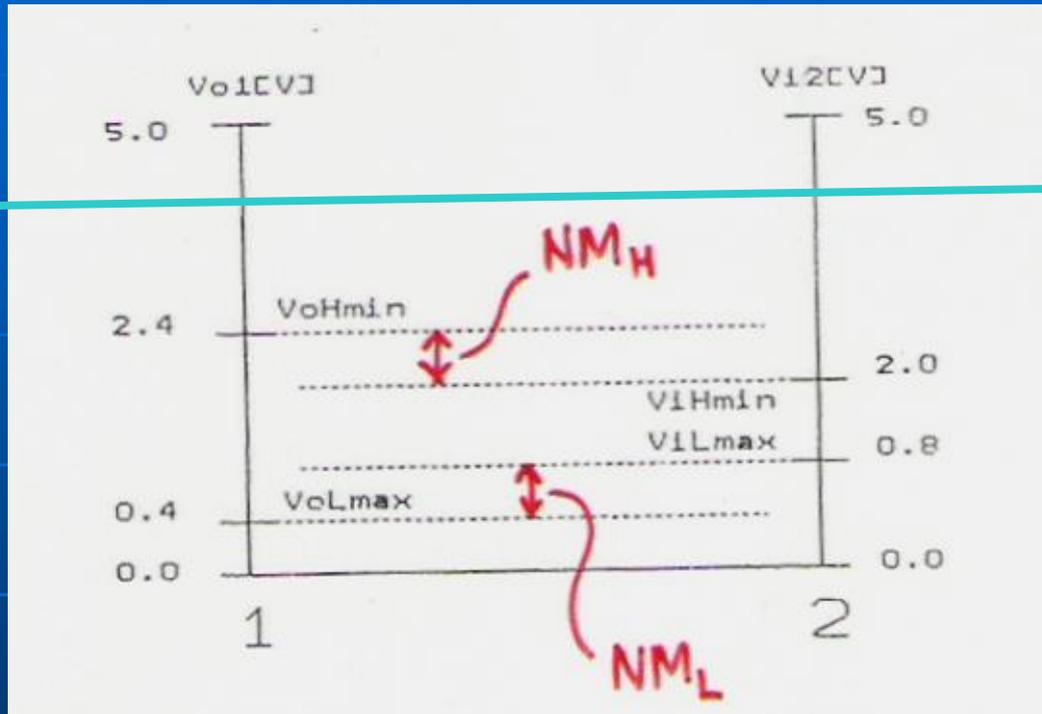
**Note 3:** Not more than one output should be shorted at a time, and the duration should not exceed one second.

El límite real es la peor condición:  
**FAn Out = 20 compuertas**

## Márgen de ruido en nivel alto y bajo

Salida de compuerta 1

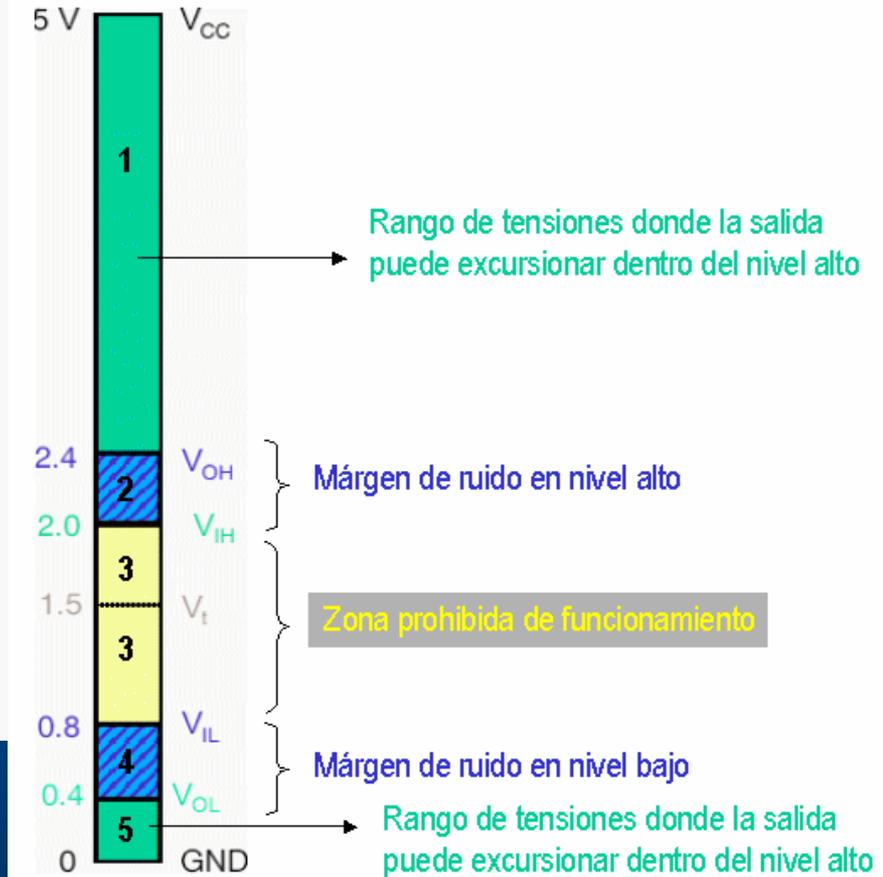
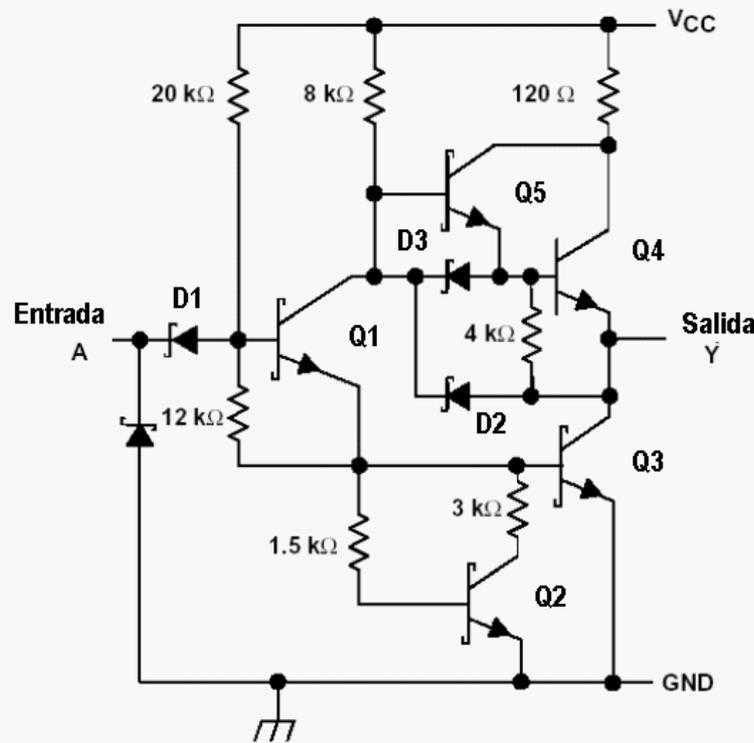
Entrada de compuerta 2



Si se cumplen las condiciones estipuladas de niveles de entrada y salida entre la salida de una compuerta y las entradas de otras conectadas a la misma, existirá un margen de tensiones tanto en H y L que en TTL es de alrededor de 400mV para que se llegue a caso crítico de error al querer reconocer un dado nivel lógico. se denominan Margén de Ruido en nivel bajo:  $NM_L$  y Margén de Ruido en el nivel alto:  $NM_H$ .



### Circuito de un inversor TTL serie 74 LS



Power Schottky comenzó con la serie 74S y **culminó** con la 74LS, donde la L significa versión de bajo consumo (Low Power Schottky).

Usa transistores tipo Schottky para mejorar la conmutación cuando se debe sacar a un transistor de la saturación.

## Familia TTL serie 74LS Características Generales

General Characteristics for Schottky TTL Logic (All Maximum Ratings)

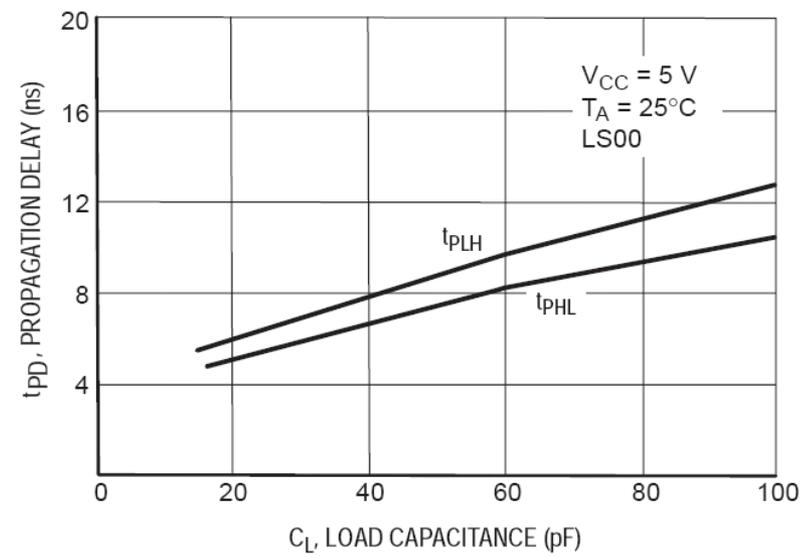
Characteristic	Symbol	74LSxxx	Unit
Operating Voltage Range	$V_{CC}$	$5 \pm 5\%$	Vdc
Operating Temperature Range	$T_A$	0 to 70	°C
Input Current	$I_{IN}$	$I_{IH}$	20
		$I_{IL}$	-400
Output Drive Standard Output	$I_{OH}$	-0.4	mA
	$I_{OL}$	8.0	mA
	$I_{SC}$	-20 to -100	mA
Buffer Output	$I_{OH}$	-15	mA
	$I_{OL}$	24	mA
	$I_{SC}$	-40 to -225	mA

Speed/Power Characteristics for Schottky TTL Logic<sup>(1)</sup>  
(All Typical Ratings)

Characteristic	Symbol	Typ	Unit
Quiescent Supply Current/Gate	$I_G$	0.4	mA
Power/Gate (Quiescent)	$P_G$	2.0	mW
Propagation Delay	$t_p$	9.0	ns
Speed Power Product	—	18	pJ
Clock Frequency (D-F/F)	$f_{max}$	33	MHz
Clock Frequency (Counter)	$f_{max}$	40	MHz

NOTES: 1. Specifications are shown for the following conditions:  
 a)  $V_{CC} = 5.0$  Vdc (AC),  
 b)  $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  
 c)  $C_L = 15$  pF.

## Familia TTL serie 74LS Retardo de propagación vs. Capacidad de carga

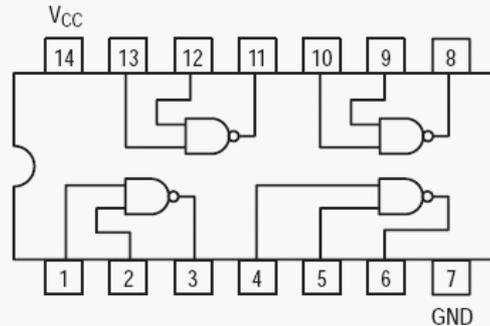


Fan out H =  $400\mu\text{A} / 20\mu\text{A} = 20$   
 Fan out L =  $8\text{mA} / 0.4\text{mA} = 20$

### SN74LS00

### Quad 2-Input NAND Gate

- ESD > 3500 Volts



**ON Semiconductor**

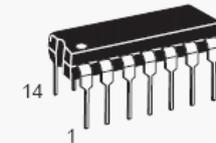
Formerly a Division of Motorola

<http://onsemi.com>

**LOW  
POWER  
SCHOTTKY**

#### GUARANTEED OPERATING RANGES

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
$V_{CC}$	Supply Voltage	4.75	5.0	5.25	V
$T_A$	Operating Ambient Temperature Range	0	25	70	°C
$I_{OH}$	Output Current – High			-0.4	mA
$I_{OL}$	Output Current – Low			8.0	mA



**PLASTIC  
N SUFFIX  
CASE 646**

#### AC CHARACTERISTICS ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
$t_{PLH}$	Turn-Off Delay, Input to Output		9.0	15	ns	$V_{CC} = 5.0 \text{ V}$ $C_L = 15 \text{ pF}$
$t_{PHL}$	Turn-On Delay, Input to Output		10	15	ns	

**SN74LS74A****Dual D-Type Positive  
Edge-Triggered Flip-Flop****AC CHARACTERISTICS** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 5.0\text{ V}$ )

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions	
		Min	Typ	Max			
$f_{MAX}$	Maximum Clock Frequency	25	33		MHz	Figure 1	$V_{CC} = 5.0\text{ V}$ $C_L = 15\text{ pF}$
$t_{PLH}$ $t_{PHL}$	Clock, Clear, Set to Output		13	25	ns	Figure 1	
			25	40	ns		

**AC SETUP REQUIREMENTS** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions	
		Min	Typ	Max			
$t_{W(H)}$	Clock	25			ns	Figure 1	$V_{CC} = 5.0\text{ V}$
$t_{W(L)}$	Clear, Set	25			ns	Figure 2	
$t_s$	Data Setup Time — HIGH LOW	20			ns	Figure 1	
		20			ns		
$t_h$	Hold Time	5.0			ns	Figure 1	

**CONTADORES BCD Y BINARIO****SN74LS161A SN74LS163A****AC CHARACTERISTICS** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
$f_{\text{MAX}}$	Maximum Clock Frequency	25	32		MHz	$V_{\text{CC}} = 5.0\text{ V}$ $C_L = 15\text{ pF}$
$t_{\text{PLH}}$ $t_{\text{PHL}}$	Propagation Delay Clock to TC		20 18	35 35	ns	
$t_{\text{PLH}}$ $t_{\text{PHL}}$	Propagation Delay Clock to Q		13 18	24 27	ns	
$t_{\text{PLH}}$ $t_{\text{PHL}}$	Propagation Delay CET to TC		9.0 9.0	14 14	ns	
$t_{\text{PHL}}$	$\overline{\text{MR}}$ or $\overline{\text{SR}}$ to Q		20	28	ns	

**AC SETUP REQUIREMENTS** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
$t_{\text{WCP}}$	Clock Pulse Width Low	25			ns	$V_{\text{CC}} = 5.0\text{ V}$
$t_{\text{W}}$	$\overline{\text{MR}}$ or $\overline{\text{SR}}$ Pulse Width	20			ns	
$t_{\text{s}}$	Setup Time, other*	20			ns	
$t_{\text{s}}$	Setup Time $\overline{\text{PE}}$ or $\overline{\text{SR}}$	25			ns	
$t_{\text{h}}$	Hold Time, data	3			ns	
$t_{\text{h}}$	Hold Time, other	0			ns	
$t_{\text{rec}}$	Recovery Time $\overline{\text{MR}}$ to CP	15			ns	

\*CEP, CET, or DATA



## TTL Family Comparisons

## Tabla de comparación entre subfamilias TTL

### General Characteristics for Schottky TTL Logic

(ALL MAXIMUM RATINGS)

Characteristic	Symbol	LS		ALS			FAST		Units
		54LSxxx	74LSxxx	54ALSxxx	74ALSxxx		54Fxxx	74Fxxx	
Operating Voltage Range	V <sub>CC</sub>	5 ± 10%	5 ± 5%	5 ± 10%	5 ± 10%	5 ± 5%	5 ± 10%	5 ± 5%	V <sub>dc</sub>
Operating Temperature Range	T <sub>A</sub>	-55 to 125	0 to 70	-55 to 125	0 to 70	0 to 70	-55 to 125	0 to 70	°C
Input Current	I <sub>ih</sub>	20	20	20	20	20	20	20	μA
	I <sub>il</sub>	-400	-400	-100	-100	-100	-600	-600	
Output Drive Standard Output	I <sub>oh</sub>	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-1.0	-1.0	mA
	I <sub>ol</sub>	4.0	8.0	4.0	8.0	8.0	7.0	7.0	
	I <sub>sc</sub>	-20 to -100	-20 to -100	-25 to -150	-25 to -150	-25 to -150	-60 to -150	-60 to -150	
Buffer Output	I <sub>oh</sub>	-12	-15	-12	-15	-15	-12	-15	mA
	I <sub>ol</sub>	12	24	12	24	24	48	64	
	I <sub>sc</sub>	-40 to -225	-40 to -225	-50 to -225	-50 to -225	-50 to -225	-100 to -225	-100 to -225	
Buffer Line Driving Capability: Minimum R <sub>L</sub> into 2.5 V		178	84	178	84	84	43	32	Ω
	Minimum R <sub>L</sub> into 5.0 V	381	189	381	189	189	95	71	Ω

### Speed/Power Characteristics for Schottky TTL Logic<sup>(1)</sup>

(ALL TYPICAL RATINGS)

Characteristic	Symbol	LS	ALS	FAST	Units
Quiescent Supply Current/Gate	I <sub>G</sub>	0.4	0.2	1.1	mA
Power/Gate (Quiescent)	P <sub>G</sub>	2.0	1.0	5.5	mW
Propagation Delay	t <sub>p</sub>	9.0	5.0	3.7	ns
Speed Power Product	—	18	5.0	19.2	pJ
Clock Frequency (D-F/F)	f <sub>max</sub>	33	35	125	MHz
Clock Frequency (Counter)	f <sub>max</sub>	40	45	125	MHz

## Lógica CMOS

### Evolución:

Serie 4000, serie 4000UB-4000B,  
Serie 74C, serie 74HC-74HCT, serie 74AC-74ACT,  
Serie 74AHC-74AHCT, etc..

Versiones de baja tensión de alimentación:  
(3,3V, 2,5V, 1,8V, 1,2V)

## Lógica CMOS Standard

### Serie 4000

Es la mas antigua de CMOS.

Sus mayores ventajas son:

Extremado bajo consumo.

Mayor DENSIDAD de INTEGRACIÓN.

Alta inmunidad al ruido.

Alto Fan-out.

Rango de tensiones de alimentación amplio (3 V a 18V).

**Principal desventaja: Velocidad.**

TTL sólo se puede alimentar con 5V +/- 5%

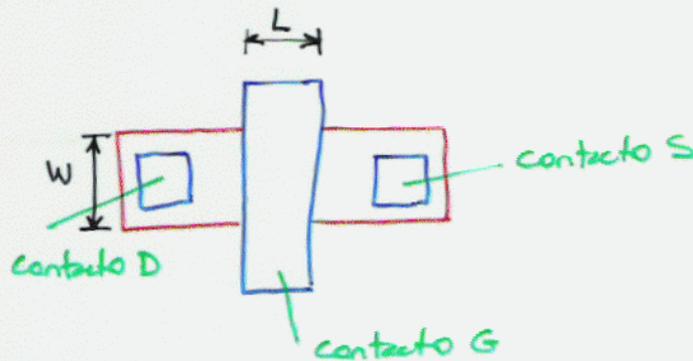
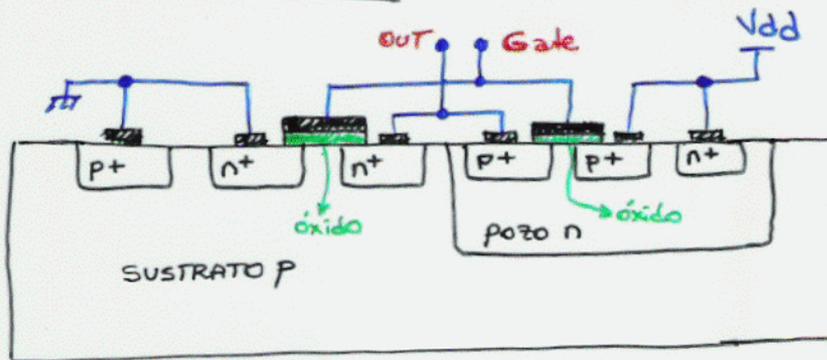
En la actualidad viene en dos versiones: 4xxxUB y 4xxxB.

La primera, UB (unbuffered) es un poco más rápida pero con poca capacidad de corriente de salida.

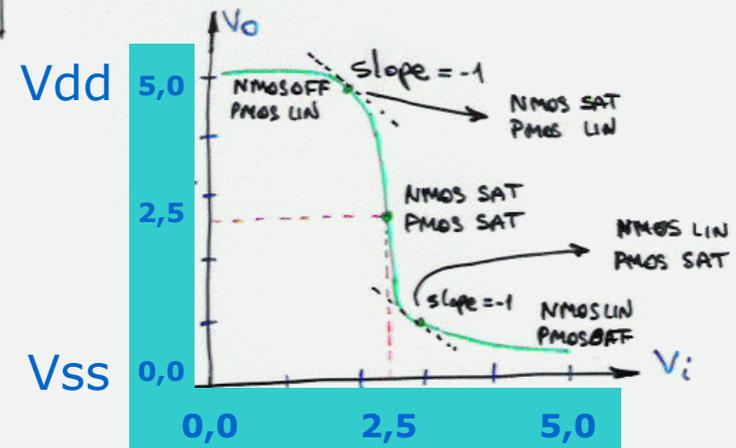
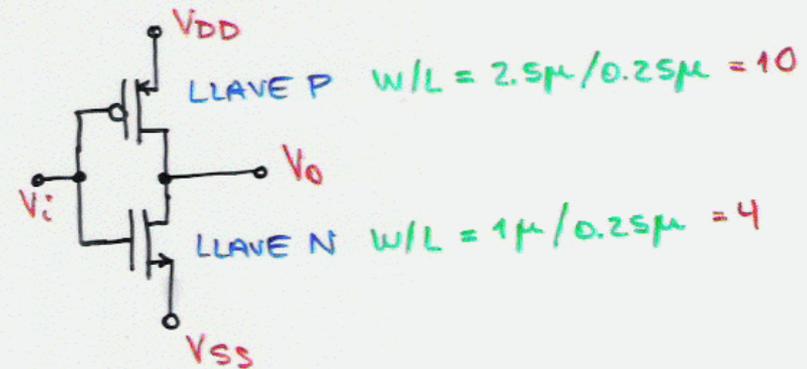
La segunda, B (buffered) es un poco más lenta pero tiene mayor corriente para alimentar cargas TTL ya que posee un driver a la salida (generalmente un inversor) con lo cual hay que negar dos veces y eso hace mas lento al circuito.

## Circuito de un inversor CMOS

### Inversor CMOS

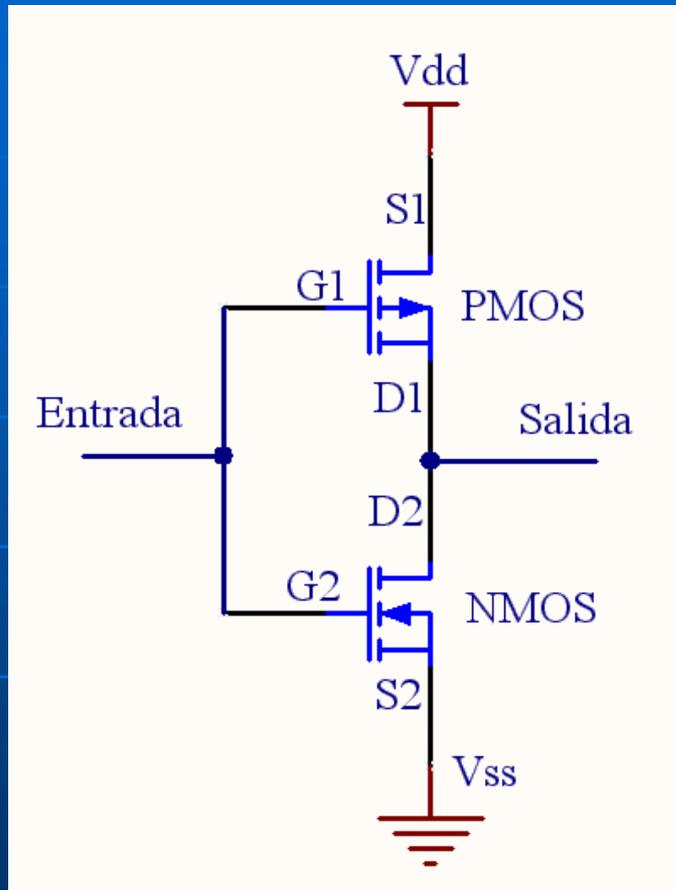


### Inversor CMOS

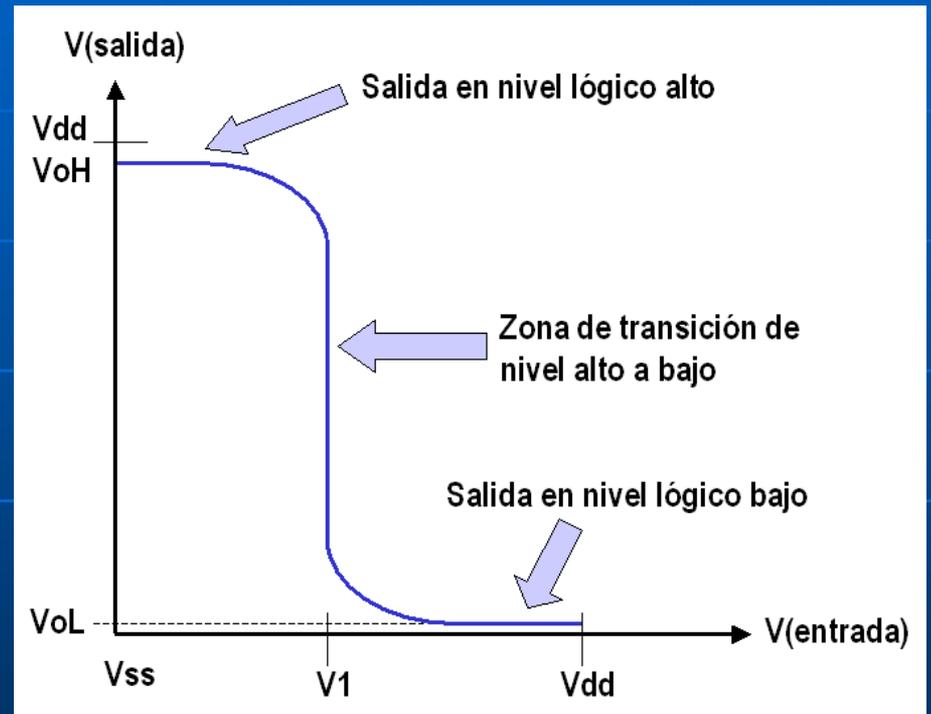


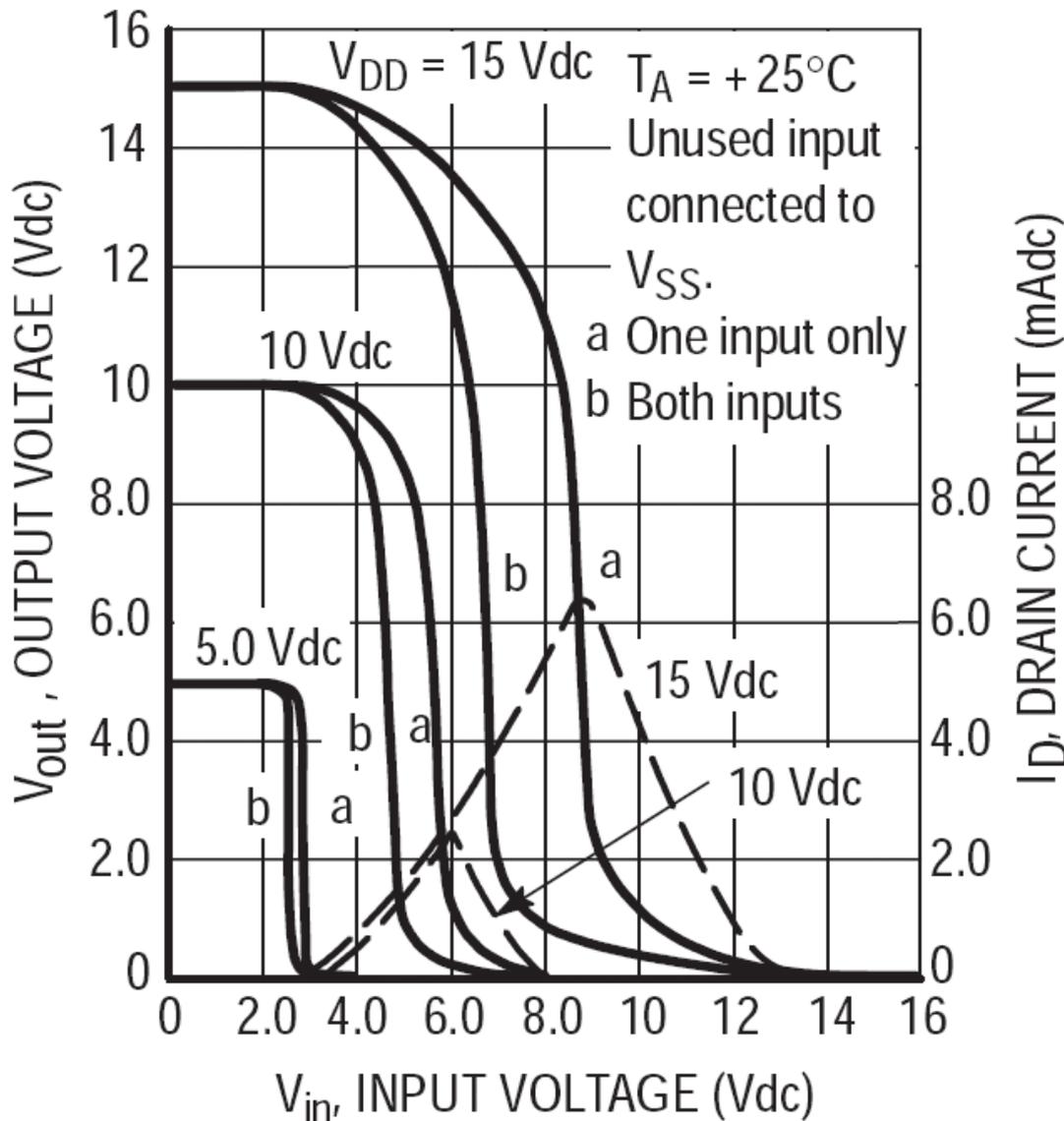
La base comienza con un sustrato de Silicio que es un material de fácil accesibilidad y económico. Por procesos litográficos se procede a generar las áreas de dopaje para construir siempre dos tipos de transistores: NMOS y PMOS. El tamaño del transistor es clave para conseguir la mejor densidad de integración y mayor velocidad de conmutación posible. Hoy en día se diseña al transistor en tres dimensiones y con múltiples gates para mejorar su performance.

## Circuito de un inversor CMOS



## Respuesta idealizada

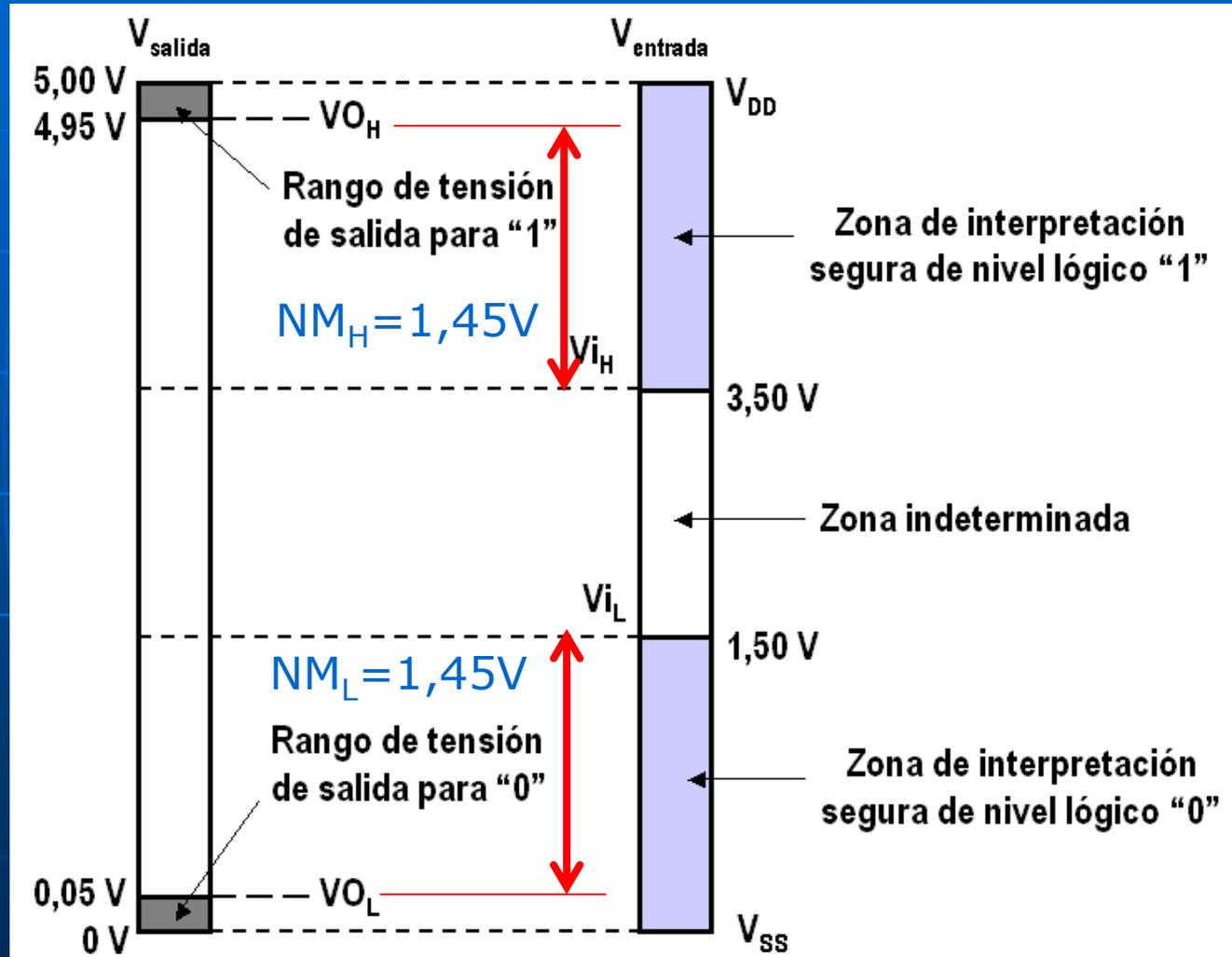




**FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA REAL DE HOJAS DE DATOS DE ALGUNAS COMPUERTAS CMOS SERIE 4000 para 3 niveles de tensión de alimentación  $V_{DD}$ : 5, 10 y 15 V y con temperatura ambiente estable en  $25^\circ\text{C}$ .**

**Qué funciones lógicas puede representar este tipo de respuesta ...??**

## Márgen de ruido en CMOS



## Ecuaciones del MOSFET canal N

o Región de corte:  $I_{ds} = 0$  para  $V_{gs} - V_T < 0$

o Región lineal:

$$I_{ds} = \mu C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot \left[ (V_{gs} - V_T) \cdot V_{ds} - \frac{V_{ds}^2}{2} \right] \cdot (1 + \lambda \cdot V_{ds})$$

$$\text{para } 0 < V_{ds} < V_{gs} - V_T$$

o Capacidad del óxido

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} \quad (\text{F/m}^2)$$

→ espesor

o Región de saturación:

$$I_{ds} = \frac{\mu C_{ox}}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{gs} - V_T)^2 \cdot (1 + \lambda V_{ds}) \quad \text{para } V_{ds} > V_{gs} - V_T$$

Retardo de propagación

$$t_{PLH} = \frac{C_L \cdot V_{dd}}{k_p (V_{dd} - |V_{TP}|)^2} \approx \frac{C_L}{k_p \cdot V_{dd}} \propto 1/L_p$$

$$t_{pHL} = \frac{C_L \cdot V_{dd}}{k_n (V_{dd} - |V_{TN}|)^2} \approx \frac{C_L}{k_n \cdot V_{dd}} \propto 1/L_n$$

$$t_p \approx \frac{1}{2} (t_{pLH} + t_{pHL}) = \frac{C_L}{2 \cdot V_{dd}} \cdot \left( \frac{1}{k_n} + \frac{1}{k_p} \right)$$

Para reducir retardos:

- REDUCIR  $C_L$
- INCREMENTAR  $k_n$  y  $k_p$   
 $\Rightarrow$  aumentar  $W/L \Rightarrow I_{Ds} \uparrow$

En la tecnología CMOS la velocidad de respuesta se puede incrementar si se **reduce el tamaño del canal** del transistor MOS.

La mejora en los procesos de fabricación ha posibilitado crear transistores 3D con longitud de canal (hasta el momento) por debajo de la decena de nanómetros.

## Inversor CMOS

Disipación de potencia dinámica

- Función del tamaño del transistor  
(Capacidades de GATE y parásitas)

- Para reducir  $P_d$  se puede:

o Reducir  $C_L$

o Reducir  $V_{dd}$   $\Rightarrow$  MAS EFECTIVO

o Reducir freq.

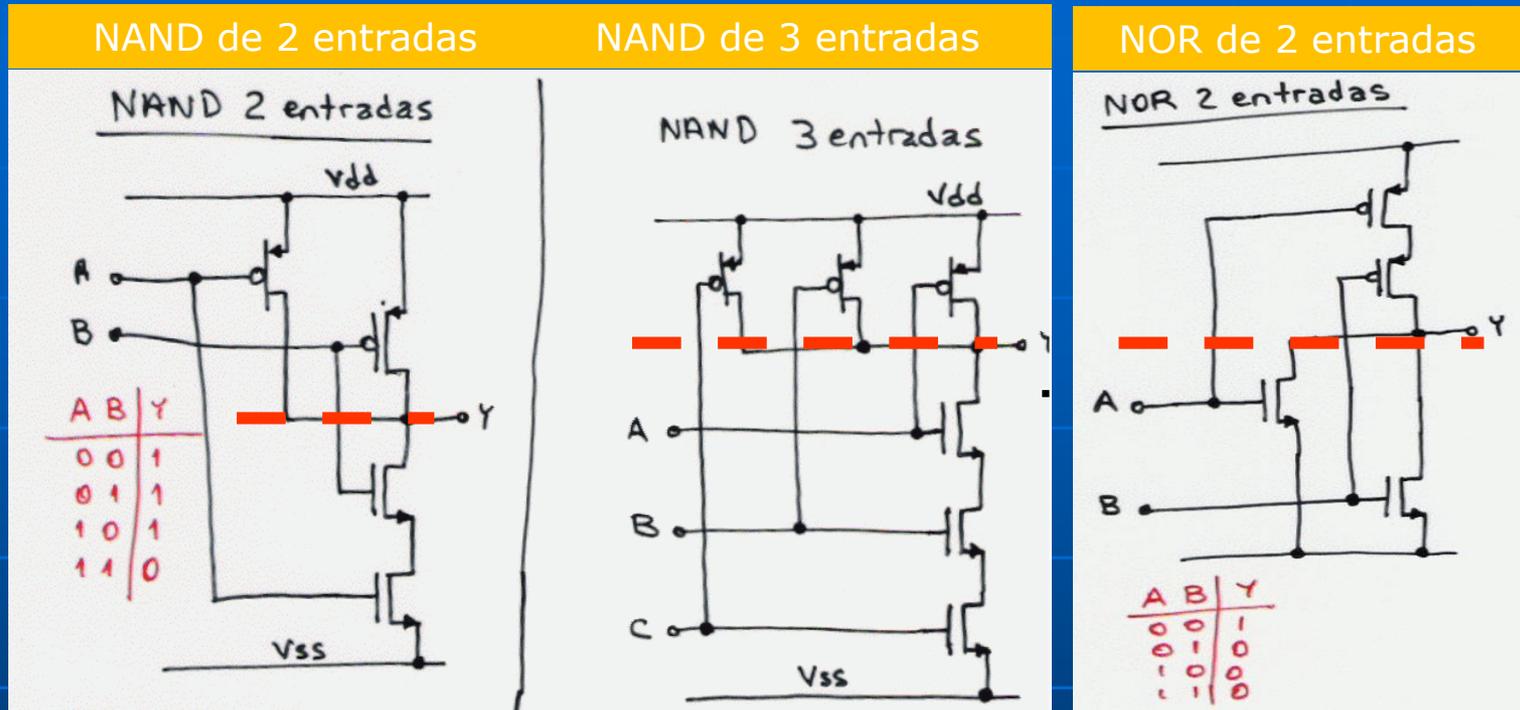
$$E = \frac{1}{2} C_L \cdot V_{dd}^2$$

$$P = 2 \cdot f \cdot E = f \cdot C_L \cdot V_{dd}^2$$

Por años se ha empleado la técnica de disminuir la tensión de alimentación  $V_{dd}$  para bajar la potencia disipada. Comenzando por 5 V y pasando por 3,3V, 2,5V, 1,8V y actualmente 1,2V.

**Si se reduce a la mitad  $V_{dd}$  se baja 4 veces el consumo de energía.**

## Estructuras simples de compuertas CMOS



Existe una **antisimetría** (ver línea horizontal a trazos) en la construcción de compuertas en CMOS.

La parte superior basada en transistores PMOS donde los mismos se activan con una entrada de gate se pone a Vdd. Una vez que se consigue un camino entre "Y" y Vdd, la salida vale "1". Lo opuesto ocurre con los transistores NMOS en la parte inferior. Se activan cuando en el gate la tensión se pone a Vss. Cuando se logra un camino entre "Y" y Vss, la salida vale "0".

El arreglo de Trs PMOS es "complementario" al arreglo hecho con los Trs. NMOS.

En la NAND, los PMOS están en paralelo y los NMOS en serie.

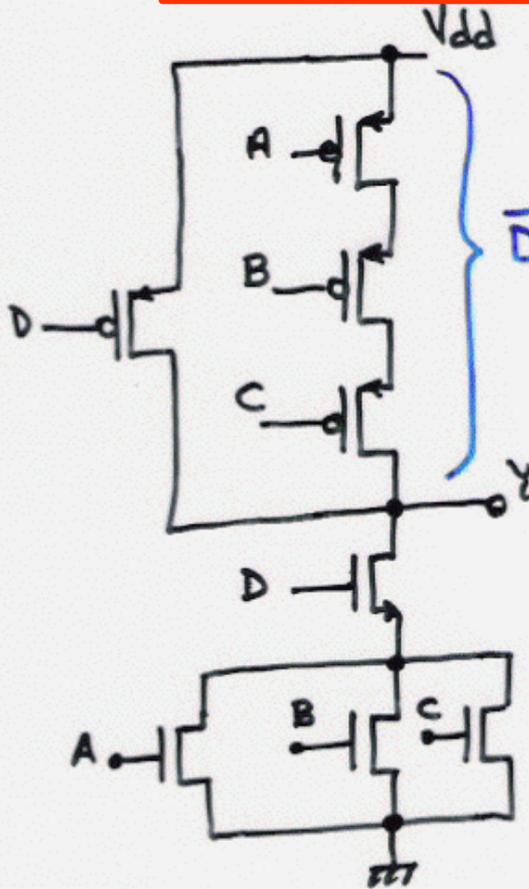
En la NOR pasa lo mismo, salvo que los PMOS están en serie y los NMOS en paralelo.

## Compuertas CMOS complejas

Función:  $Y = \overline{D \cdot (A+B+C)}$

Ciertas funciones se pueden implementar con un solo bloque de retardos .

En TTL exigiría 3 niveles de compuertas ...!!!!

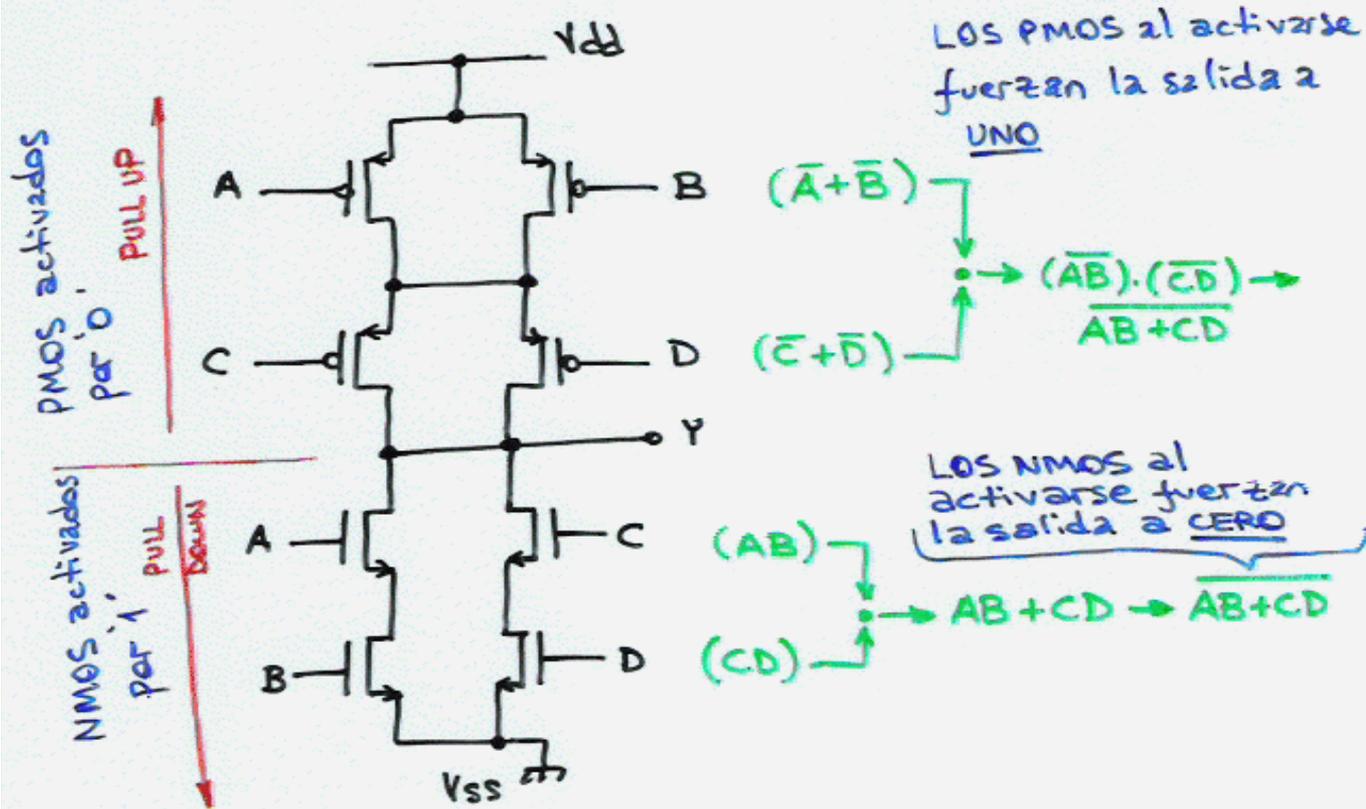


$$\overline{D + \overline{A} \overline{B} \overline{C}} = Y = \overline{\overline{D \cdot (A+B+C)}} = \overline{D \cdot (A+B+C)}$$

$$= \overline{D} + \overline{(A+B+C)} = \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

$$D \cdot (A+B+C) = \overline{Y}$$

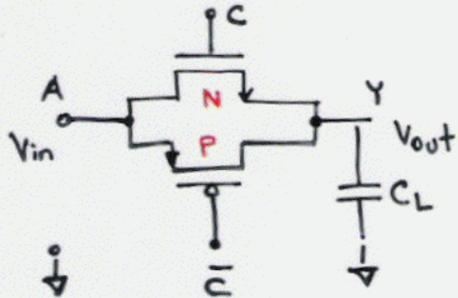
## Compuertas CMOS complejas



La regla de diseño es que la función implementada con los PMOS para lograr la  $F = '1'$ , debe tener otra función  $\bar{F}$  implementada con los NMOS.

# Familias Lógicas

## Compuerta de paso CMOS - SWITCH CMOS -



C	A	Y
0	0	?
0	1	?
1	0	BUEN 0
1	1	BUEN 1

ALTA Z (for 0,0 and 0,1)  
NO INVERSOR (for 1,0 and 1,1)

### Transición de entrada de 0 a 1

NMOS: trabaja como seguidor por fuente  
 $V_{gs} = V_{ds}$  siempre.

Cuando  $V_{out} < V_{dd} - V_{tn}$  → SATURA

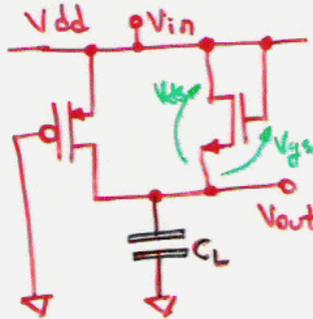
Cuando  $V_{out} > V_{dd} - V_{tn}$  → CORTA

PMOS: trabaja como fuente de corriente

Cuando  $V_{out} < |V_{tp}|$  → SATURA

Cuando  $V_{out} > |V_{tp}|$  → FUNC. LINEAL

### CIRCUITO EQUIVALENTE



### Transición de entrada de 1 a 0

NMOS: trabaja como fuente de corriente

Cuando  $V_{out} > V_{dd} - V_{tn}$  → SATURA

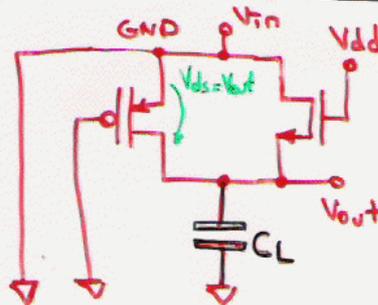
Cuando  $V_{out} < V_{dd} - V_{tn}$  → FUNC. LIN.

PMOS: trabaja como seguidor por fuente

$V_{gs} = V_{ss}$  siempre

Cuando  $V_{out} > |V_{tp}|$  → SATURA

Cuando  $V_{out} < |V_{tp}|$  → CORTA



Funcionamiento de compuerta tipo pass-gate.

Se considera que la llave está en "ON" y debe alimentar una dada capacidad de carga que simularía a la entrada de otra compuerta CMOS.

El primer esquema representa el caso donde la entrada A pasa a Vdd.

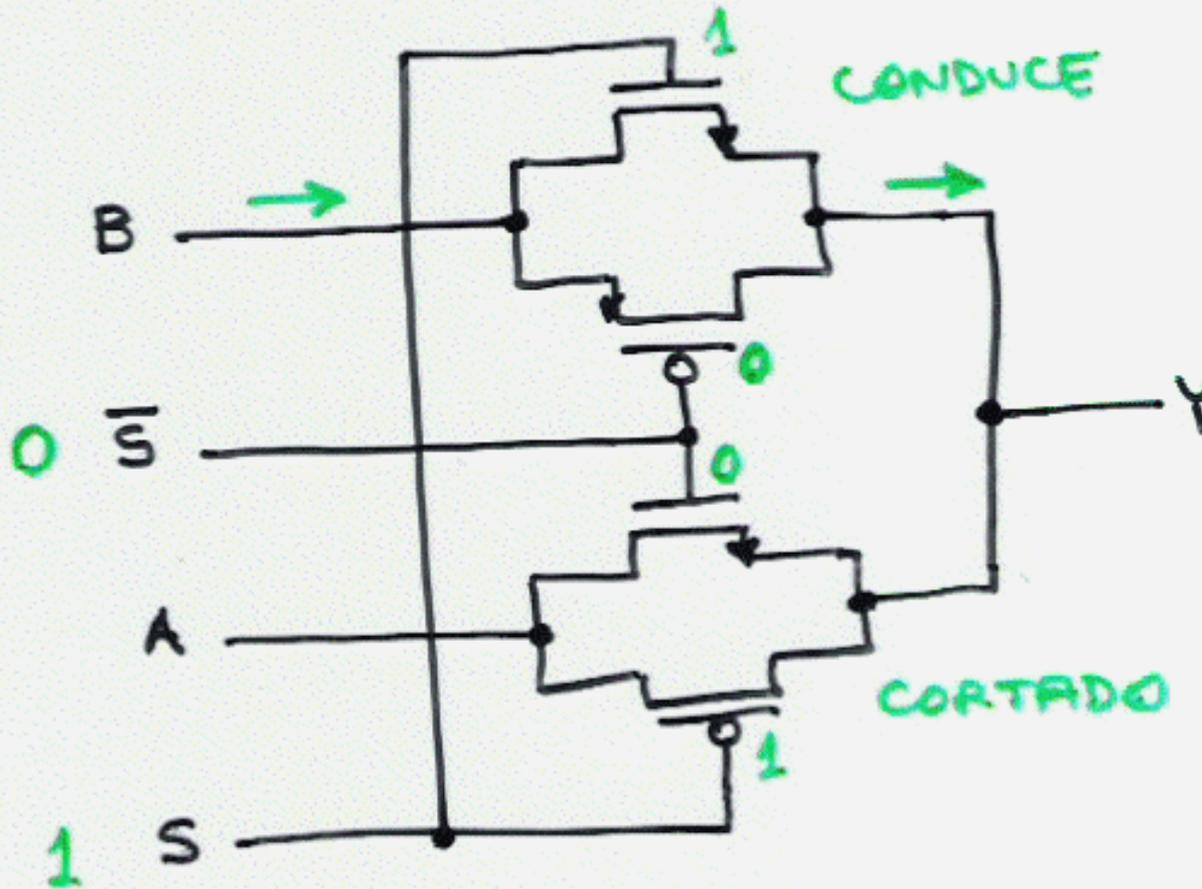
Se muestra como en base a los 3 puntos de funcionamiento de los TRs. MOS se pasa por estados de zona de corte-lineal y saturación según sea el caso.

Termina la carga C cargada a Vdd a través de el PMOS.

El segundo esquema es lo mismo pero la entrada pasa a Vss y la carga se irá descargando, terminando a Vss por el NMOS.

MUX basado en compuertas pass-gate

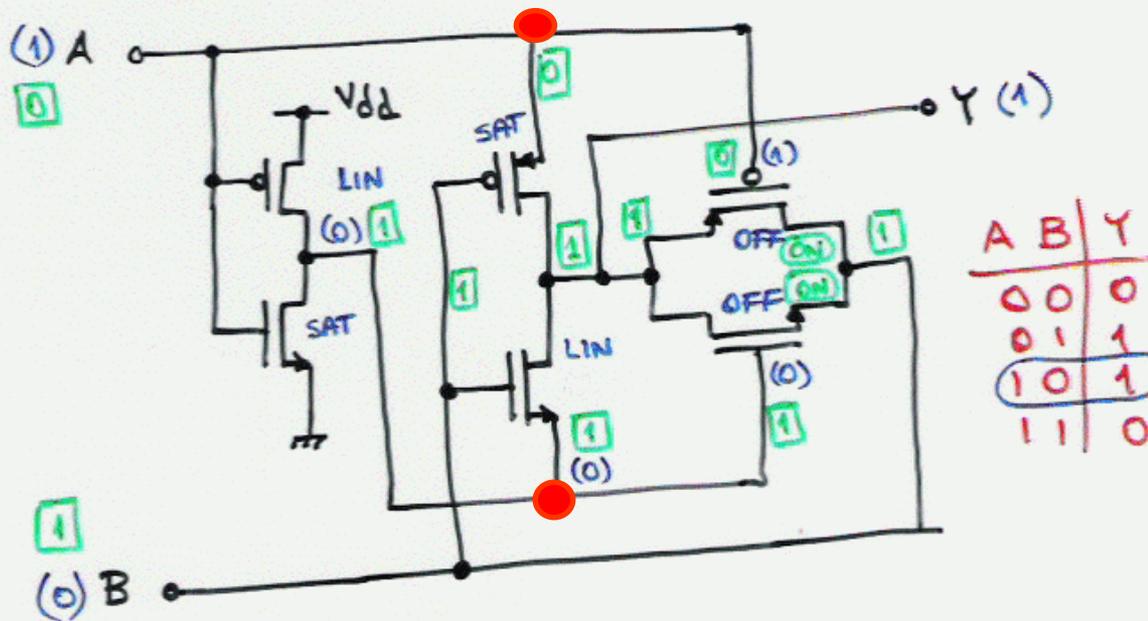
## MULTIPLEXER 2:1



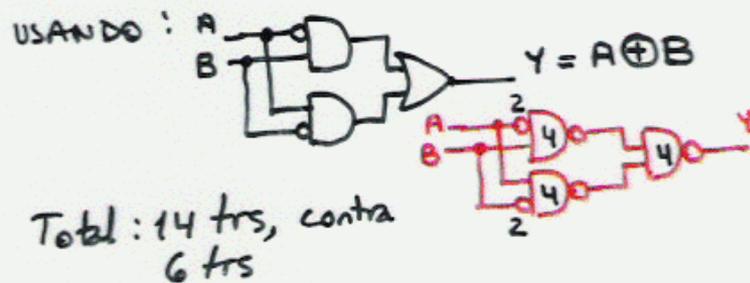
S	Y
0	A
1	B

## OR EXCLUSIVA

## OR-EXCL basada en pass-gate



MAS SIMPLE, MENOR RETARDO QUE

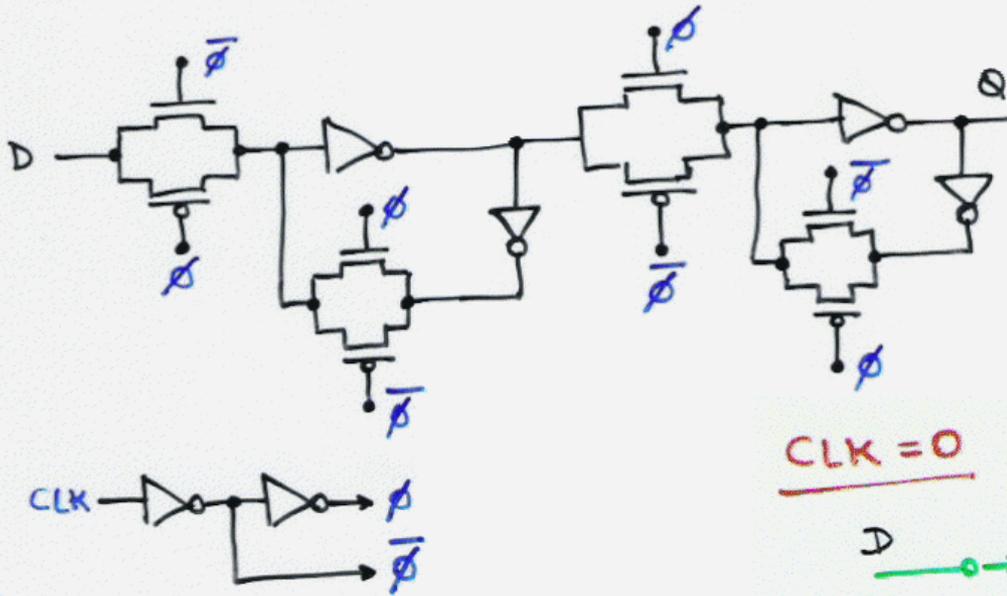


Dado el muy bajo consumo, se tiene la posibilidad de "colgar" compuertas alimentadas de otras.

Esto permite por ejemplo hacer una Or-Exclusiva.

El segundo inversor está alimentado de la entrada A y de la salida del primer inversor (puntos rojos)

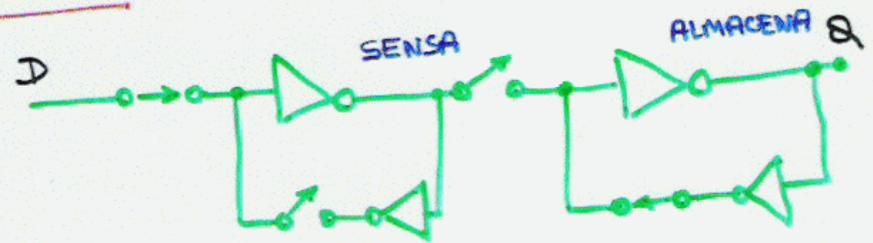
FLIP-FLOP TIPO D disparado por flanco ascendente



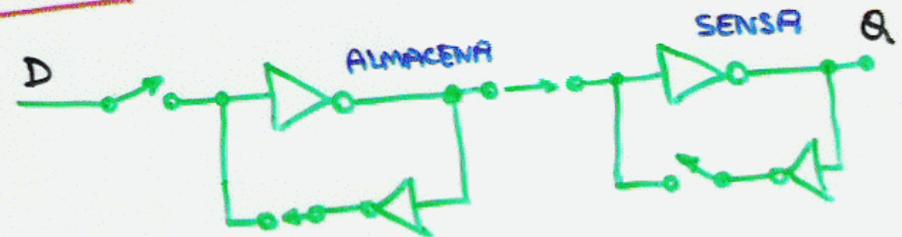
Implementación de un FF tipo "D" disparado por flanco ascendente.

Tiene una configuración tipo master-salve, es decir, dos bloques idénticos que se activan con niveles de tensión diferentes de CLK.

CLK = 0

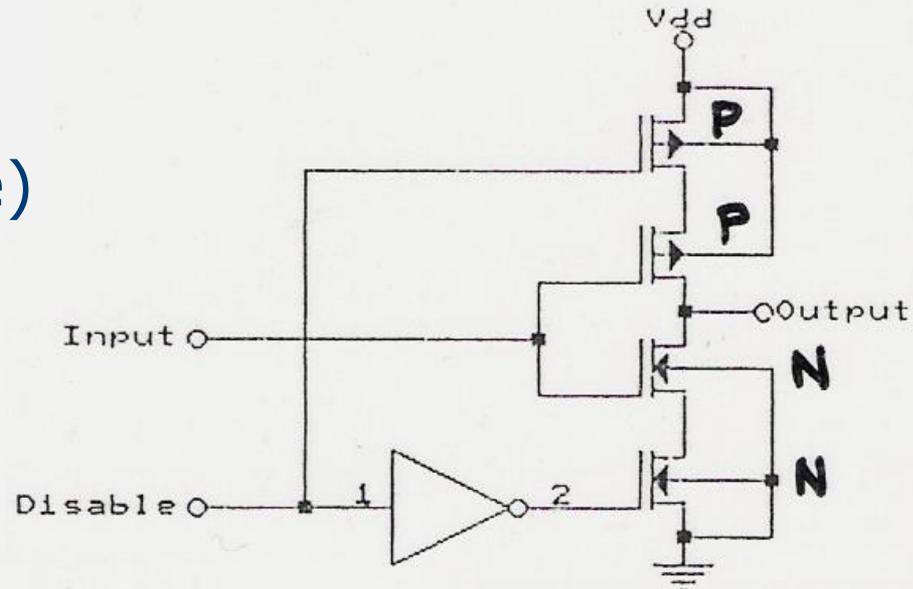


CLK = 1

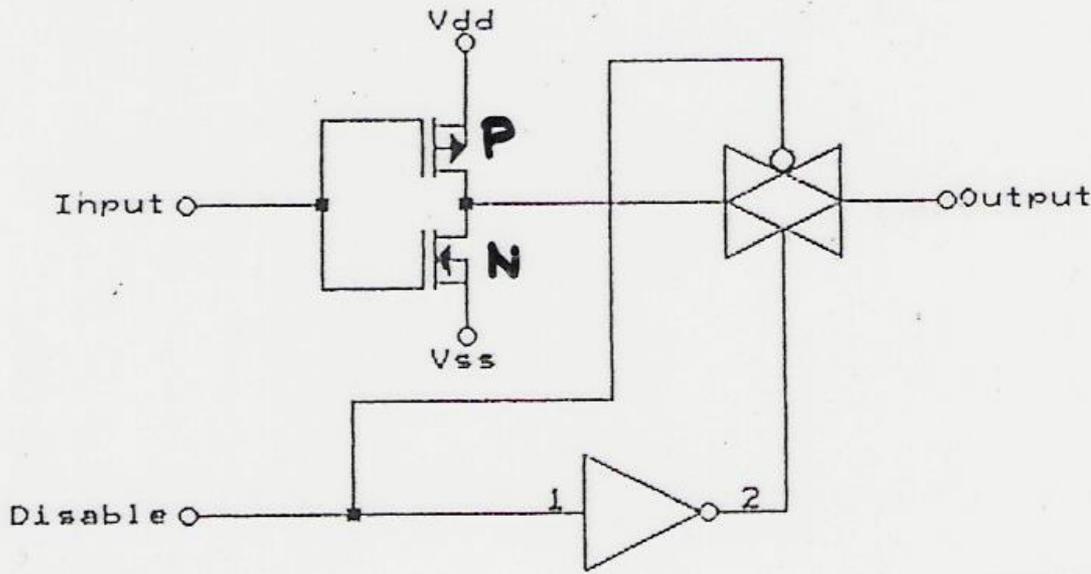


Cómo se puede hacer uno que sea sensible al otro flanco..??

Dos posibilidades para lograr compuertas con tercer estado (tri-state)



**DISABLE = 0 → CONDUCE**  
**DISABLE = 1 → OFF**





alta capacidad de corriente

## MC14001B Series

### B-Suffix Series CMOS Gates

MC14001B, MC14011B, MC14023B,  
MC14025B, MC14071B, MC14073B,  
MC14081B, MC14082B

The B Series logic gates are constructed with P and N channel enhancement mode devices in a single monolithic structure (Complementary MOS). Their primary use is where low power dissipation and/or high noise immunity is desired.

- Supply Voltage Range = 3.0 Vdc to 18 Vdc
- All Outputs Buffered
- Capable of Driving Two Low-power TTL Loads or One Low-power Schottky TTL Load Over the Rated Temperature Range.
- Double Diode Protection on All Inputs Except: Triple Diode Protection on MC14011B and MC14081B
- Pin-for-Pin Replacements for Corresponding CD4000 Series B Suffix Devices

Characteristic	Symbol	V <sub>DD</sub> Vdc	- 55°C		25°C			125°C		Unit	
			Min	Max	Min	Typ <sup>(3)</sup>	Max	Min	Max		
Output Voltage V <sub>in</sub> = V <sub>DD</sub> or 0	"0" Level	V <sub>OL</sub>	5.0	—	0.05	—	0	0.05	—	0.05	Vdc
			10	—	0.05	—	0	0.05	—	0.05	
			15	—	0.05	—	0	0.05	—	0.05	
	"1" Level	V <sub>OH</sub>	5.0	4.95	—	4.95	5.0	—	4.95	—	
			10	9.95	—	9.95	10	—	9.95	—	
			15	14.95	—	14.95	15	—	14.95	—	
Input Voltage (V <sub>O</sub> = 4.5 or 0.5 Vdc) (V <sub>O</sub> = 9.0 or 1.0 Vdc) (V <sub>O</sub> = 13.5 or 1.5 Vdc)	"0" Level	V <sub>IL</sub>	5.0	—	1.5	—	2.25	1.5	—	1.5	Vdc
			10	—	3.0	—	4.50	3.0	—	3.0	
			15	—	4.0	—	6.75	4.0	—	4.0	
	"1" Level	V <sub>IH</sub>	5.0	3.5	—	3.5	2.75	—	3.5	—	
			10	7.0	—	7.0	5.50	—	7.0	—	
			15	11	—	11	8.25	—	11	—	
Output Drive Current (V <sub>OH</sub> = 2.5 Vdc) (V <sub>OH</sub> = 4.6 Vdc) (V <sub>OH</sub> = 9.5 Vdc) (V <sub>OH</sub> = 13.5 Vdc)	Source	I <sub>OH</sub>	5.0	-3.0	—	-2.4	-4.2	—	-1.7	—	mAdc
			5.0	-0.64	—	-0.51	-0.88	—	-0.36	—	
			10	-1.6	—	-1.3	-2.25	—	-0.9	—	
	Sink	I <sub>OL</sub>	5.0	0.64	—	0.51	0.88	—	0.36	—	
			10	1.6	—	1.3	2.25	—	0.9	—	
			15	4.2	—	3.4	8.8	—	2.4	—	
Input Current	I <sub>in</sub>	15	—	± 0.1	—	± 0.00001	± 0.1	—	± 1.0	μAdc	
Input Capacitance (V <sub>in</sub> = 0)	C <sub>in</sub>	—	—	—	—	5.0	7.5	—	—	pF	
Quiescent Current (Per Package)	I <sub>DD</sub>	5.0	—	0.25	—	0.0005	0.25	—	7.5	μAdc	
		10	—	0.5	—	0.0010	0.5	—	15		
		15	—	1.0	—	0.0015	1.0	—	30		
Total Supply Current <sup>(4),(5)</sup> (Dynamic plus Quiescent, Per Gate, C <sub>L</sub> = 50 pF)	I <sub>T</sub>	5.0	I <sub>T</sub> = (0.3 μA/kHz) f + I <sub>DD</sub> /N							μAdc	
10	I <sub>T</sub> = (0.6 μA/kHz) f + I <sub>DD</sub> /N										
15	I <sub>T</sub> = (0.9 μA/kHz) f + I <sub>DD</sub> /N										

En el mejor de los casos, esta compuerta puede alimentar a sólo dos cargas TTL.

Pero puede alimentar a miles de cargas CMOS (la entrada consume 1 pA). El límite práctico lo impone la parte dinámica ya que cada carga equivale a una capacidad de 5 pF lo que va haciendo a la salida cada vez mas lenta.

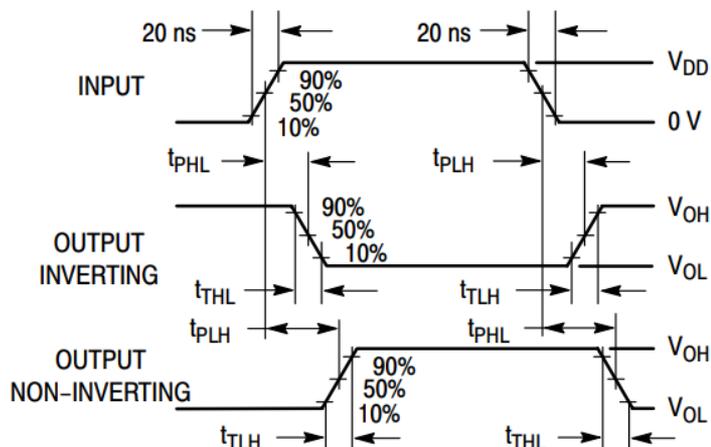
**Como todo dispositivo CMOS: La corriente de alimentación I<sub>T</sub> (o la potencia P<sub>T</sub> = I<sub>T</sub>\*V<sub>DD</sub>) depende de la frecuencia de operación.**

## MC14001B Series

## B-SERIES GATE SWITCHING TIMES

SWITCHING CHARACTERISTICS <sup>(6.)</sup> ( $C_L = 50$  pF,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

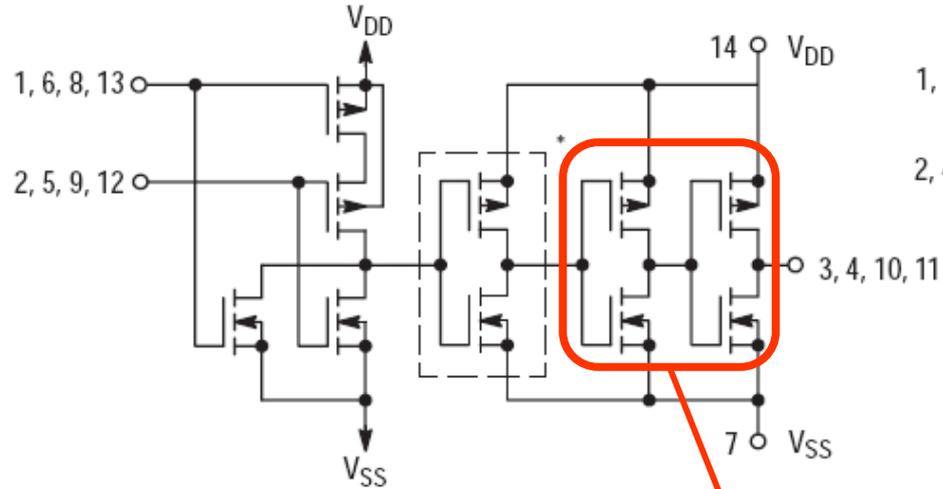
Characteristic	Symbol	$V_{DD}$ Vdc	Min	Typ <sup>(7.)</sup>	Max	Unit
Output Rise Time, All B-Series Gates $t_{TLH} = (1.35 \text{ ns/pF}) C_L + 33 \text{ ns}$ $t_{TLH} = (0.60 \text{ ns/pF}) C_L + 20 \text{ ns}$ $t_{TLH} = (0.40 \text{ ns/pF}) C_L + 20 \text{ ns}$	$t_{TLH}$	5.0 10 15	— — —	100 50 40	200 100 80	ns
Output Fall Time, All B-Series Gates $t_{THL} = (1.35 \text{ ns/pF}) C_L + 33 \text{ ns}$ $t_{THL} = (0.60 \text{ ns/pF}) C_L + 20 \text{ ns}$ $t_{THL} = (0.40 \text{ ns/pF}) C_L + 20 \text{ ns}$	$t_{THL}$	5.0 10 15	— — —	100 50 40	200 100 80	ns
Propagation Delay Time MC14001B, MC14011B only $t_{PLH}, t_{PHL} = (0.90 \text{ ns/pF}) C_L + 80 \text{ ns}$ $t_{PLH}, t_{PHL} = (0.36 \text{ ns/pF}) C_L + 32 \text{ ns}$ $t_{PLH}, t_{PHL} = (0.26 \text{ ns/pF}) C_L + 27 \text{ ns}$ All Other 2, 3, and 4 Input Gates $t_{PLH}, t_{PHL} = (0.90 \text{ ns/pF}) C_L + 115 \text{ ns}$ $t_{PLH}, t_{PHL} = (0.36 \text{ ns/pF}) C_L + 47 \text{ ns}$ $t_{PLH}, t_{PHL} = (0.26 \text{ ns/pF}) C_L + 37 \text{ ns}$ 8-Input Gates (MC14068B, MC14078B) $t_{PLH}, t_{PHL} = (0.90 \text{ ns/pF}) C_L + 155 \text{ ns}$ $t_{PLH}, t_{PHL} = (0.36 \text{ ns/pF}) C_L + 62 \text{ ns}$ $t_{PLH}, t_{PHL} = (0.26 \text{ ns/pF}) C_L + 47 \text{ ns}$	$t_{PLH}, t_{PHL}$	5.0 10 15	— — —	125 50 40	250 100 80	ns



Generalmente se especifican los retardos considerando que la salida es cargada con 50 pF, lo que equivale a unas 10 entradas CMOS.

A mayor  $V_{DD}$  menor será el retardo.  
Para 15 V se obtiene la mayor velocidad.

**MC14001B, MC14071B**  
One of Four Gates Shown

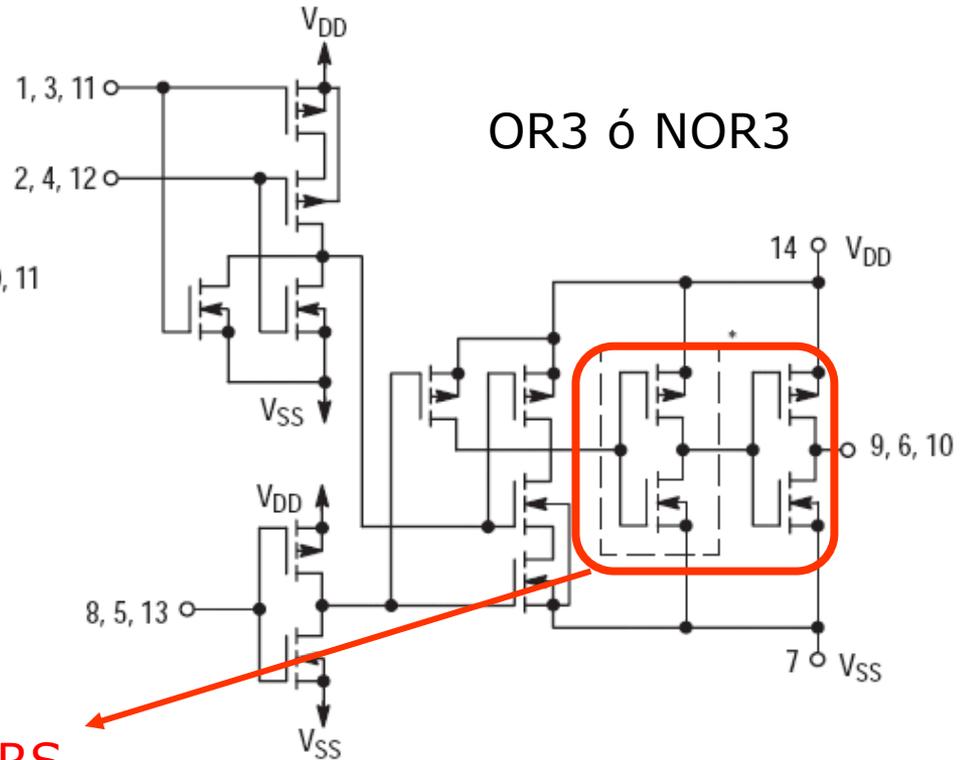


\*Inverter omitted in MC14001B

OR2 ó NOR2

**BUFFERS**

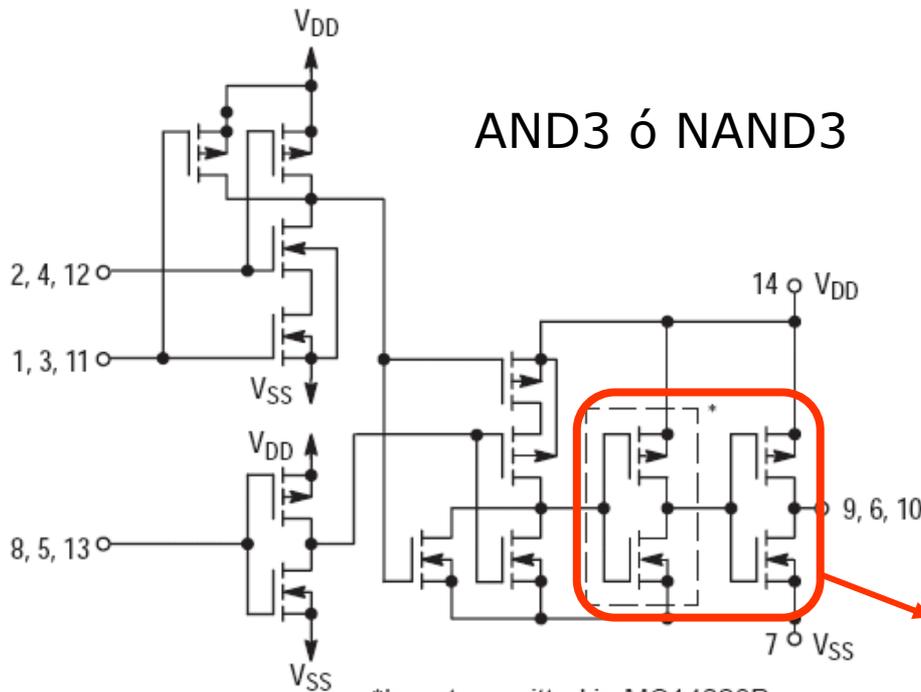
**MC14025B**  
One of Three Gates Shown



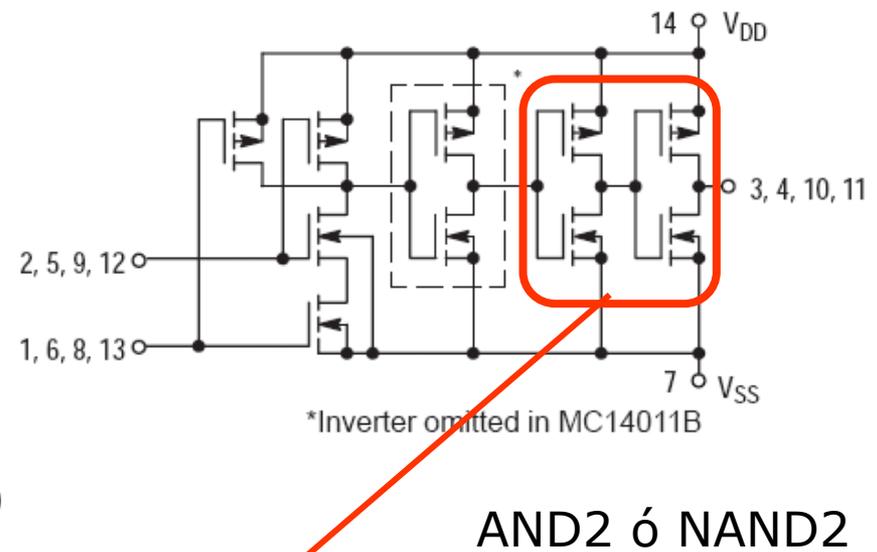
OR3 ó NOR3

\*Inverter omitted in MC14025B

**MC14023B, MC14073B**  
One of Three Gates Shown



**MC14011B, MC14081B**  
One of Four Gates Shown



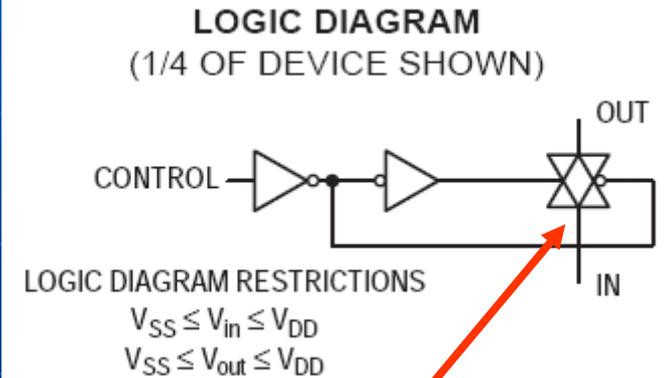
**BUFFERS**

## MC14016B

### Quad Analog Switch/ Quad Multiplexer

The MC14016B quad bilateral switch is constructed with MOS P-channel and N-channel enhancement mode devices in a single monolithic structure. Each MC14016B consists of four independent switches capable of controlling either digital or analog signals. The quad bilateral switch is used in signal gating, chopper, modulator, demodulator and CMOS logic implementation.

- Diode Protection on All Inputs
- Supply Voltage Range = 3.0 Vdc to 18 Vdc
- Linearized Transfer Characteristics
- Low Noise —  $12 \text{ nV}/\sqrt{\text{Cycle}}$ ,  $f \geq 1.0 \text{ kHz}$  typical
- Pin-for-Pin Replacements for CD4016B, CD4066B (Note improved transfer characteristic design causes more parasitic coupling capacitance than CD4016)
- For Lower  $R_{ON}$ , Use The HC4016 High-Speed CMOS Device or The MC14066B
- This Device Has Inputs and Outputs Which Do Not Have ESD Protection. Antistatic Precautions Must Be Taken.



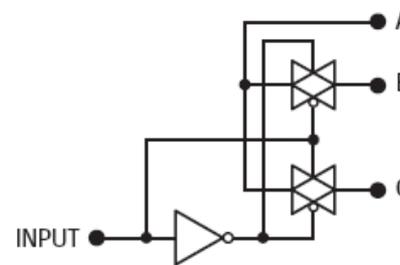
Compuerta pass-gate

## MC14007UB

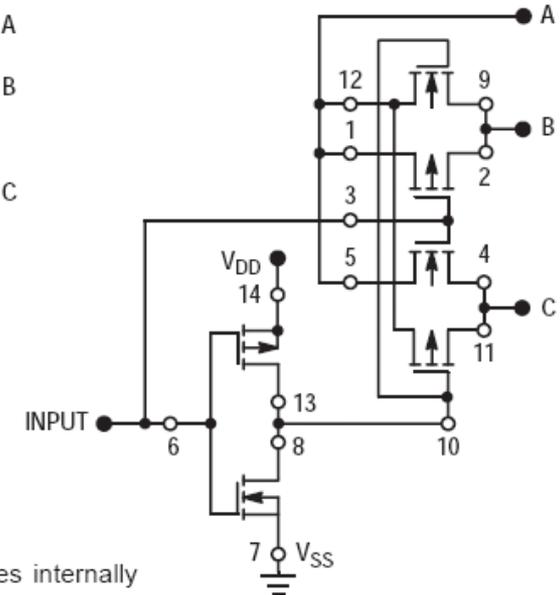
### Dual Complementary Pair Plus Inverter

The MC14007UB multi-purpose device consists of three N-channel and three P-channel enhancement mode devices packaged to provide access to each device. These versatile parts are useful in inverter circuits, pulse-shapers, linear amplifiers, high input impedance amplifiers, threshold detectors, transmission gating, and functional gating.

- Diode Protection on All Inputs
- Supply Voltage Range = 3.0 Vdc to 18 Vdc
- Capable of Driving Two Low-power TTL Loads or One Low-power Schottky TTL Load Over the Rated Temperature Range
- Pin-for-Pin Replacement for CD4007A or CD4007UB
- This device has 2 outputs without ESD Protection. Anti-static precautions must be taken.



INPUT	OUTPUT CONDITION
1	A = C, B = OPEN
0	A = B, C = OPEN



Substrates of P-channel devices internally connected to  $V_{DD}$ ; substrates of N-channel devices internally connected to  $V_{SS}$ .

## Lógica CMOS de alta velocidad

### Serie 74XX

Es la mas nueva y actual de CMOS.

Sus mayores ventajas son:

Bajo consumo respecto a las versiones de TTL LPS (Low Power Schottky).

Mayor inmunidad al ruido.

Rango de tensiones de alimentación medio (3 V a 6 V).

Velocidad comparable a TTL LS (depende de las versiones).

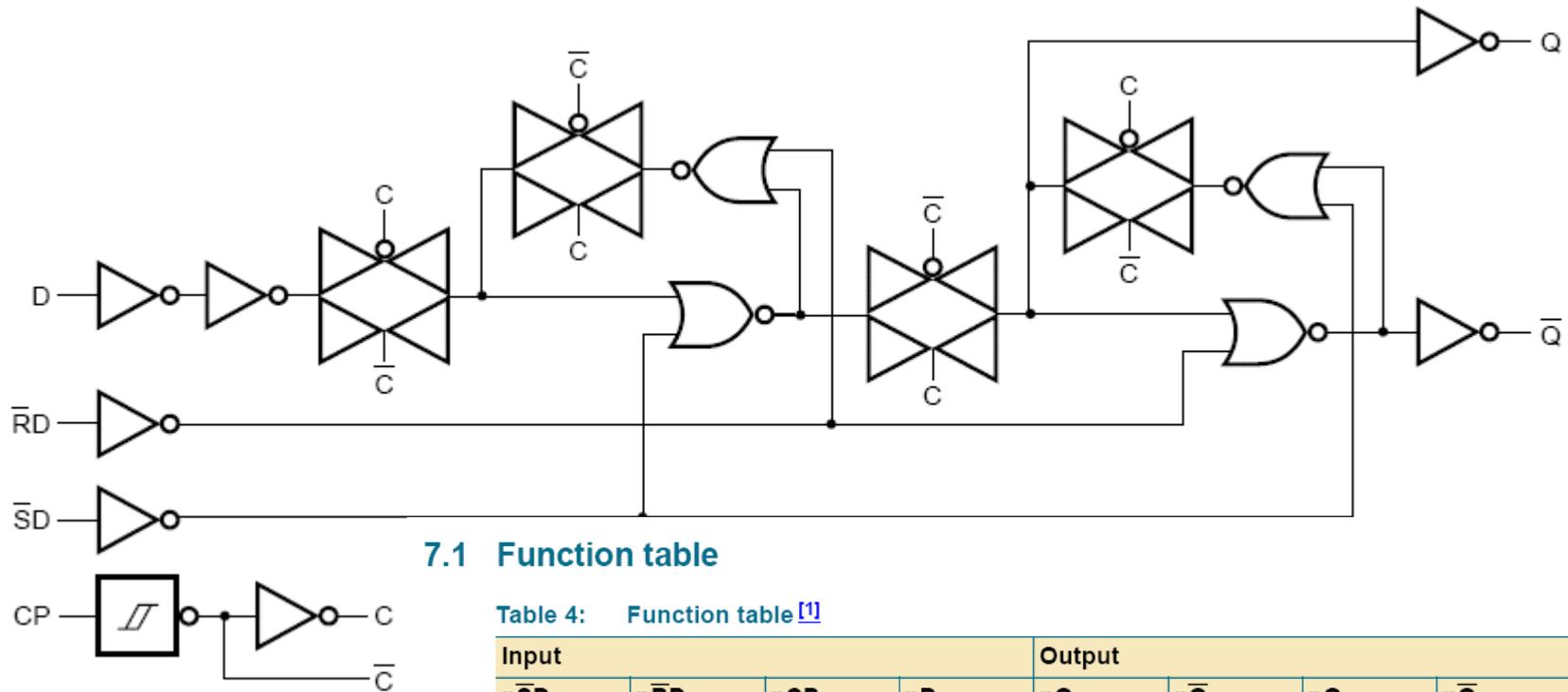
En la actualidad tenemos varias versiones:

74HC y 74AC (compatibles con CMOS con rango reducido de  $V_{cc}$ ).

74HCT y 74ACT (compatibles con TTL en 5 Volts)

Versiones de baja tensión (74AHC, 74LCX, 74LVX, 74ALCX, etc.)

**NOTA: Las denominaciones cambian dependiendo del fabricante.**



## 7.1 Function table

Table 4: Function table [1]

Input				Output			
$n\bar{S}D$	$n\bar{R}D$	$nCP$	$nD$	$nQ$	$n\bar{Q}$	$nQ_{n+1}$	$n\bar{Q}_{n+1}$
L	H	X	X	H	L	L	H
H	L	X	X	L	H	H	L
L	L	X	X	H	H	-	-
H	H	$\uparrow$	L	-	-	L	H
H	H	$\uparrow$	H	-	-	H	L

- [1] H = HIGH voltage level;  
 L = LOW voltage level;  
 $\uparrow$  = LOW-to-HIGH transition;  
 $Q_{n+1}$  = state after the next LOW-to-HIGH CP transition;  
 X = don't care.

FLIP-FLOP TIPO "D"  
 sensible a flanco  
 ascendente con  
 entradas de set y reset



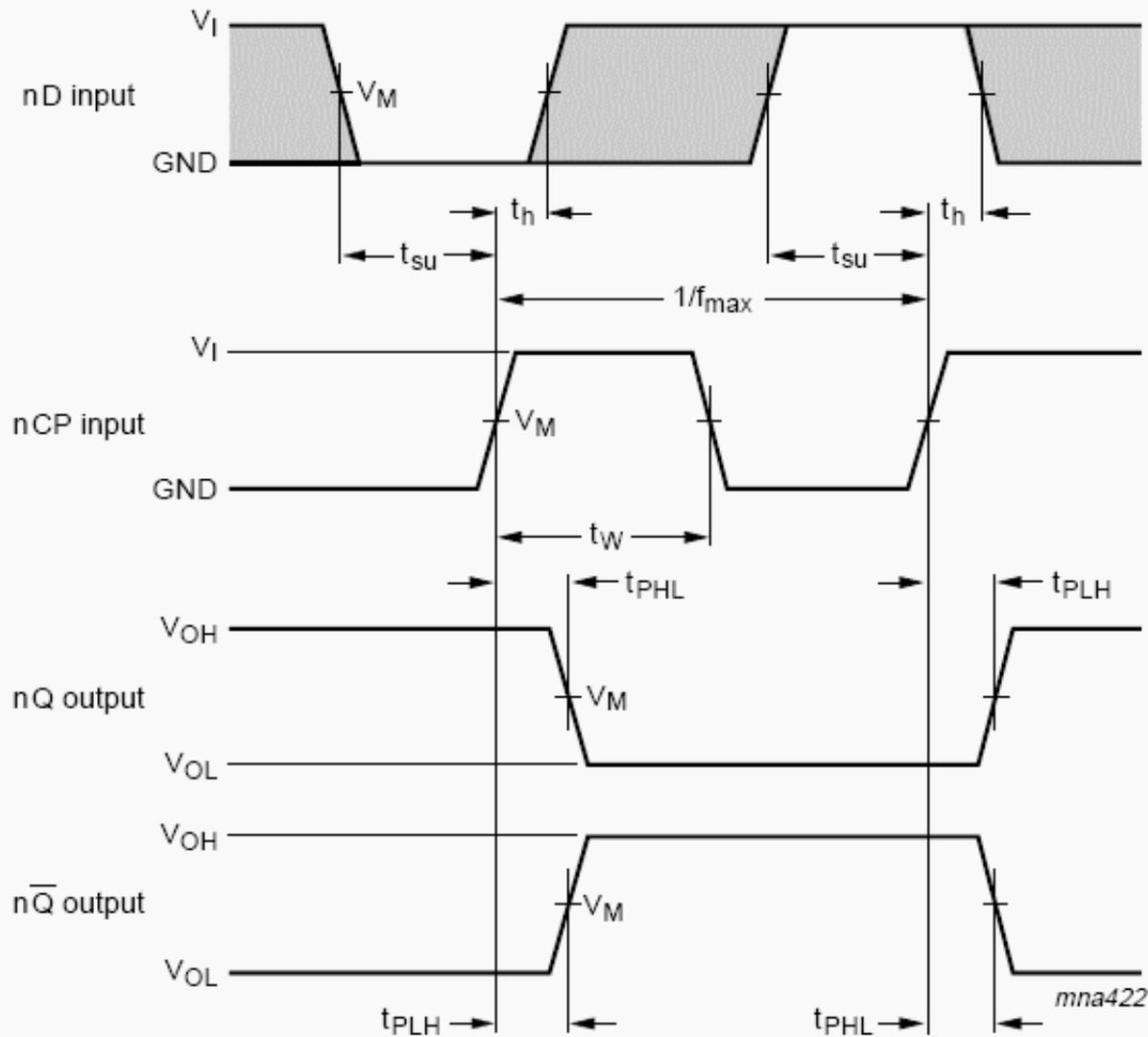




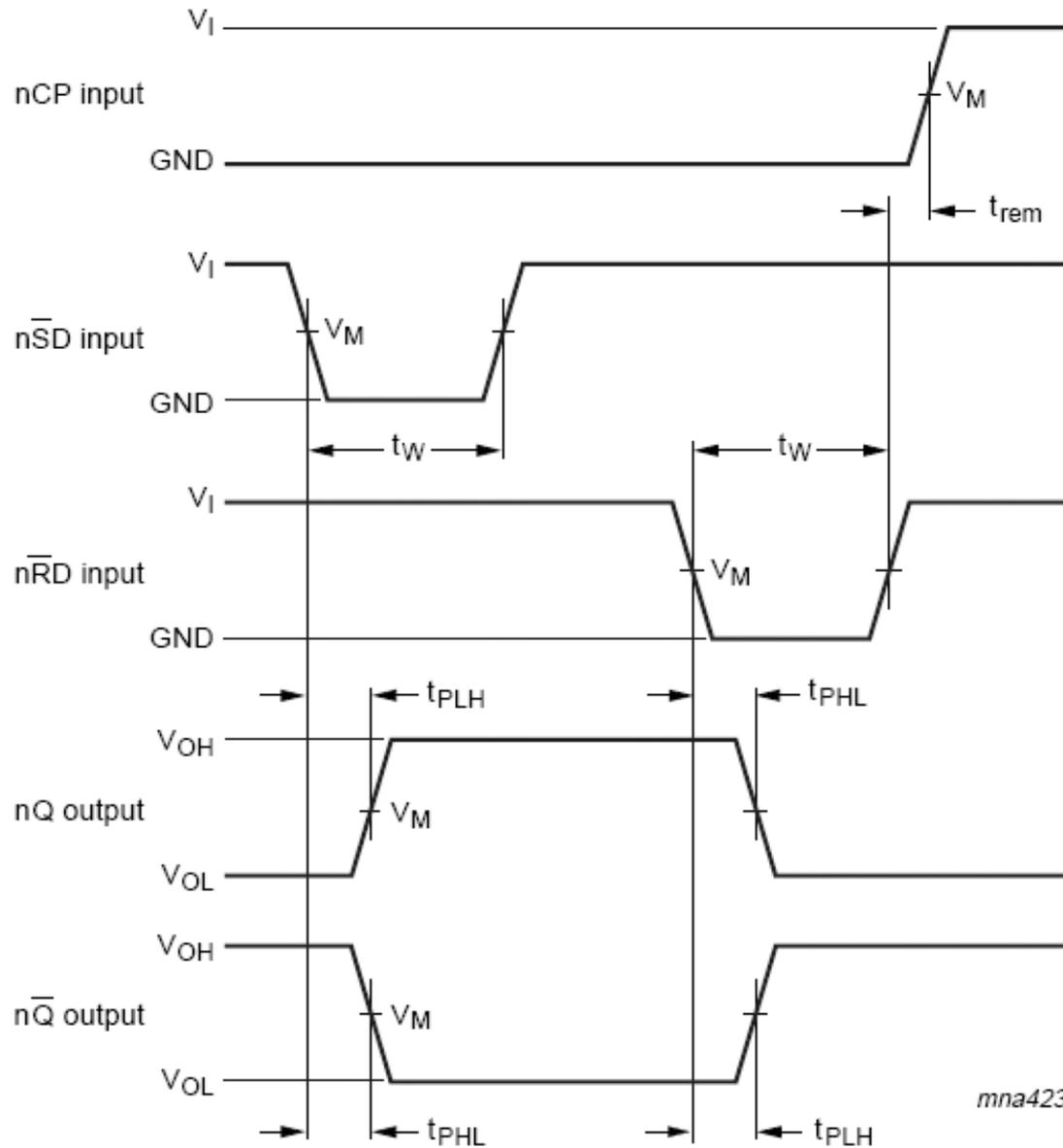
Symbol	Parameter	Test conditions	Min	Typ	Max	Unit	
$T_{amb} = 25\text{ °C}$ [1]							
$t_{PHL}, t_{PLH}$	propagation delay nCP to nQ, n $\bar{Q}$	$V_{CC} = 3.0\text{ V to }3.6\text{ V}$ ; see <a href="#">Figure 7</a>					
		$C_L = 15\text{ pF}$	-	5.2	11.9	ns	
		$C_L = 50\text{ pF}$	-	7.4	15.4	ns	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V to }5.5\text{ V}$ ; see <a href="#">Figure 7</a>					
		$C_L = 15\text{ pF}$	-	3.7	7.3	ns	
		$C_L = 50\text{ pF}$	-	5.2	9.3	ns	
	n $\bar{S}D$ , n $\bar{R}D$ to nQ, n $\bar{Q}$	$V_{CC} = 3.0\text{ V to }3.6\text{ V}$ ; see <a href="#">Figure 8</a>					
		$C_L = 15\text{ pF}$	-	5.4	12.3	ns	
		$C_L = 50\text{ pF}$	-	7.7	15.8	ns	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V to }5.5\text{ V}$ ; see <a href="#">Figure 8</a>					
$C_L = 15\text{ pF}$		-	3.7	7.7	ns		
$C_L = 50\text{ pF}$		-	5.3	9.7	ns		
$f_{max}$	maximum clock pulse frequency	$V_{CC} = 3.0\text{ V to }3.6\text{ V}$ ; see <a href="#">Figure 7</a>					
		$C_L = 15\text{ pF}$	80	125	-	MHz	
		$C_L = 50\text{ pF}$	50	75	-	MHz	
		$V_{CC} = 4.5\text{ V to }5.5\text{ V}$ ; see <a href="#">Figure 7</a>					
		$C_L = 15\text{ pF}$	130	170	-	MHz	
		$C_L = 50\text{ pF}$	90	115	-	MHz	
$t_w$	pulse width	$C_L = 50\text{ pF}$ ; see <a href="#">Figure 7</a>	$V_{CC} = 3.0\text{ V to }3.6\text{ V}$	6.0	-	-	ns
			$V_{CC} = 4.5\text{ V to }5.5\text{ V}$	5.0	-	-	ns
	set or reset pulse LOW	$C_L = 50\text{ pF}$ ; see <a href="#">Figure 8</a>	$V_{CC} = 3.0\text{ V to }3.6\text{ V}$	6.0	-	-	ns
			$V_{CC} = 4.5\text{ V to }5.5\text{ V}$	5.0	-	-	ns

Hay anchos mínimos de pulso que se deben respetar

## Diagramas de tiempo: Salidas vs. reloj



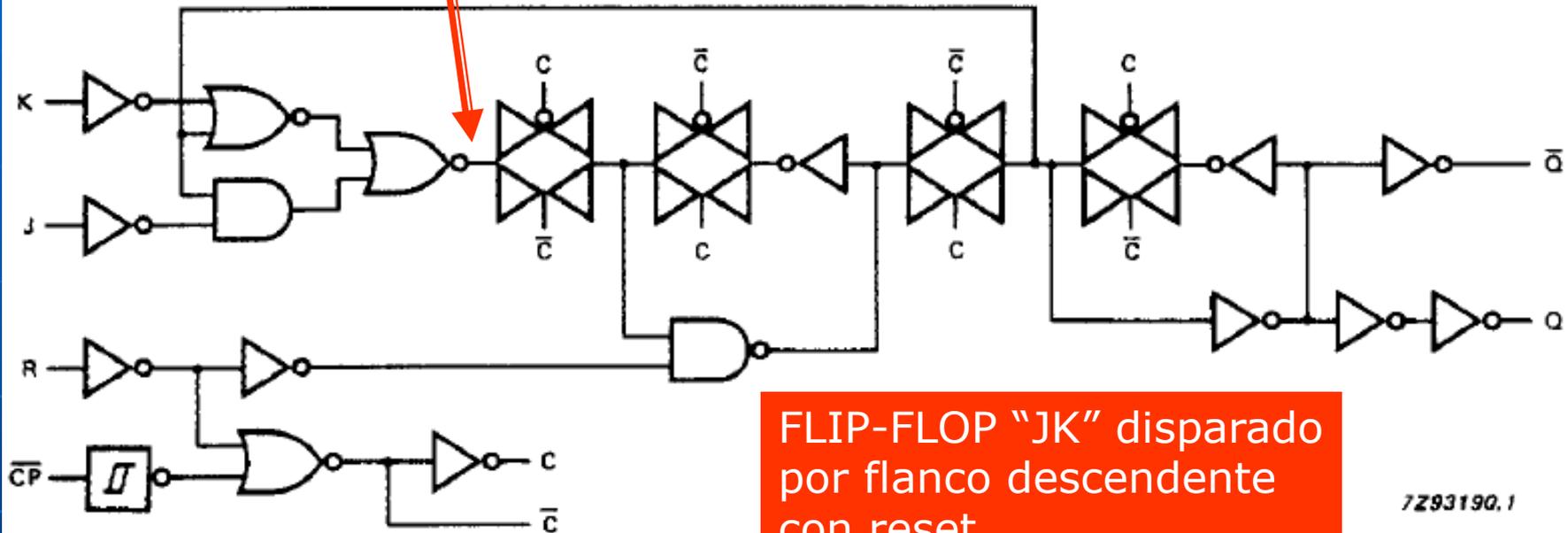
Diagramas de tiempo:  
Salidas vs. entradas  
asincrónicas



$$P = (\overline{J} \cdot \overline{Q}) + (\overline{\overline{K} + \overline{Q}})$$

### 74HC/HCT107

Dual JK flip-flop with reset;  
negative-edge trigger



7293190.1

Si  $J = \overline{K} \Rightarrow P = (\overline{J} \cdot \overline{Q}) + (\overline{\overline{K} + \overline{Q}}) = (J + Q) \cdot (J + \overline{Q}) = J$  (Funciona como "D")

Si  $J = K \Rightarrow P = (\overline{J} \cdot \overline{Q}) + (\overline{\overline{J} + \overline{Q}}) = (J + Q) \cdot (\overline{J} + \overline{Q}) = J \oplus Q$  (Funciona como "T")

## AC CHARACTERISTICS FOR 74HC

GND = 0 V;  $t_r = t_f = 6$  ns;  $C_L = 50$  pF

SYMBOL	PARAMETER	$T_{amb}$ (°C)						UNIT	TEST CONDITIONS		
		74HC							$V_{CC}$ (V)	WAVEFORMS	
		+25			-40 to +85		-40 to +125				
		min.	typ.	max.	min.	max.	min.				max.
$t_{PHL}/t_{PLH}$	propagation delay $n\overline{CP}$ to nQ		52 19 15	160 32 27		200 40 34		240 48 41	ns	2.0 4.5 6.0	Fig.6
$t_{PHL}/t_{PLH}$	propagation delay $n\overline{CP}$ to $n\overline{Q}$		52 19 15	160 32 27		200 40 34		240 48 41	ns	2.0 4.5 6.0	Fig.6
$t_{PHL}/t_{PLH}$	propagation delay $n\overline{R}$ to nQ, $n\overline{Q}$		52 19 15	155 31 26		195 39 33		235 47 40	ns	2.0 4.5 6.0	Fig.7
$t_{THL}/t_{TLH}$	output transition time		19 7 6	75 15 13		95 19 16		110 22 19	ns	2.0 4.5 6.0	Fig.6
$t_w$	clock pulse width HIGH or LOW	80 16 14	22 8 6		100 20 17		120 24 20		ns	2.0 4.5 6.0	Fig.6
$t_w$	reset pulse width LOW	80 16 14	22 8 6		100 20 17		120 24 20		ns	2.0 4.5 6.0	Fig.7
$t_{rem}$	removal time $n\overline{R}$ to $n\overline{CP}$	60 12 10	19 7 6		75 15 13		90 18 15		ns	2.0 4.5 6.0	Fig.7
$t_{su}$	set-up time nJ, nK to $n\overline{CP}$	100 20 17	22 8 6		125 25 21		150 30 26		ns	2.0 4.5 6.0	Fig.6
$t_h$	hold time nJ, nK to $n\overline{CP}$	3 3 3	-6 -2 -2		3 3 3		3 3 3		ns	2.0 4.5 6.0	Fig.6
$f_{max}$	maximum clock pulse frequency	6.0 30 35	23 70 85		4.8 24 28		4.0 20 24		MHz	2.0 4.5 6.0	Fig.6

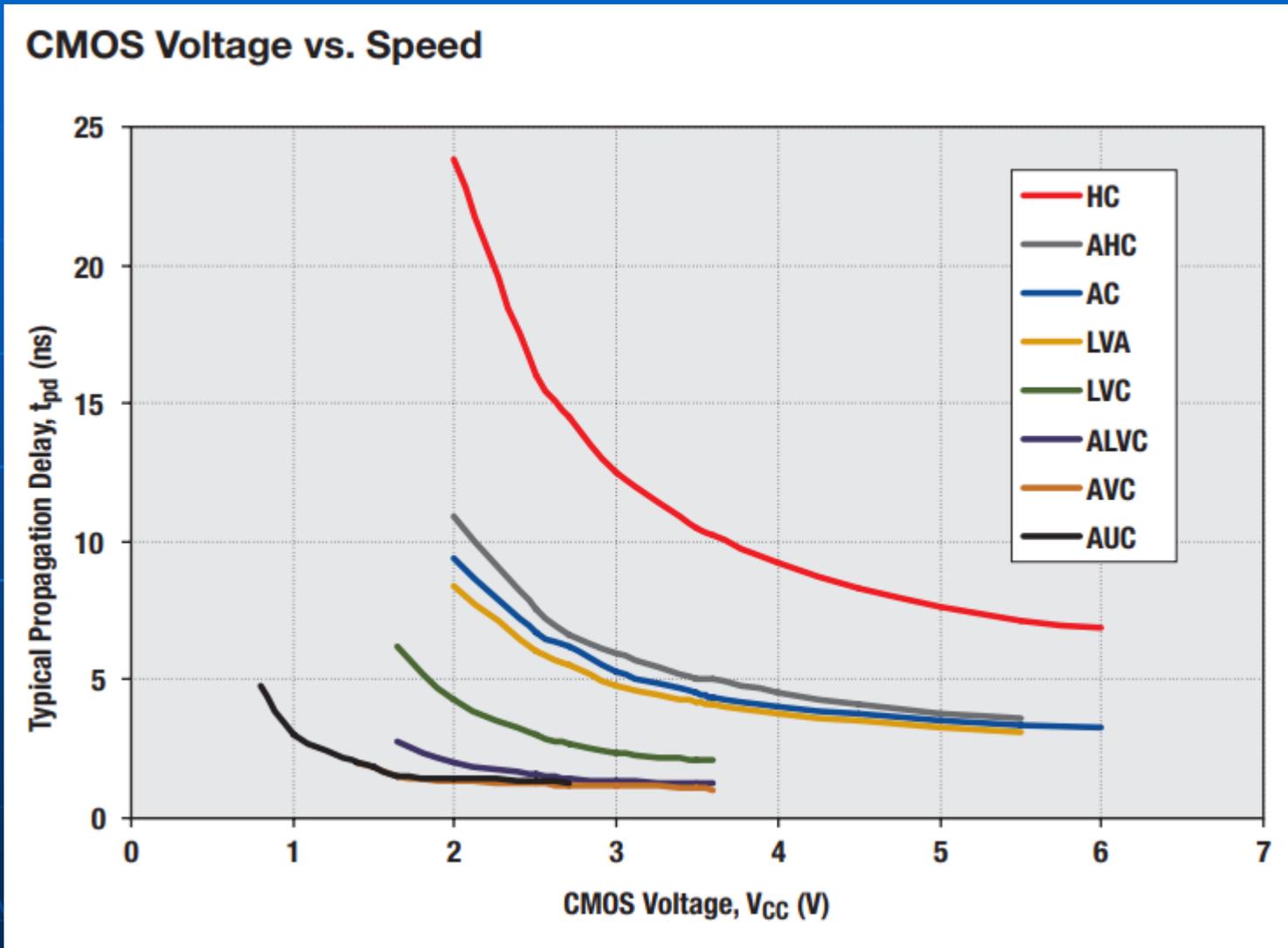
## FUNCTION TABLE

OPERATING MODE	INPUTS				OUTPUTS	
	$n\bar{R}$	$n\bar{CP}$	J	K	Q	$\bar{Q}$
asynchronous reset	L	X	X	X	L	H
toggle	H	↓	h	h	$\bar{q}$	q
load "0" (reset)	H	↓	l	h	L	H
load "1" (set)	H	↓	h	l	H	L
hold "no change"	H	↓	l	l	q	$\bar{q}$

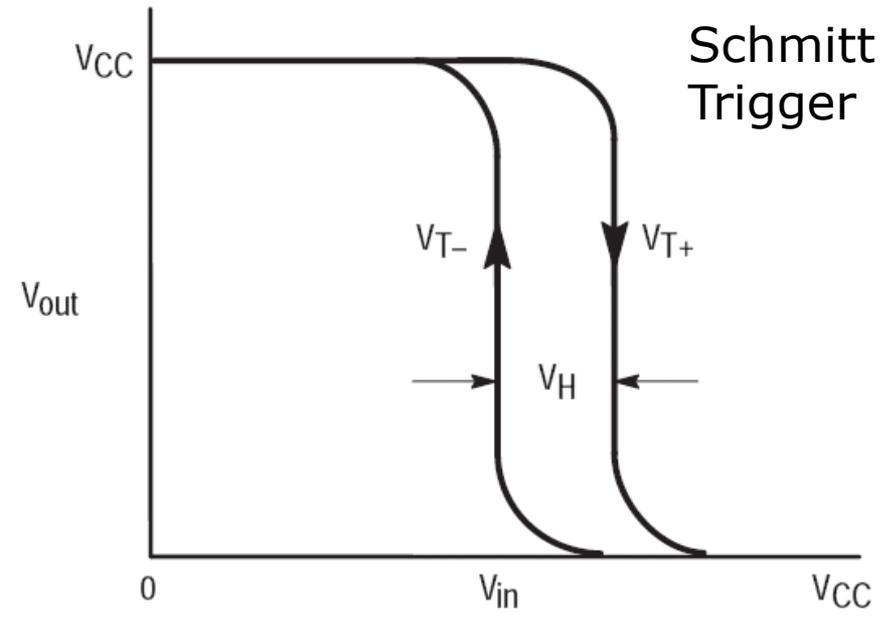
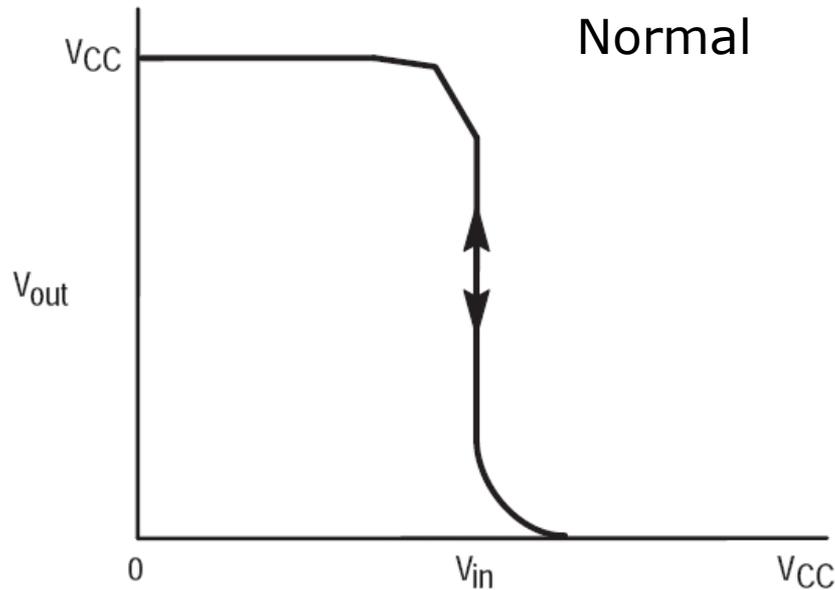
## Note

- H = HIGH voltage level  
 h = HIGH voltage level one set-up time prior to the HIGH-to-LOW CP transition  
 L = LOW voltage level  
 l = LOW voltage level one set-up time prior to the HIGH-to-LOW CP transition  
 q = lower case letters indicate the state of the referenced output one set-up time prior to the HIGH-to-LOW CP transition  
 X = don't care  
 ↓ = HIGH-to-LOW CP transition

## Comparación de velocidad vs. tensión de alimentación (Vdd)



## Función de transferencia compuertas Schmitt-Trigger

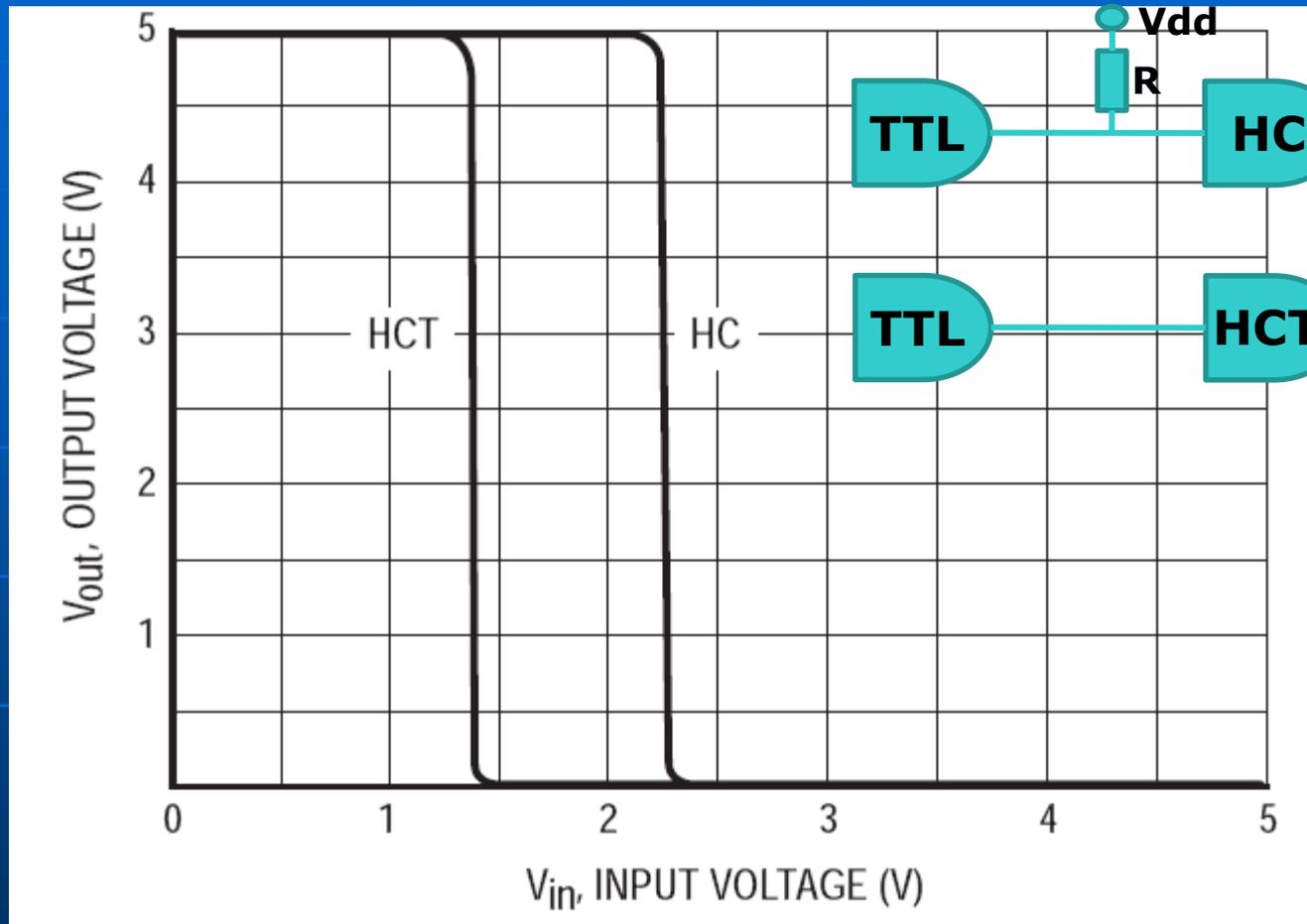


A diferencia de un circuito de entrada normal, en Schmitt trigger existen dos umbrales de tensión. Esto permite mayor inmunidad al ruido al existir una histéresis ( $V_H$ ) y suele utilizarse en casos donde por ejemplo se quiera detectar una señal de reloj que pueda contener ruido.

Si por ejemplo la señal de entrada es "0", la salida vale  $V_{CC}$ . Debe superar  $V_{T+}$  para que la salida cambie a "0".

Y si estando la entrada en "1" se requiere que la salida pase nuevamente a "1", deberá bajar por debajo de  $V_{T-}$ .

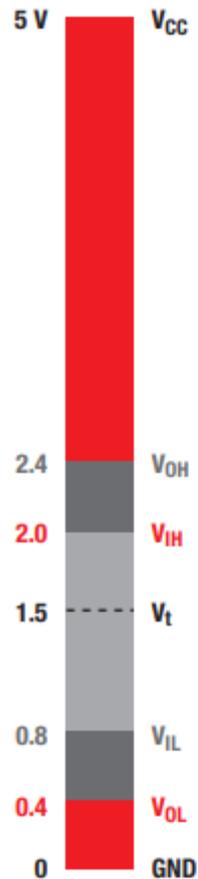
## Función de transferencia series HC y HCT



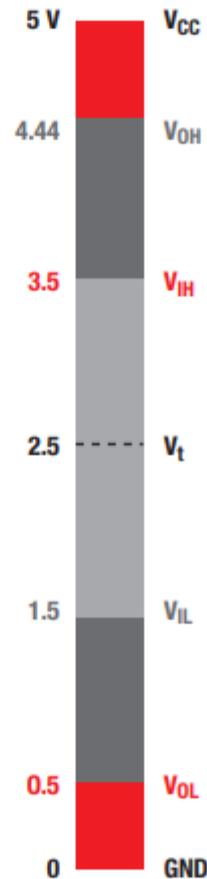
HCT es una versión CMOS que compatibiliza los niveles de tensiones de entrada como TTL, lo que permite conectar a una salida TTL una entrada CMOS 74HCT de igual tensión de alimentación.

# Familias Lógicas

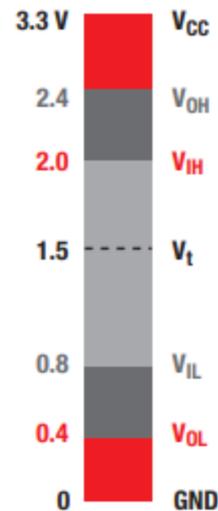
## Rango de tensiones de operación



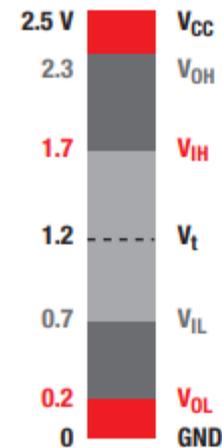
**5-V TTL**  
Standard TTL: ABT,  
AHCT, HCT, ACT,  
bipolar, LV1T, LV4T



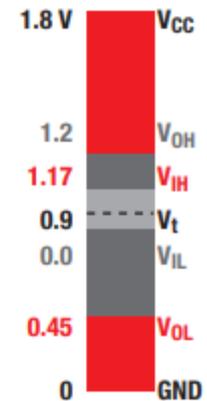
**5-V CMOS**  
Rail-to-Rail 5 V  
HC, AHC, AC, LV-A,  
LV1T, LV4T



**3.3-V LVTTTL**  
LVT, LV1T, LV4T,  
LVC, ALVC, AUP,  
LV-A, ALVT



**2.5-V CMOS**  
AUC, AUP, AVC,  
ALVC, LVC, ALVT,  
LV1T, LV4T



**1.8-V CMOS**  
AUC, AUP, AVC,  
ALVC, LVC,  
LV1T, LV4T

### Tecnología ECL

#### Tecnología ECL

Ventaja: Velocidad y margen de ruido

Desventaja: Fuente negativa de tensión (-5.2V) y elevado Consumo.

#### Tecnología PECL

Ventaja: Fuente positiva (desplazada a +5V).

Mantiene características de ECL (swing de 800mV)

#### Tecnología LVPECL

Ventaja: Fuente de +3.3V. Mejora la velocidad de respuesta.

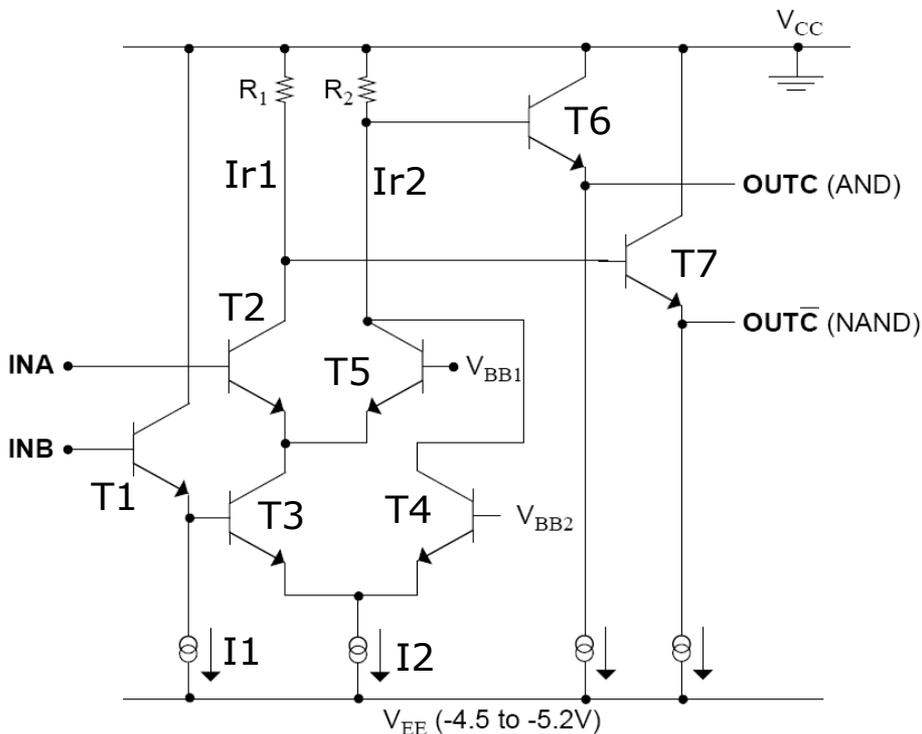
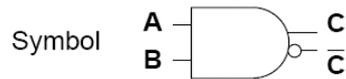
Suele emplearse en el diseño de componentes no muy complejos por su excesivo consumo, por ejemplo en drivers y receptores de comunicaciones seriales en velocidades que superan los 10Gbps (ejemplo en enlaces de fibras ópticas).

Para enlaces de muy alta velocidad es una opción mas viable que LVDS ("Low Voltage Differential Signaling" que usa tecnología CMOS) y similar a CML ("Current Mode Logic" que usa tecnología BIPOLAR-CMOS).

## Familias Lógicas

## Tecnología ECL

## Compuerta AND-NAND en ECL



Todos los transistores en un circuito ECL trabajan en zona ACTIVA.

Las entradas INA e INAB presentan un "1" si están más cerca de  $V_{cc}=0V$  (ej.  $-1,0 V$ ) y un "0" si están cerca de  $V_{ee}=-5V$  (ej.  $-1,6V$ ). T4 y T5 están polarizados en directa.

El generador de corriente I2 se encarga de mantener constante la corriente que circula por T3 y T4.

T2 y T3 están formando una rama y dependen de las tensiones de sus bases que son las entradas de la compuerta.

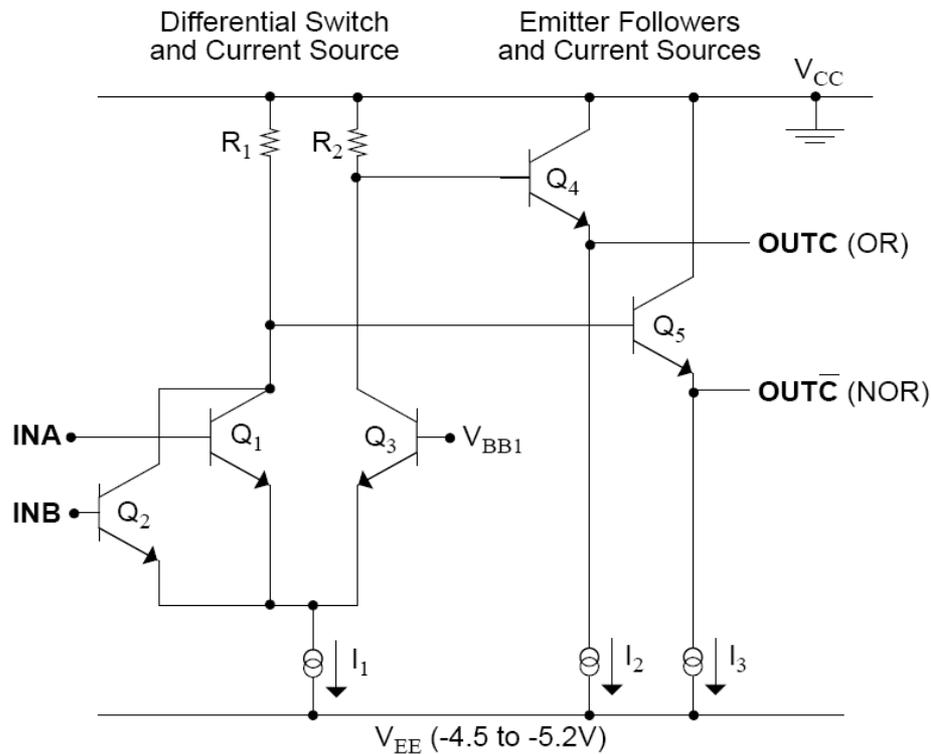
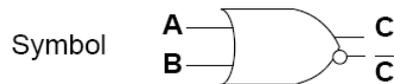
Si las tensiones INA e INB respecto de Vee suben ambas lo suficiente, haciendo que Ir1 sea alta, lograrán aumentar la caída de tensión en R1. Así mismo como  $I_2=I_{r1}+I_{r2}$ , la caída sobre R2 disminuirá.

El efecto es que el emisor de T6 subirá respecto de Vee y el emisor de T7 bajará hacia Vee, trabajando ambas salidas siempre en contrafase.

Se ajusta todo para que sólo cuando ambas entradas están cerca de Vcc, T7 por ejemplo baje a un nivel que se pueda considerar como "0" y cuando ambas están cerca de Vee, lo opuesto. Entonces funcionaría como una NAND.

T6 hace lo puestas, por lo que generaría una salida AND entre INA e INB.

## Compuerta OR-NOR en ECL



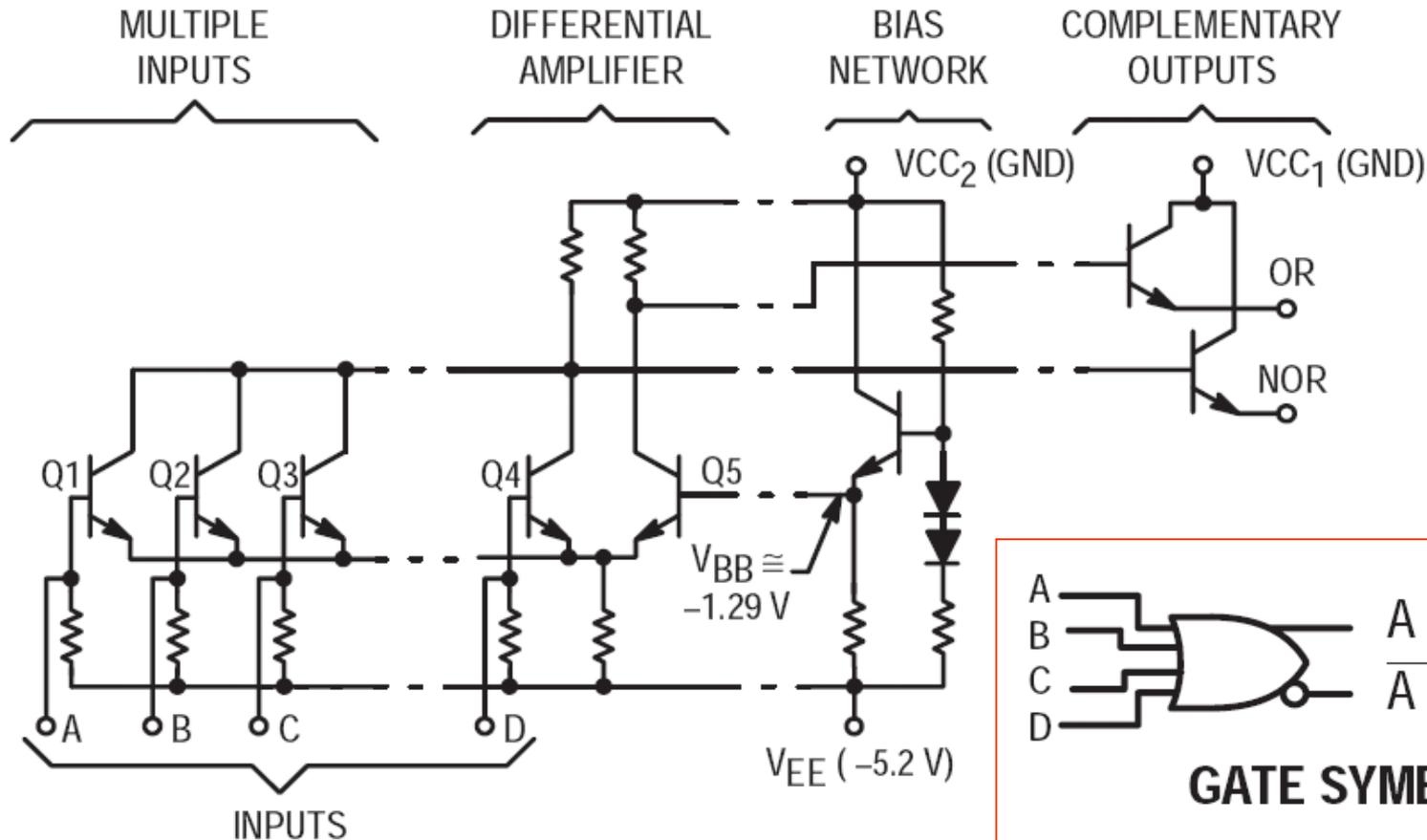
Aquí INA e INB alimentan a la base de dos transistores en paralelo.

La suma de las corrientes de rama de Q3 y la rama Q1-Q2 es constante e igual a  $I_1$ . Se ajusta el circuito para que cuando INA ó INB, o ambas entradas estén cerca de  $V_{CC}$ , la caída en R1 sea tal que de un nivel de tensión que pueda ser interpretado como "0" (mas cerca de Vee).

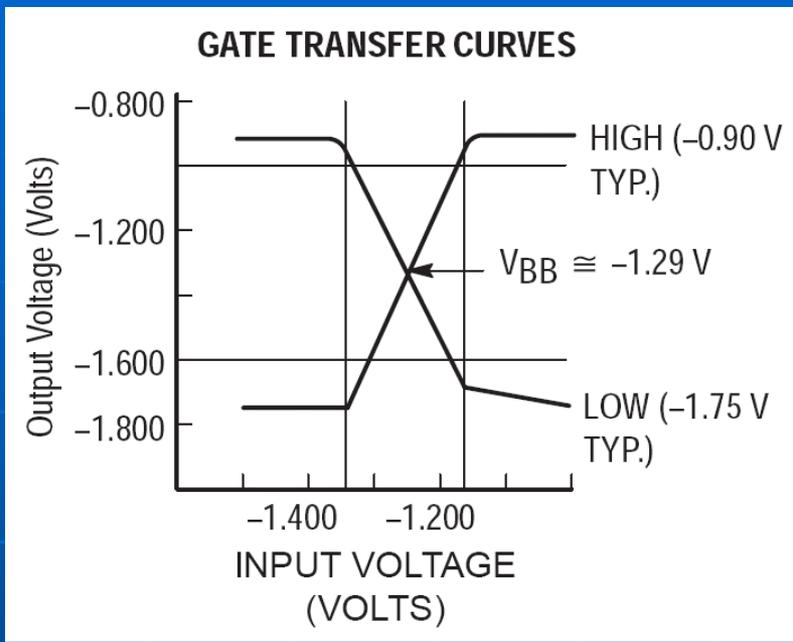
El emisor de Q5 sigue ese mismo cambio. Lo contrario pasa con la salida por R2 donde el emisor de Q4 sigue a la caída de R2. Si ambas entradas están a un nivel de tensión mas cerca de Vee, aumentará la tensión de base de Q5 y bajará la de Q4. El efecto es el de generar una OR por Q4 y la negación por Q5.

## Ejemplo de compuerta OR-NOR de 4 entradas ECL serie 10K

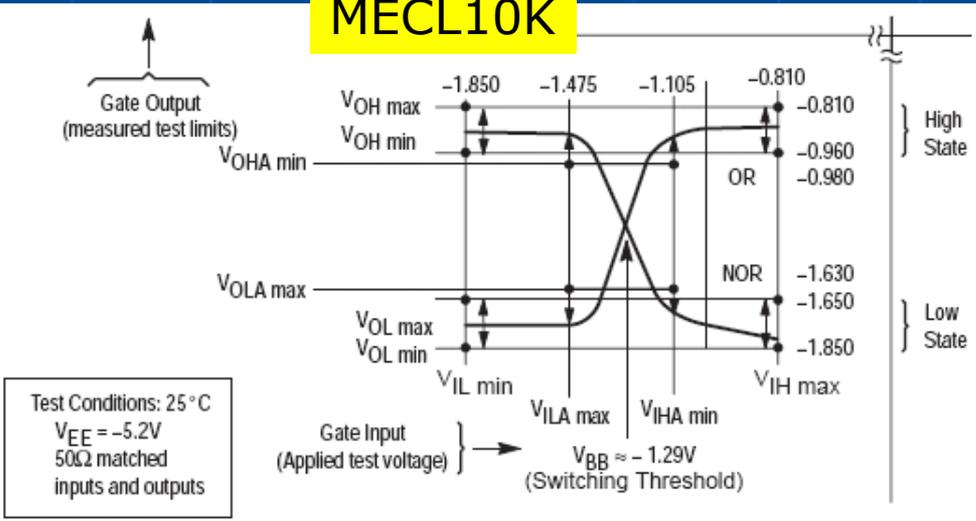
### GATE CIRCUIT



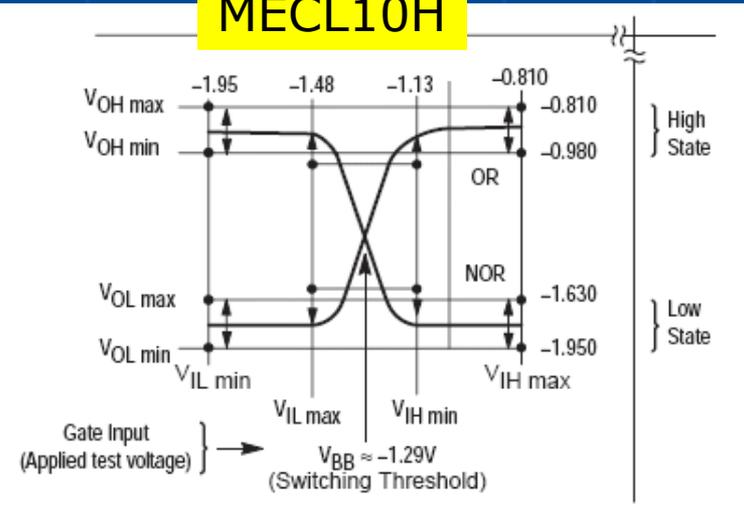
## Función de transferencia general de ECL



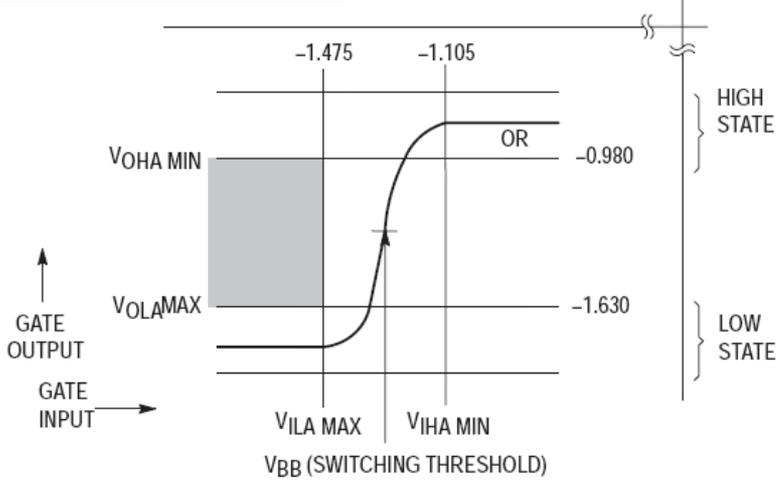
### MECL10K



### MECL10H



## Márgenes de ruido para MECL10K/10H



$$\Delta V = \text{High Noise Margin} \left\{ \begin{array}{l} V_{OHA \text{ MIN}}^* \\ V_{IHA \text{ MIN}}^* \end{array} \right.$$

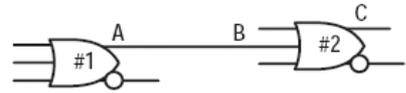
$$\Delta V = \text{Low Noise Margin} \left\{ \begin{array}{l} V_{ILA \text{ MAX}}^* \\ V_{OLA \text{ MAX}}^* \end{array} \right.$$

\* $V_{OHA \text{ min}} = V_{OH \text{ min}}$ ,  $V_{OLA \text{ max}} = V_{OL \text{ max}}$ .  $V_{IHA \text{ min}} = V_{IH \text{ min}}$  and  $V_{ILA \text{ max}} = V_{IL \text{ max}}$  for MECL 10H.

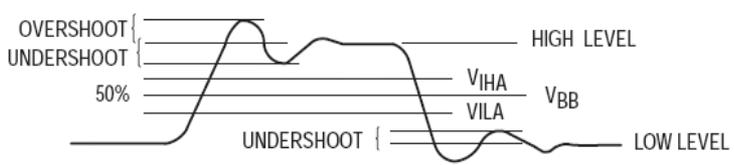
### Noise Margin Computations

Family	Guaranteed Worst-Case dc Noise Margin (V)	Typical dc Noise Margin (V)
MECL 10H	0.150	0.270
MECL 10K	0.125	0.210

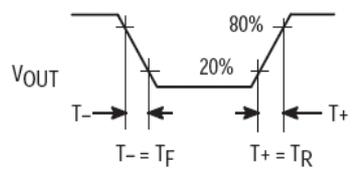
### Specification Points for Determining Noise Margin



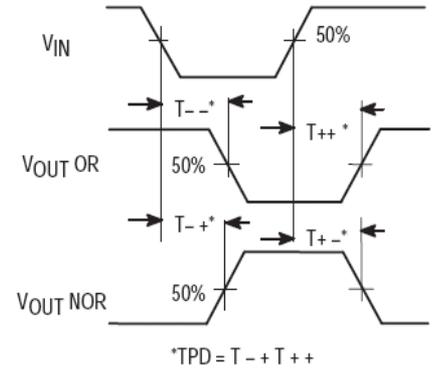
## Formas de onda típicas encontradas en señales de alta velocidad



### MECL WAVEFORM TERMINOLOGY



MECL 10K and MECL 10H Rise and Fall Times



MECL Propagation Delay

\* $TPD = T_{-+} + T_{+-}$

# Familias Lógicas

Compuerta AND-NAND ECL  
modelos MC10EP/100EP

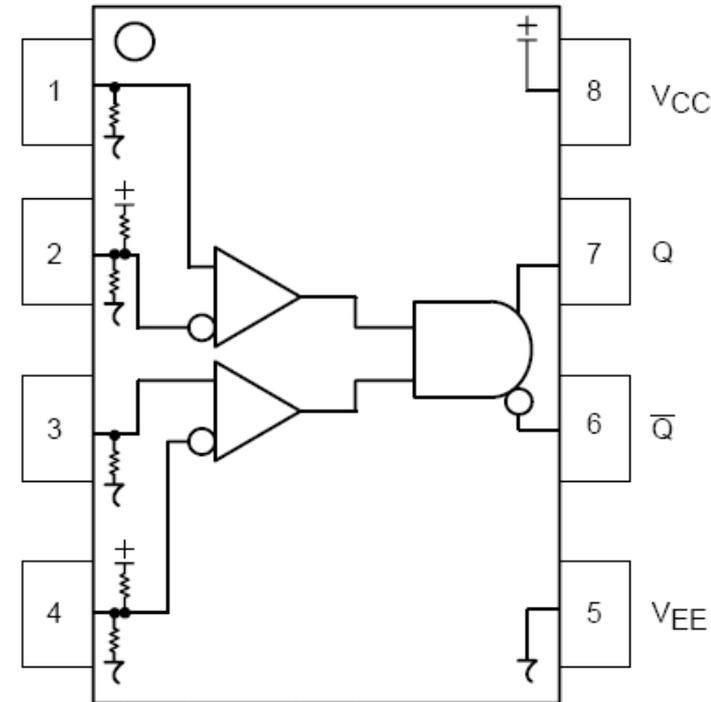
## MC10EP05, MC100EP05

### 3.3V / 5V ECL 2-Input Differential AND/NAND

The MC10/100EP05 is a 2-input differential AND/NAND gate. The device is functionally equivalent to the EL05 and LVEL05 devices. With AC performance much faster than the LVEL05 device, the EP05 is ideal for applications requiring the fastest AC performance available.

The 100 Series contains temperature compensation.

- 220 ps Typical Propagation Delay
- Maximum Frequency > 3 GHz Typical
- PECL Mode Operating Range:  $V_{CC} = 3.0\text{ V to }5.5\text{ V}$  with  $V_{EE} = 0\text{ V}$
- NECL Mode Operating Range:  $V_{CC} = 0\text{ V}$  with  $V_{EE} = -3.0\text{ V to }-5.5\text{ V}$
- Open Input Default State
- Safety Clamp on Inputs
- Q Output Will Default LOW with Inputs Open or at  $V_{EE}$



Puede funcionar como PECL...!

## MC10EP05, MC100EP05

### AND-NAND DIFERENCIAL

### 3.3V / 5V ECL 2-Input Differential AND/NAND

#### 100EP DC CHARACTERISTICS, PECL $V_{CC} = 3.3\text{ V}, V_{EE} = 0\text{ V}$ (Note 12)

Symbol	Characteristic	-40°C			25°C			85°C			Unit
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
$I_{EE}$	Power Supply Current	15	25	32	17	27	36	19	28	38	mA
$V_{OH}$	Output HIGH Voltage (Note 13)	2155	2280	2405	2155	2280	2405	2155	2280	2405	mV
$V_{OL}$	Output LOW Voltage (Note 13)	1355	1480	1605	1355	1480	1605	1355	1480	1605	mV
$V_{IH}$	Input HIGH Voltage (Single Ended)	2075		2420	2075		2420	2075		2420	mV
$V_{IL}$	Input LOW Voltage (Single Ended)	1355		1675	1355		1675	1355		1675	mV
$V_{IHCMR}$	Input HIGH Voltage Common Mode Range (Differential) (Note 14)	2.0		3.3	2.0		3.3	2.0		3.3	V
$I_{IH}$	Input HIGH Current			150			150			150	$\mu\text{A}$
$I_{IL}$	Input LOW Current	D $\bar{D}$	0.5 -150		0.5 -150			0.5 -150			$\mu\text{A}$

NOTE: EP circuits are designed to meet the DC specifications shown in the above table after thermal equilibrium has been established. The circuit is in a test socket or mounted on a printed circuit board and transverse airflow greater than 500 lfm is maintained.

12. Input and output parameters vary 1:1 with  $V_{CC}$ .  $V_{EE}$  can vary +0.3 V to -2.2 V.

13. All loading with 50 ohms to  $V_{CC}$ -2.0 volts.

14.  $V_{IHCMR}$  min varies 1:1 with  $V_{EE}$ ,  $V_{IHCMR}$  max varies 1:1 with  $V_{CC}$ . The  $V_{IHCMR}$  range is referenced to the most positive side of the differential input signal.

ALIMENTACIÓN POSITIVA DE 3,3 V

## MC10EP05, MC100EP05

### AND-NAND DIFERENCIAL

### 3.3V / 5V ECL 2-Input Differential AND/NAND

#### 100EP DC CHARACTERISTICS, PECL $V_{CC} = 5.0\text{ V}, V_{EE} = 0\text{ V}$ (Note 15)

Symbol	Characteristic	-40°C			25°C			85°C			Unit
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
$I_{EE}$	Power Supply Current	15	25	32	17	27	36	19	28	38	mA
$V_{OH}$	Output HIGH Voltage (Note 16)	3855	3980	4105	3855	3980	4105	3855	3980	4105	mV
$V_{OL}$	Output LOW Voltage (Note 16)	3055	3180	3305	3055	3180	3305	3055	3180	3305	mV
$V_{IH}$	Input HIGH Voltage (Single Ended)	3775		4120	3775		4120	3775		4120	mV
$V_{IL}$	Input LOW Voltage (Single Ended)	3055		3375	3055		3375	3055		3375	mV
$V_{IHCMR}$	Input HIGH Voltage Common Mode Range (Differential) (Note 17)	2.0		5.0	2.0		5.0	2.0		5.0	V
$I_{IH}$	Input HIGH Current			150			150			150	$\mu\text{A}$
$I_{IL}$	Input LOW Current	$\frac{D}{\bar{D}}$	0.5 -150		0.5 -150			0.5 -150			$\mu\text{A}$

NOTE: EP circuits are designed to meet the DC specifications shown in the above table after thermal equilibrium has been established. The circuit is in a test socket or mounted on a printed circuit board and transverse airflow greater than 500 lfm is maintained.

15. Input and output parameters vary 1:1 with  $V_{CC}$ .  $V_{EE}$  can vary +2.0 V to -0.5 V.

16. All loading with 50 ohms to  $V_{CC}$ -2.0 volts.

17.  $V_{IHCMR}$  min varies 1:1 with  $V_{EE}$ ,  $V_{IHCMR}$  max varies 1:1 with  $V_{CC}$ . The  $V_{IHCMR}$  range is referenced to the most positive side of the differential input signal.

ALIMENTACIÓN POSITIVA DE 5,0 V

## MC10EP05, MC100EP05

### AND-NAND DIFERENCIAL

### 3.3V / 5V ECL 2-Input Differential AND/NAND

100EP DC CHARACTERISTICS, NECL  $V_{CC} = 0\text{ V}$ ,  $V_{EE} = -5.5\text{ V to } -3.0\text{ V}$  (Note 18)

Symbol	Characteristic	-40°C			25°C			85°C			Unit
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
$I_{EE}$	Power Supply Current	15	25	32	17	27	36	19	28	38	mA
$V_{OH}$	Output HIGH Voltage (Note 19)	-1 145	-1020	-895	-1 145	-1020	-895	-1 145	-1020	-895	mV
$V_{OL}$	Output LOW Voltage (Note 19)	-1945	-1820	-1695	-1945	-1820	-1695	-1945	-1820	-1695	mV
$V_{IH}$	Input HIGH Voltage (Single Ended)	-1225		-880	-1225		-880	-1225		-880	mV
$V_{IL}$	Input LOW Voltage (Single Ended)	-1945		-1625	-1945		-1625	-1945		-1625	mV
$V_{IHCMR}$	Input HIGH Voltage Common Mode Range (Differential) (Note 20)	$V_{EE}+2.0$		0.0	$V_{EE}+2.0$		0.0	$V_{EE}+2.0$		0.0	V
$I_{IH}$	Input HIGH Current			150			150			150	$\mu\text{A}$
$I_{IL}$	Input LOW Current	D	0.5		0.5			0.5			$\mu\text{A}$
		$\bar{D}$	-150		-150			-150			

NOTE: EP circuits are designed to meet the DC specifications shown in the above table after thermal equilibrium has been established. The circuit is in a test socket or mounted on a printed circuit board and transverse airflow greater than 500 lfm is maintained.

18. Input and output parameters vary 1:1 with  $V_{CC}$ .

19. All loading with 50 ohms to  $V_{CC}-2.0$  volts.

20.  $V_{IHCMR}$  min varies 1:1 with  $V_{EE}$ ,  $V_{IHCMR}$  max varies 1:1 with  $V_{CC}$ . The  $V_{IHCMR}$  range is referenced to the most positive side of the differential input signal.

ALIMENTACIÓN NEGATIVA DE 5,0 V

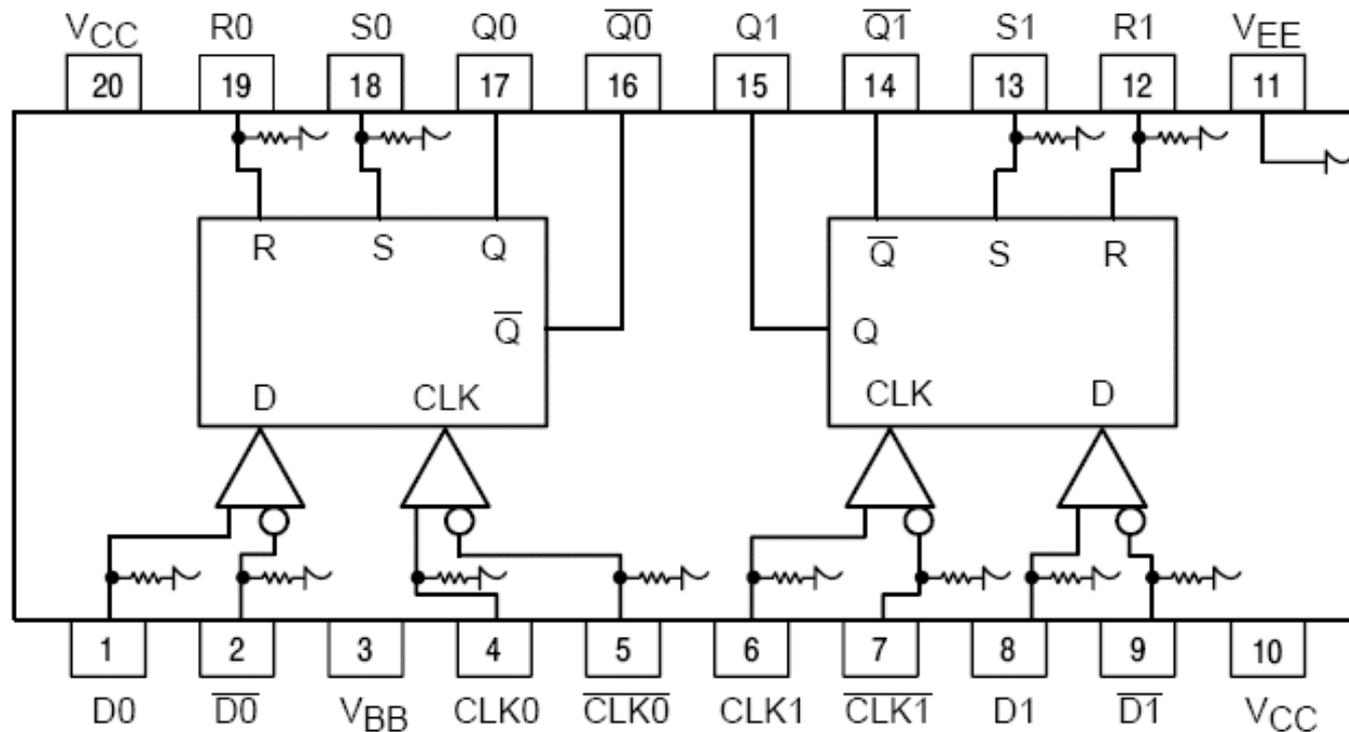
**MC10EP05, MC100EP05****3.3V / 5V ECL 2-Input  
Differential AND/NAND****AC CHARACTERISTICS**  $V_{CC} = 0\text{ V}$ ;  $V_{EE} = -3.0\text{ V}$  to  $-5.5\text{ V}$  or  $V_{CC} = 3.0\text{ V}$  to  $5.5\text{ V}$ ;  $V_{EE} = 0\text{ V}$  (Note 21)

Symbol	Characteristic	-40 °C			25 °C			85 °C			Unit	
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max		
$f_{\max}$	Maximum Frequency (See Figure 2. $F_{\max}/\text{JITTER}$ )		> 3			> 3			> 3		GHz	
$t_{\text{PLH}}$ , $t_{\text{PHL}}$	Propagation Delay to Output Differential	160	210	260	170	220	270	210	260	320	ps	
$t_{\text{JITTER}}$	Cycle-to-Cycle Jitter (See Figure 2. $F_{\max}/\text{JITTER}$ )		0.2	< 1		0.2	< 1		0.2	< 1	ps	
$V_{\text{PP}}$	Input Voltage Swing (Differential)	150	800	1200	150	800	1200	150	800	1200	mV	
$t_{\text{r}}$ $t_{\text{f}}$	Output Rise/Fall Times (20% - 80%)	Q	70	120	170	80	130	180	100	150	200	ps

21. Measured using a 750 mV source, 50% duty cycle clock source. All loading with 50 ohms to  $V_{CC}-2.0\text{ V}$ .

Flip-Flop tipo D ECL  
modelos MC10EP/100EP

### 3.3V / 5V ECL Dual Differential Data and Clock D Flip-Flop With Set and Reset



Warning: All VCC and VEE pins must be externally connected to Power Supply to guarantee proper operation.

## Flip-Flop tipo "D" ECL modelos MC10EP/100EP

### MC10EP29, MC100EP29

### 3.3V / 5V ECL Dual Differential Data and Clock D Flip-Flop With Set and Reset

**AC CHARACTERISTICS**  $V_{CC} = 0\text{ V}; V_{EE} = -3.0\text{ V to }-5.5\text{ V}$  or  $V_{CC} = 3.0\text{ V to }5.5\text{ V}; V_{EE} = 0\text{ V}$  (Note 21)

Symbol	Characteristic	-40 °C			25 °C			85 °C			Unit	
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max		
$f_{max}$	Maximum Frequency (See Figure 5 $F_{max}/JITTER$ )		> 3.0			> 3.0			> 3.0		GHz	
$t_{PLH}$ , $t_{PHL}$	Propagation Delay to Output Differential	CLK	300	380	450	350	420	500	400	470	550	ps
		S	275	380	475	300	400	500	350	450	550	
		R	300	400	500	325	420	525	375	470	575	
$t_S$	Setup Time		100	20		100	20		100	20		ps
$t_H$	Hold Time		100	20		100	20		100	20		ps
$t_{RR}/t_{RR2}$	Set/Reset Recovery		150	80		150	80		150	80		ps
$t_{PW}$	Minimum Pulse Width	Set, Reset	500	300		500	300		500	300		ps
$t_{JITTER}$	Cycle-to-Cycle Jitter (See Figure 5 $F_{max}/JITTER$ )			.2	< 1		.2	< 1		.2	< 1	ps
$V_{PP}$	Input Voltage Swing (Note 22)		150	800	1200	150	800	1200	150	800	1200	mV
$t_r$ , $t_f$	Output Rise/Fall Times (20% - 80%)	Q, $\bar{Q}$	100	180	250	150	210	300	175	230	325	ps

21. Measured using a 750 mV source, 50% duty cycle clock source. All loading with 50  $\Omega$  to  $V_{CC}-2.0\text{ V}$ .

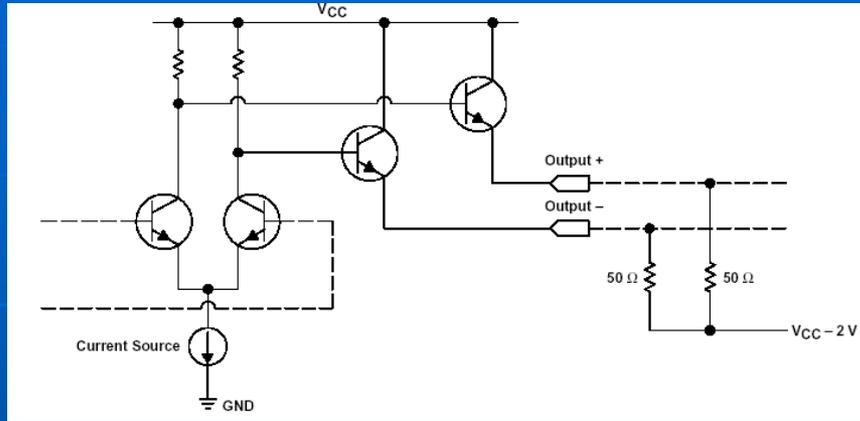
22.  $V_{pp}(\text{min})$  is the minimum input swing for which AC parameters are guaranteed.

**AC CHARACTERISTICS**  $V_{EE} = -3.0\text{ V to }-5.5\text{ V}; V_{CC} = 0\text{ V}$  or  $V_{CC} = 3.0\text{ V to }5.5\text{ V}; V_{EE} = 0\text{ V}$  (Note 25)

Symbol	Characteristic	-40 °C			25 °C			85 °C			Unit	
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max		
$f_{COUNT}$	Maximum Frequency		> 1			> 1			> 1		GHz	
			> 800			> 800			> 800		MHz	
$t_{PLH}$	Propagation Delay (10)	CLK to Q	300	460	600	350	500	650	400	560	700	ps
$t_{PHL}$	(10)	MR to $\bar{Q}$	300	400	500	400	500	600	450	580	700	
	(10)	CLK to $\bar{TC}$	350	420	550	400	500	600	400	550	700	
	(10)	MR to $\bar{TC}$	250	350	450	350	450	550	400	510	600	
	(10)	CLK to COUT	400	470	650	450	550	700	450	600	800	
	(10)	MR to COUT	300	400	550	400	500	650	450	560	700	
	(100)	CLK to Q	350	500	650	400	550	700	480	630	780	
	(100)	MR to Q	400	550	700	450	590	750	520	670	820	
	(100)	CLK to $\bar{TC}$	350	500	650	400	550	700	480	630	780	
	(100)	MR to $\bar{TC}$	400	550	700	450	590	750	520	670	820	
	(100)	CLK to COUT	400	550	750	450	600	800	530	680	880	
	(100)	MR to COUT	450	600	800	500	640	850	570	720	920	

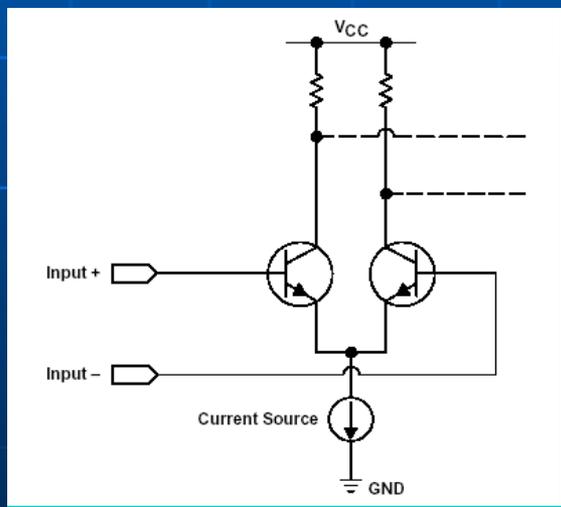
## Contador binario sincrónico ECL MC10EP016/100EP016

## Tecnología ECL: Resumen de características



Salida diferencial seguidor por emisor trabajando en zona activa.  
 Permite tiempos de switching muy bajos a costa de un consumo permanente de corriente típico de 14 mA por las resistencias de Terminación de 50 Ω. Impedancia de los seguidores es muy baja (4-5 Ω) por lo que hay que tener cuidado cuando se trabaja con líneas de transmisión por posibles desadaptaciones.

Etapa de salida LVPECL



Entrada diferencial de alta impedancia.  
 Se requiere levantar la tensión de las entradas con resistencias de pull-up a una tensión de  $V_{CC} - 1,3\text{ V}$  a fin de proveer una tensión de modo común de 2,0 V (para el caso en que  $V_{CC}$  sea de +3,3V).

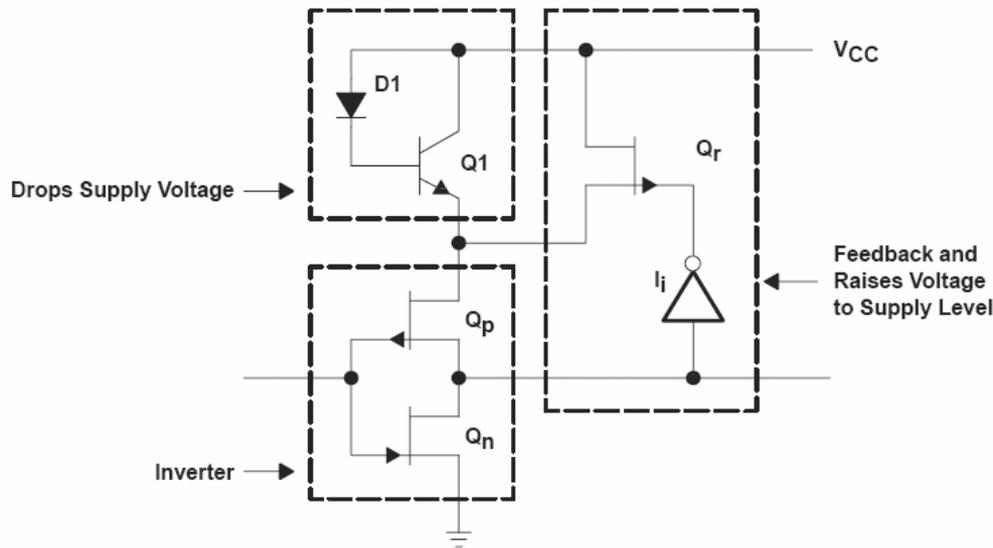
Etapa de entrada LVPECL

### Especificaciones LVPECL de Tensiones de entrada y salida

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Output High Voltage	$T_A = 0^\circ\text{C to } +85^\circ\text{C}$	$V_{CC} - 1.025$		$V_{CC} - 0.88$	V
	$T_A = -40^\circ\text{C}$	$V_{CC} - 1.085$		$V_{CC} - 0.88$	V
Output Low Voltage	$T_A = 0^\circ\text{C to } +85^\circ\text{C}$	$V_{CC} - 1.81$		$V_{CC} - 1.62$	V
	$T_A = -40^\circ\text{C}$	$V_{CC} - 1.83$		$V_{CC} - 1.55$	V
Input High Voltage		$V_{CC} - 1.16$		$V_{CC} - 0.88$	V
Input Low Voltage		$V_{CC} - 1.81$		$V_{CC} - 1.48$	V

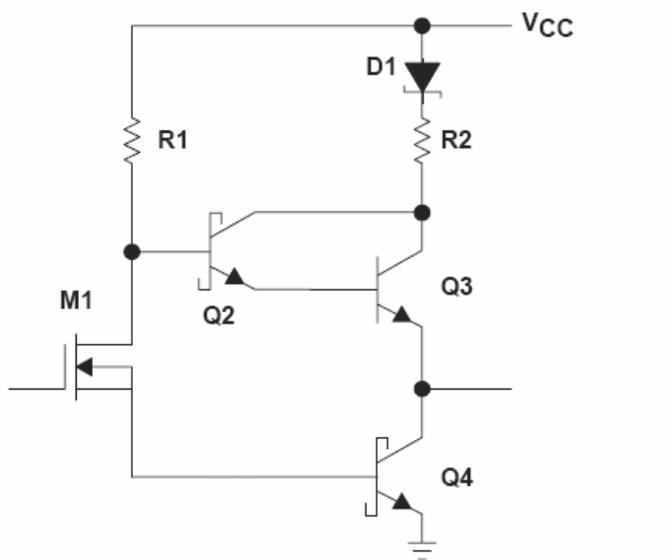
## Tecnología BiCMOS (Bipolar - CMOS)

## Familia ABT



**Entrada CMOS** para bajo consumo.  $D_1$  y  $Q_1$  sirven para disminuir la tensión de conmutación entre estados.

El circuito tiene una realimentación para generar histéresis y así aumentar el margen de ruido.

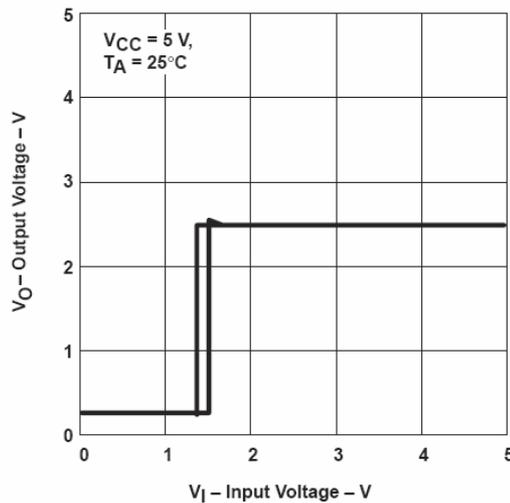


**Salida bipolar** para disminuir el swing de tensión entre  $V_{OH}$  y  $V_{OL}$ . Mayor capacidad de corriente de carga.

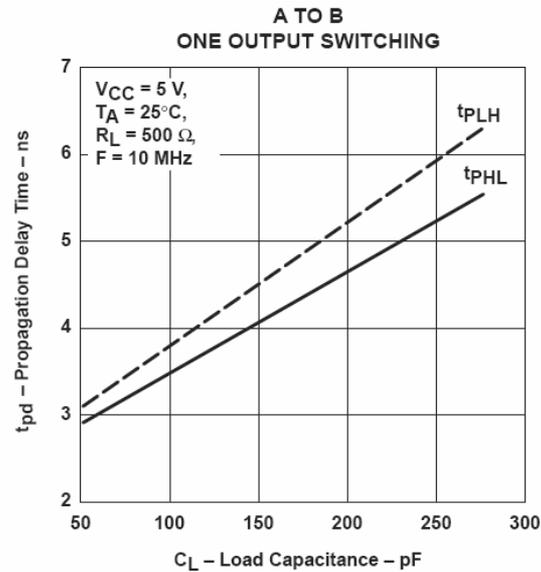
## Tecnología BiCMOS

## Familia ABT

### Función de transferencia



### Tiempos de retardo promedio del orden de algunos [ns]



### Gráfico de comparación entre Familias lógicas $I_{CC}$ vs. Frec.

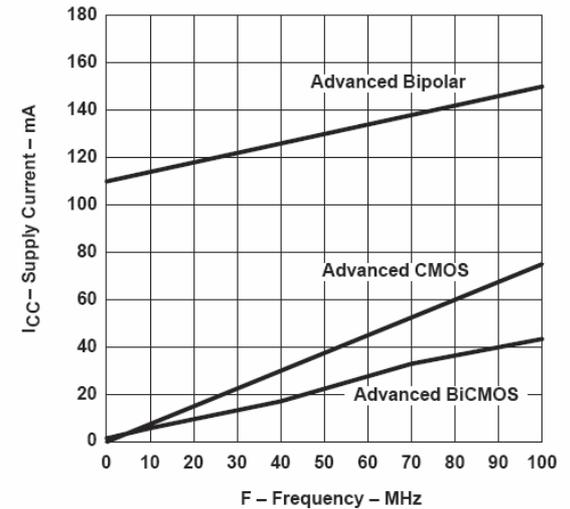
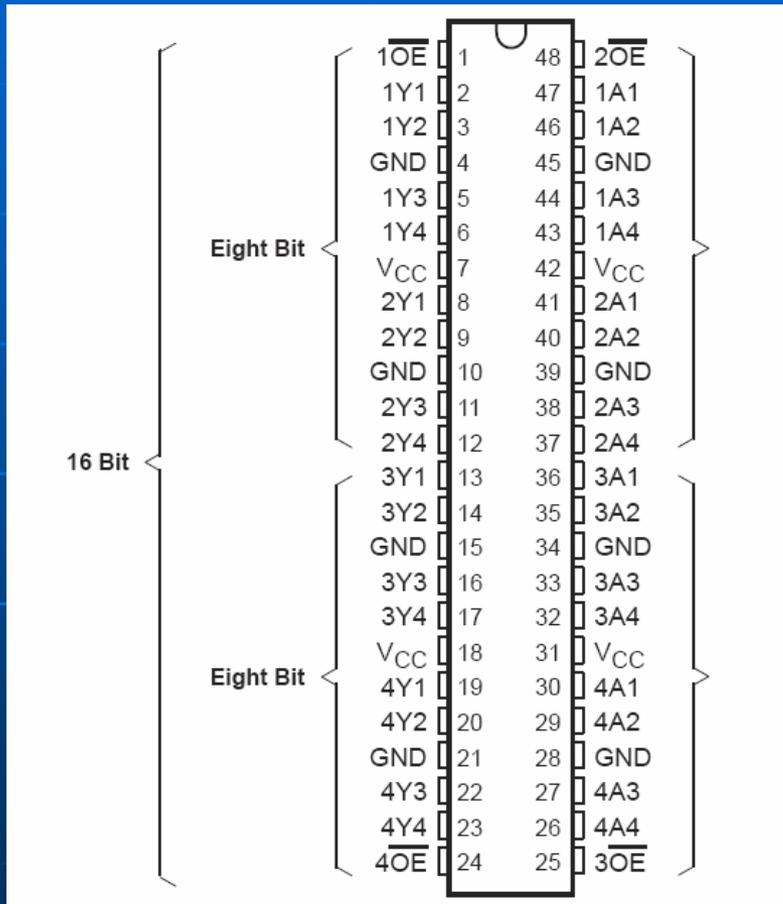


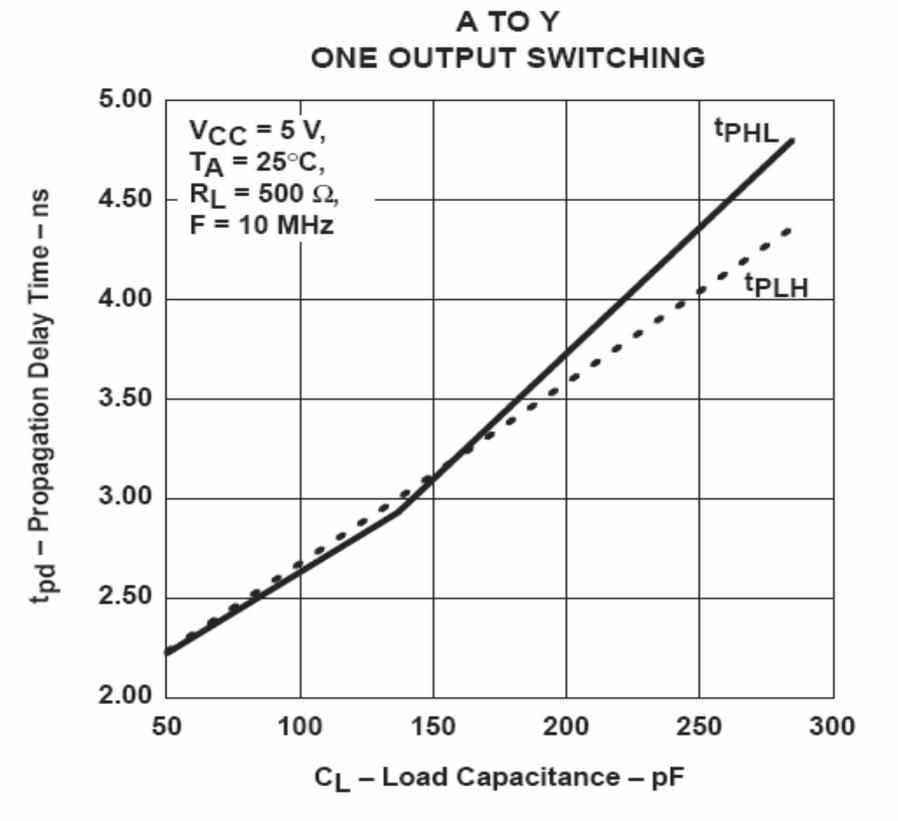
Figure 4. Supply Current vs Frequency

## Tecnología BiCMOS

**Ejemplo** 74ABT16244A: buffer x 16, no inversor con tri-state



Retardos en función de la capacidad de carga



# Familias Lógicas

## Comparaciones entre familias LS-TTL y CMOS de alta velocidad

FACT = 24/-24 mA  
 ALS = 24/-15 mA  
 LS = 8/-0.4 mA @ 4.75 V V<sub>CC</sub>  
 HC = 4/-4 mA

Corriente máxima de salida

FACT = 2 to 6 V  
 ALS = 5 V ± 10%  
 LS = 5 V ± 5%  
 HC = 2 to 6 V

Rango de tensiones de alimentación

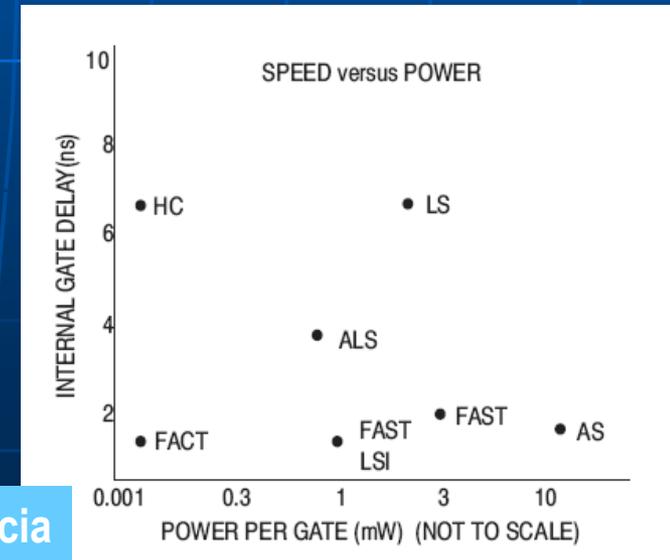
FACT = 1.25/1.25 V  
 ALS = 0.4/0.7 V  
 LS = 0.3/0.7 V @ 4.75 V V<sub>CC</sub>  
 HC = 0.8/1.25 V

Márgenes de ruido

FACT = 0.1 mW/Gate  
 ALS = 1.2 mW/Gate  
 LS = 2.0 mW/Gate  
 HC = 0.1 mW/Gate

Consumo interno por compuerta

NOTA: FACT corresponde a una línea comercial de CMOS como la ACT.

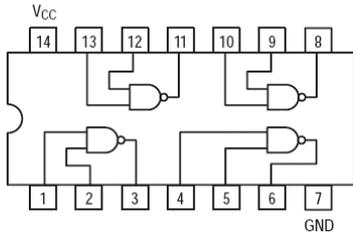


Curva general de velocidad vs potencia

## SN74LS00

### Quad 2-Input NAND Gate

- ESD > 3500 Volts



### AC CHARACTERISTICS (T<sub>A</sub> = 25°C)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
t <sub>PLH</sub>	Turn-Off Delay, Input to Output		9.0	15	ns	V <sub>CC</sub> = 5.0 V C <sub>L</sub> = 15 pF
t <sub>PHL</sub>	Turn-On Delay, Input to Output		10	15	ns	

## MC74HC00A

### Quad 2-Input NAND Gate High-Performance Silicon-Gate CMOS

### AC CHARACTERISTICS (C<sub>L</sub> = 50 pF, Input t<sub>r</sub> = t<sub>f</sub> = 6 ns)

Symbol	Parameter	V <sub>CC</sub> V	Guaranteed Limit			Unit
			-55 to 25°C	≤85°C	≤125°C	
t <sub>PLH</sub> , t <sub>PHL</sub>	Maximum Propagation Delay, Input A or B to Output Y (Figures 1 and 2)	2.0	75	95	110	ns
		3.0	30	40	55	
		4.5	15	19	22	
		6.0	13	16	19	
t <sub>TLH</sub> , t <sub>THL</sub>	Maximum Output Transition Time, Any Output (Figures 1 and 2)	2.0	75	95	110	ns
		3.0	27	32	36	
		4.5	15	19	22	
		6.0	13	16	19	
C <sub>in</sub>	Maximum Input Capacitance		10	10	10	pF

NOTE: For propagation delays with loads other than 50 pF, and information on typical parametric values, see Chapter 2 of the ON Semiconductor High-Speed CMOS Data Book (DL129/D).

C <sub>PD</sub>	Power Dissipation Capacitance (Per Buffer)*	Typical @ 25°C, V <sub>CC</sub> = 5.0 V, V <sub>EE</sub> = 0 V	
			Unit
		22	pF

\* Used to determine the no-load dynamic power consumption: P<sub>D</sub> = C<sub>PD</sub> V<sub>CC</sub><sup>2</sup>f + I<sub>CC</sub> V<sub>CC</sub>. For load considerations, see Chapter 2 of the ON Semiconductor High-Speed CMOS Data Book (DL129/D).

## MC74AC00, MC74ACT00

### Quad 2-Input NAND Gate High-Performance Silicon-Gate CMOS

### AC CHARACTERISTICS (t<sub>r</sub> = t<sub>f</sub> = 3.0 nS; C<sub>L</sub> = 50 pF; see Figures 3 and 4 for Waveforms)

Symbol	Parameter	V <sub>CC</sub> <sup>*</sup> (V)	MC74AC00								Unit
			T <sub>A</sub> = +25°C			T <sub>A</sub> = -40°C to +85°C		T <sub>A</sub> = -55°C to +125°C			
			Min	Typ	Max	Min	Max	Min	Max		
t <sub>PLH</sub>	Propagation Delay	3.3	2.0	7.0	9.5	2.0	10.0	1.0	11.0	ns	
		5.0	1.5	6.0	8.0	1.5	8.5	1.0	8.5		
t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay	3.3	1.5	5.5	8.0	1.0	8.5	1.0	9.0	ns	
		5.0	1.5	4.5	6.5	1.0	7.0	1.0	7.0		

\*Voltage Range 3.3 V is 3.3 V ± 0.3 V.  
Voltage Range 5.0 V is 5.0 V ± 0.5 V.

# Familias Lógicas

## SN74LS74A

### Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop

AC CHARACTERISTICS ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 5.0\text{ V}$ )

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
$f_{MAX}$	Maximum Clock Frequency	25	33		MHz	Figure 1
$t_{PLH}$ $t_{PHL}$	Clock, Clear, Set to Output		15	25	ns	Figure 1
			25	40	ns	

$V_{CC} = 5.0\text{ V}$   
 $C_L = 15\text{ pF}$

AC SETUP REQUIREMENTS ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
$t_{W(H)}$	Clock	25			ns	Figure 1
$t_{W(L)}$	Clear, Set	25			ns	Figure 2
$t_s$	Data Setup Time — HIGH LOW	20			ns	Figure 1
		20			ns	
$t_h$	Hold Time	5.0			ns	Figure 1

$V_{CC} = 5.0\text{ V}$

## MC74HC74A

### Dual D Flip-Flop with Set and Reset

High-Performance Silicon-Gate CMOS

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $C_L = 50\text{ pF}$ , Input  $t_r = t_f = 6.0\text{ ns}$ )

Symbol	Parameter	$V_{CC}$ V	Guaranteed Limit			Unit
			-55 to 25°C	≤ 85°C	≤ 125°C	
$f_{max}$	Maximum Clock Frequency (50% Duty Cycle) (Figures 1 and 4)	2.0 3.0 4.5 6.0	6.0 15 30 35	4.8 10 24 28	4.0 8.0 20 24	MHz
$t_{PLH}$ $t_{PHL}$	Maximum Propagation Delay, Clock to Q or $\bar{Q}$ (Figures 1 and 4)	2.0 3.0 4.5 6.0	100 75 20 17	125 90 25 21	150 120 30 26	ns

## MC74AC74, MC74ACT74

### Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop

AC CHARACTERISTICS (For Figures and Waveforms – See Section 3 of the ON Semiconductor FACT Data Book, DL138/D)

Symbol	Parameter	$V_{CC}^*$ (V)	74ACT			74ACT		Unit	Fig. No.
			$T_A = +25^\circ\text{C}$ $C_L = 50\text{ pF}$			$T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+85^\circ\text{C}$ $C_L = 50\text{ pF}$			
			Min	Typ	Max	Min	Max		
$f_{max}$	Maximum Clock Frequency	5.0	145	210	–	125	–	MHz	3–3
$t_{PLH}$	Propagation Delay $\bar{C}_{Dn}$ or $\bar{S}_{Dn}$ to $Q_n$ or $\bar{Q}_n$	5.0	3.0	5.5	9.5	2.5	10.5	ns	3–6
$t_{PHL}$	Propagation Delay $\bar{C}_{Dn}$ or $\bar{S}_{Dn}$ to $Q_n$ or $\bar{Q}_n$	5.0	3.0	6.0	10.0	3.0	11.5	ns	3–6
$t_{PLH}$	Propagation Delay $C_{Pn}$ to $Q_n$ or $\bar{Q}_n$	5.0	4.0	7.5	11.0	4.0	13.0	ns	3–6
$t_{PHL}$	Propagation Delay $C_{Pn}$ to $Q_n$ or $\bar{Q}_n$	5.0	3.5	6.0	10.0	3.0	11.5	ns	3–6

\*Voltage Range 5.0 V is 5.0 V  $\pm$ 0.5 V.

of the ON

# Familias Lógicas

**SN54/74LS160A**  
**SN54/74LS161A**  
**SN54/74LS162A**  
**SN54/74LS163A**

**BCD DECADE COUNTERS/  
 4-BIT BINARY COUNTERS**  
**LOW POWER SCHOTTKY**

**AC CHARACTERISTICS** (T<sub>A</sub> = 25°C)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
f <sub>MAX</sub>	Maximum Clock Frequency	25	32		MHz	V <sub>CC</sub> = 5.0 V C <sub>L</sub> = 15 pF
t <sub>PLH</sub>	Propagation Delay		20	35	ns	
t <sub>PHL</sub>	Clock to TC		18	35		
t <sub>PLH</sub>	Propagation Delay		13	24	ns	
t <sub>PHL</sub>	Clock to Q		18	27		
t <sub>PLH</sub>	Propagation Delay		9.0	14	ns	
t <sub>PHL</sub>	CET to TC		9.0	14		
t <sub>PHL</sub>	MR or SR to Q		20	28	ns	

Symbol	Parameter	Fig.	V <sub>CC</sub> V	-55 to 25°C	≤ 85°C	≤ 125°C	Unit
f <sub>max</sub>	Maximum Clock Frequency (50% Duty Cycle)*	1, 7	2.0 3.0 4.5 6.0	6 15 30 35	5 12 24 28	4 10 20 24	MHz
t <sub>PLH</sub>	Maximum Propagation Delay, Clock to Q	1, 7	2.0 3.0 4.5 6.0	120 75 20 16	160 120 23 20	200 150 28 22	ns
t <sub>PHL</sub>		1, 7	2.0	145	185	220	ns

**MC74HC161A,**  
**MC74HC163A**

**Presetable Counters**  
**High-Performance Silicon-Gate CMOS**

**AC CHARACTERISTICS** (For Figures and Waveforms – See Section 3 of the ON Semiconductor FACT Data Book, DL138/D)

Symbol	Parameter	V <sub>CC</sub> (V)	74AC163			74AC163		Unit	Fig. No.
			T <sub>A</sub> = +25°C C <sub>L</sub> = 50 pF			T <sub>A</sub> = -40°C to +85°C C <sub>L</sub> = 50 pF			
			Min	Typ	Max	Min	Max		
f <sub>max</sub>	Maximum Count Frequency	3.3 5.0	70 110	95 140	– –	60 95	– –	MHz	3-3
t <sub>PLH</sub>	Propagation Delay CP to Q <sub>n</sub> (PE Input HIGH or LOW)	3.3 5.0	2.0 1.5	7.5 5.5	12.5 9.0	1.5 1.0	13.5 9.5	ns	3-6
t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay CP to Q <sub>n</sub> (PE Input HIGH or LOW)	3.3 5.0	1.5 1.5	8.5 6.0	12.0 9.5	1.5 1.5	13.0 10.0	ns	3-6
t <sub>PLH</sub>	Propagation Delay CP to TC	3.3 5.0	3.0 2.0	9.5 7.0	15.0 10.5	2.5 1.5	16.5 11.5	ns	3-6
t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay CP to TC	3.3 5.0	3.5 2.0	11.0 8.0	14.0 11.0	2.5 2.0	15.5 11.5	ns	3-6
t <sub>PLH</sub>	Propagation Delay CET to TC	3.3 5.0	2.0 1.5	7.5 5.5	9.5 6.5	1.5 1.0	11.0 7.5	ns	3-6
t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay CET to TC	3.3 5.0	2.5 2.0	8.5 6.0	11.0 8.5	2.0 1.5	12.5 9.5	ns	3-6

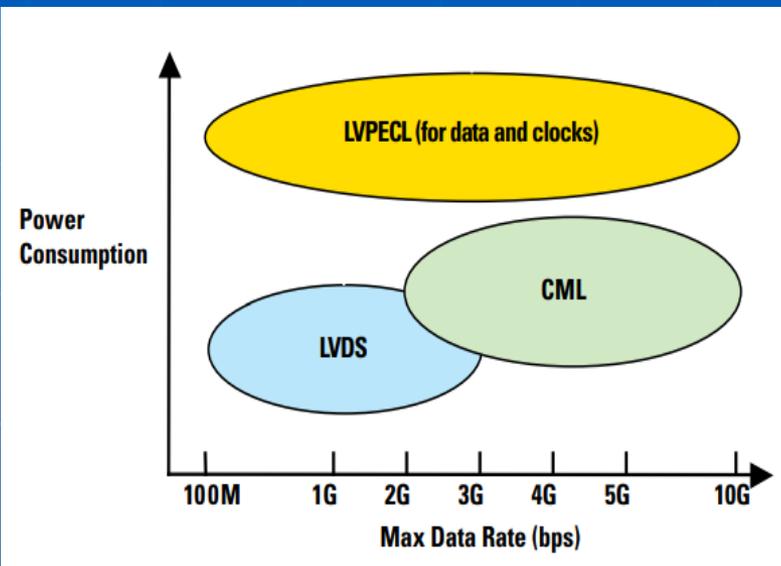
**MC74AC161, MC74ACT161,**  
**MC74AC163, MC74ACT163**

**Synchronous Presetable  
 Binary Counter**

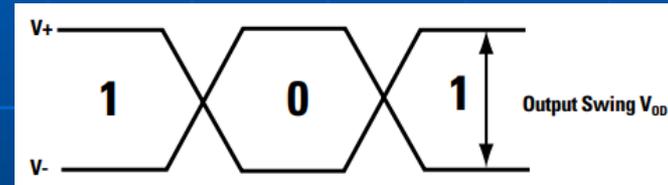
\*Voltage Range 3.3 V is 3.3 V ±0.3 V.  
 \*Voltage Range 5.0 V is 5.0 V ±0.5 V.

# Tecnologías para manejo de señalización a alta velocidad

	Industry Standard	Maximum Data Rate	Output Swing ( $V_{OD}$ )	Power Consumption
LVDS	TIA/EIA-644	3.125 Gbps	$\pm 350$ mV	Low
LVPECL	N/A	10+ Gbps	$\pm 800$ mV	Medium to High
CML	N/A	10+ Gbps	$\pm 800$ mV	Medium
M-LVDS	TIA/EIA-899	250 Mbps	$\pm 550$ mV	Low
B-LVDS	N/A	800 Mbps	$\pm 550$ mV	Low



Tecnologías usadas para el transporte de señales en formato serie de datos y reloj de manera diferencial (entre dos "vivos"). Esto mejora la inmunidad al ruido y problemas de switching.

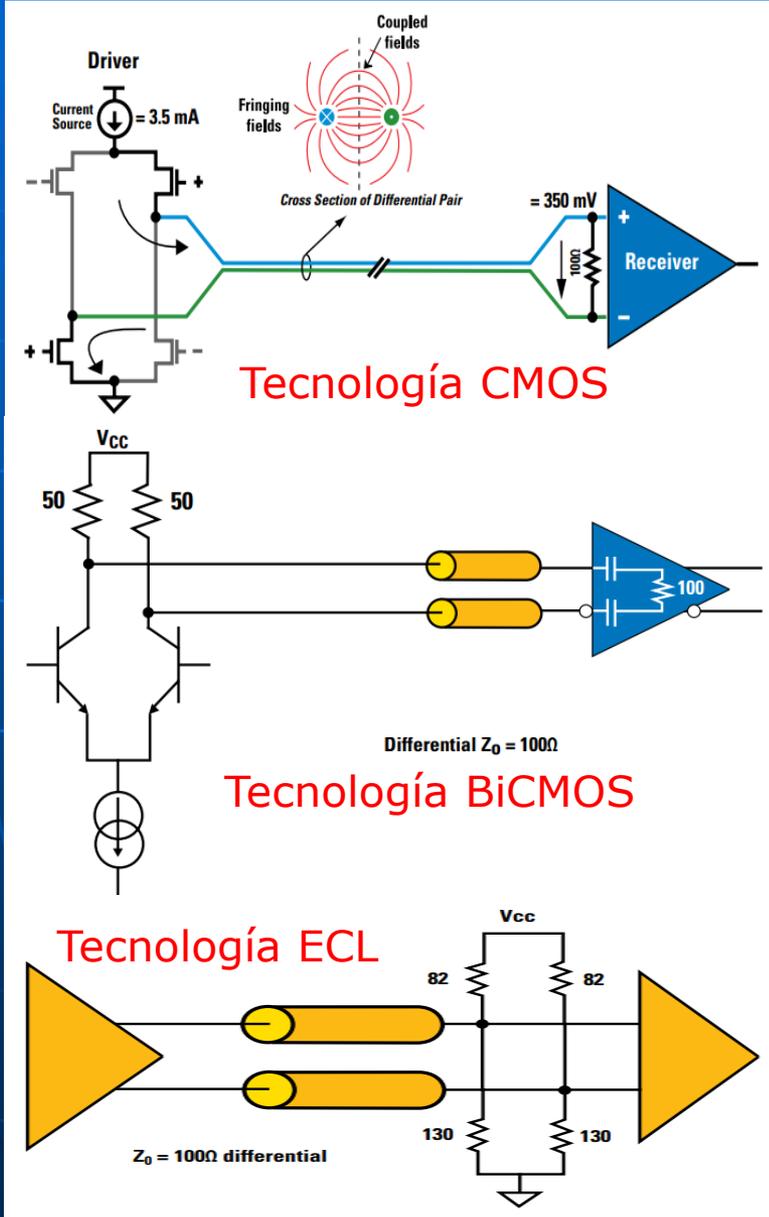


LVDS es una interface estandarizada. De bajo consumo pero baja velocidad comparada con CML y LVPECL.

PECL puede transportar señales a mas de 10Gbps pero su consumo es elevado.

CML es equiparable a LVPECL en velocidad pero con menor consumo.

# Tecnologías para manejo de señalización a alta velocidad



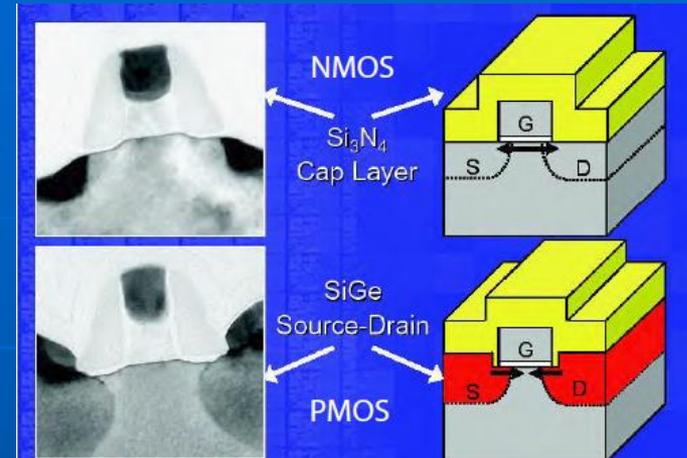
**LVDS:** Convertido en standard. Maneja el link de manera diferencial a través de un par de cables, ruteando el generador de corriente que siempre está encendido lo cual reduce emisiones de EMI y elimina los spikes por conmutación. Requiere de una resistencia de terminación de  $100\Omega$ . Se usa en comunicaciones punto a punto y multipunto. Supera los 3 Gbps de velocidad.

**CML:** De manera similar al anterior emplea un par diferencial. El link está acoplado en alterna. Los componentes de terminación de línea están incorporados al driver y receptor. Requiere mas energía pero puede superar los 10 Gbps de velocidad. Se usa en comunicaciones punto a punto. No está estandarizado al igual que LVPECL.

**PECL:** Es la tecnología de más consume. Características similares en cuanto a velocidad y margen de ruido que con CML.

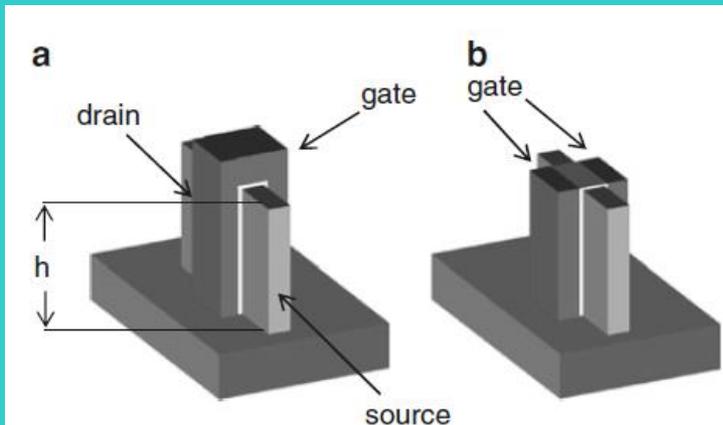
# Avances en CMOS

A principios de la década del 2000, la necesidad de conseguir mayor velocidad de conmutación en CMOS, se solucionó empleando la técnica **strained silicon** la cual genera la compresión de átomos de Si en la red cristalina, mejorando la movilidad de los portadores. Intel emplea Si-Ge + Si en transistores PMOS y  $\text{Si}_3\text{N}_4$  + Si en los del tipo NMOS.

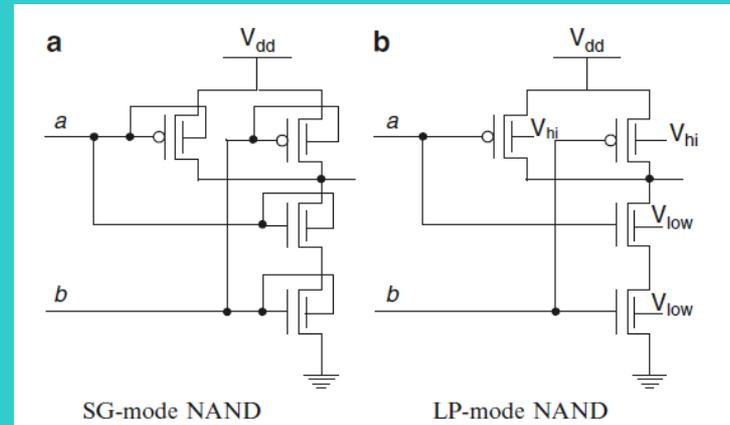


Otra mejora posterior fue la de construir transistores en 3D (como los FINFET) y multiGATE donde se logró mejorar el rendimiento bajando los tiempos de conmutación y el consumo.

## FINFET Short Gate/Isolate Gate

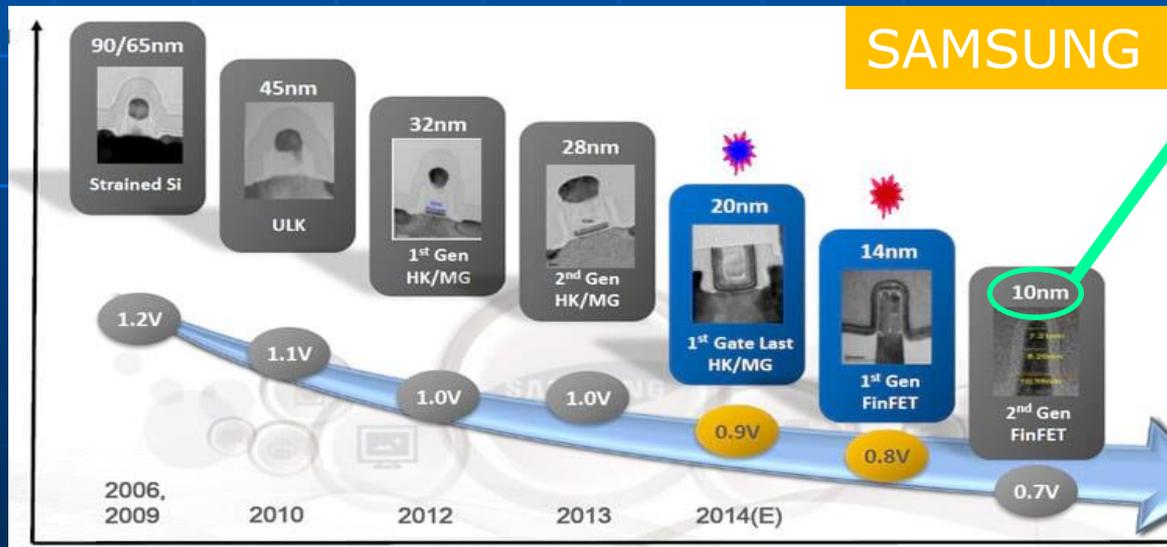
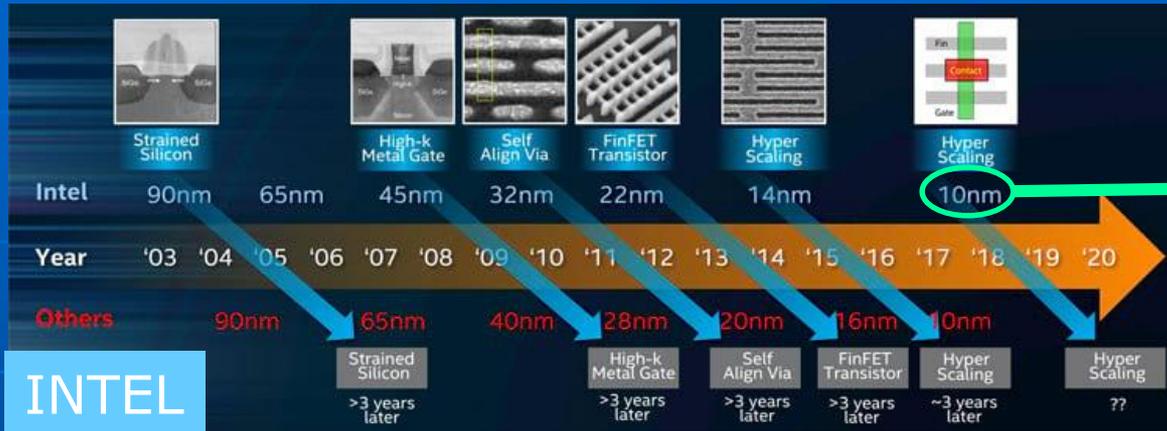


## Ejemplo de compuerta NAND



# Avances en CMOS

Evolución reciente de transistores MOS en INTEL y SAMSUNG



Longitud de Canal

# Familias Lógicas

## Bibliografía:

### Apuntes de teoría:

- "Familias Lógicas". S. Noriega.

### Libros:

- "Sistemas Digitales". R. Tocci, N. Widmer, G. Moss. Ed. Prentice Hall.
- "Diseño Digital". M. Morris Mano. Ed. Prentice Hall. 3ra edición.
- "Diseño de Sistemas Digitales". John Vyemura. Ed. Thomson.
- "Diseño Lógico". Antonio Ruiz, Alberto Espinosa. Ed. McGraw-Hill.
- "Digital Design: Principles & Practices". John Wakerly. Ed. Prentice Hall.
- "Diseño Digital". Alan Marcovitz. Ed. McGraw-Hill.
- "Electrónica Digital". James Bignell, R. Donovan. Ed. CECSA.
- "Técnicas Digitales con Circuitos Integrados". M. Ginzburg.
- "Fundamentos de Diseño Lógico y Computadoras". M. Mano, C. Kime. Ed. Prentice Hall.
- "Teoría de conmutación y Diseño lógico". F. Hill, G. Peterson. Ed. Limusa.
- "FinFETs and Other Multi-Gate Transistors". Jean-Pierre Colinge . Springer 2008.
- "Capítulo: FinFET Circuit Design. Nanoelectronic System Design". Prateek Mishra .Springer 2011.
- "Circuitos Microelectrónicos". Sedra, Smith. 5ta Edición. McGraw-Hill. 2006.
- Websites: IBM, INTEL, AMD.

# Familias Lógicas

## Bibliografía (continuación):

### Notas de aplicación y manuales:

- Nota de aplicación "AN-104" de Micrel ([www.micrel.com](http://www.micrel.com)).
- Hojas de datos del HFBR-5903A: "5988-8033EN" ([www.agilent.com](http://www.agilent.com)).
- Nota de aplicación "scba008b" de Texas Instruments ([www.ti.com](http://www.ti.com)).
- Nota de aplicación "AN-138" de Altera ([www.altera.com](http://www.altera.com)).
- Nota de aplicación "ssapexlvds" de línea APEX (Altera).
- Nota de aplicación "LVDS Owner manual de National" ([www.national.com](http://www.national.com)).
- Hojas de datos del DS90LV031A de National.
- Hojas de datos del DS90LV032A de National.
- Reportes tecnológicos de IBM ([www.ibm.com](http://www.ibm.com)).
- Notas de aplicación y hojas de datos sobre ECL ([www.onsemi.com](http://www.onsemi.com)).
- Nota de aplicación "AN1058" de Maxim ([www.maxim-ic.com](http://www.maxim-ic.com)).
- Nota de aplicación "Comparison of CML and LVDS for High-speed serial links" de Cypress ([www.cypress.com](http://www.cypress.com)).
- Nota de aplicación "Virtex-E LVPECL receivers in multi-drop applications" de Xilinx ([www.xilinx.com](http://www.xilinx.com)).
- Hojas de datos de FPGA serie Virtex-E de Xilinx.
- Hojas de datos de FPGA serie Stratix de Altera.
- Introducing Innovations at 28 nm to Move Beyond Moore's Law. White paper WP-01125-1.2. Intel 2012.
- Información sobre LVDS, CML, PECL: <http://www.ti.com/lit/ug/snla187/snla187.pdf>